Zeitschrift für angewandte Physik

INTER BAND

SEPTEMBER 1958

HEFT 9

Ein Paarspektrometer zur Messung eines 30 MeV-Bremsspektrums

Von Bernhard Ziegler

Mit 16 Textabbildungen

(Eingegangen am 6. Juni 1958)

A. Einleitung

Der zwischen 10 und 30 MeV besonders interessante auf des Wirkungsquerschnittes von Kernphototen wurde schon vielfach untersucht. Stets diente kontinuierliches Bremsspektrum mit variabler er Grenzenergie als Strahlenquelle. Dabei muß die Form des Bremsspektrums kennen, um die essenen Anregungsfunktionen in Wirkungsquerittskurven umrechnen zu können. Bremsspektren 2,7, 4,5 und 9,7 MeV Grenzenergie wurden von nud Starfelt [1] gemessen und publiziert. In vorliegenden Arbeit wird ergänzend die Form des nsspektrums bei 30 MeV Grenzenergie mit dicker ikathode bestimmt.

Zur Einführung sollen einige der in den letzten ren im Betatronenergiebereich (5 bis 50 MeV) beten γ -Spektrometer hinsichtlich Lichtstärke und rgieauflösungsvermögen miteinander verglichen den. Als Maß für die Lichtstärke wird die am Eing des Spektrometers für eine Zählrate von 1/Sekunbenötigte monochromatische Quantenstromdichte enommen. Als Maß für das Energieauflösungsmögen dient die relative Halbwertsbreite der 3kurve für monochromatische γ -Strahlung in zenten der γ -Strahlenenergie.

Bei allen Anordnungen werden die Versuchsbedingen so gewählt, daß die Quantenenergie in eintiger Weise in kinetische Energie geladener Teilnungewandelt und auf diesem Umwege gemessen d. Beugungsanordnungen wurden bisher wegen des sehr kleinen zulässigen Inzidenzwinkels und wegen mit wachsender Energie rasch abnehmenden flexionskoeffizienten bisher über 5 MeV nicht lisiert.

Als verwertbare Elementarprozesse mit dem größ-Wirkungsquerschnitt bieten sich Compton-Stoß d Elektronenpaarbildung an. Beim Comptoniekt muß man alle Elektronen, die nach dem Stoß einer bestimmten Richtung (gewöhnlich die Einsrichtung des Quants [2], [3], [4]) fliegen, ausnden und deren Energieverteilung messen. Will n den Paarbildungseffekt ausnutzen, so sucht man h durch Koinzidenzmessung im Magnetfeld [5] are mit einer bestimmten Summe von Elektrond Positronenergie aus und mißt deren Häufigkeitsteilung. In Abb. 1 sind zum Vergleich die in Frage mmenden Wirkungsquerschnitte dargestellt: das tegral über den differentiellen Compton-Streuquermitt von 0 bis 1° (ergibt bei 30 MeV etwa 2% Aufung) und den Wirkungsquerschnitt für die Paardung für einen Bereich des Aufteilungsverhältnisses ektronenenergie zu Positronenenergie von 0,98 bis 2 (entspricht ebenfalls 2% Auflösung).

Da beim Compton-Spektrometer die Paarelektronen, beim Paarspektrometer die Compton-Elektronen stören, benutzt man vorteilhaft beim Compton-Spektrometer eine Konverterfolie mit niedriger Ordnungszahl Z_1 (Be, Polistyrol), beim Paarspektrometer eine Folie mit hoher Ordnungszahl Z_2 (Pt, Pb). Man erkennt also zunächst in bezug auf den ausnutzbaren

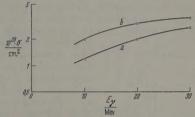


Abb. 1. Die bei 2% Auflösung ausnutzbaren Wirkungsquerschnitte, a) Compton-Effekt $\sigma_t = \frac{\sigma_c(2\%)}{Z}; \ b)$ Paarbildung $\sigma_2 = \frac{\sigma_p(2\%)}{Z^z}; \ (Z$ Ordnungszahl)

Wirkungsquerschnitt eine Überlegenheit des Paarspektrometers um den Faktor $\frac{\sigma_p(2\,\%)}{\sigma_c(2\,\%)}$. Da man jedoch wegen der Vielfachstreuung der Elektronen

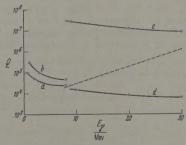


Abb. 2. Vergleich der für einen Registrierimpuls benötigten monochromatischen Anzahl von QuantenQ pro cm² am Ort der Konverterfolle bei verschiedenen Spektrometeranordungen. a [1]; b [2]; c [3]; d diese Arbeit. Die gestrichelte Gerade begrenzt etwa den Bereich der Compton-Spektrometer dieses Typs nach unten. Auflösung überall etwa 2%

(proportional Z^2) nicht in beiden Fällen mit der gleichen Atomzahl pro Quadratzentimeter der Konverterfolie rechnen darf, erhält man für vielfachstreutäquivalente Folien den Vergleichsfaktor $\frac{\sigma_p(2\,\%)}{\sigma_c(2\,\%)} \cdot \frac{Z_1^2}{Z_2^2} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \cdot Z_1$. Wegen der stets vorhandenen Beziehung zwischen Lichtstärke, Auflösung, zulässiger Größe und Dicke der Konverterfolie und der Wahl der β -Spektrometer-Geometrie kann man dieses Ergebnis nur als grobe Abschätzung werten. Für einige bekannte [2], [3], [4] Anordnungen wurde die Lichtstärke bei 2% Auflösung berechnet bzw. der Literatur entnommen

und in Abb. 2 zusammengestellt. Oberhalb 10 MeV ist selbst das einfachste Paarspektrometer mit nur einem Zählerpaar dem Compton-Spektrometer überlegen. Aus diesem Grunde wurde für die genaue Messung des Betatronbremsspektrums, besonders auch wegen der Möglichkeit von γ -Strahlen-Absorptionsmessungen das Paarspektrometerprinzip [5] gewählt. Die Auflösung soll etwa 2% betragen.

Die eingangs erwähnten Messungen von Starfelt und Koch [1] wurden mit dem Totalabsorptionsspektrometer von Foot und Koch [6] durchgeführt, das in bezug auf Lichtstärke einzigartige Vorteile besitzt. Der Auflösung sind aber oberhalb 10 MeV prinzipielle Grenzen bei etwa 10% gesetzt.

B. Grundlagen und Prinzip

1. Allgemeines

Den Ausgangspunkt für den Entwurf eines Paarspektrometers bilden die Theorie der Paarbildung am Felde eines Atomkerns [7], [8] und die Beschreibung der Bewegung relativistischer Elektronen im Magnetfeld. Beide Theorien sind so gut experimentell [9]

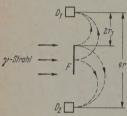


Abb. 3. Prinzipielle Anordnung; Magnetfeld senkrecht zur Bildebene; F. Konverterfolie; D., D. Detektoren in Koinzidenz; r Bahnradius bei symmetrischer Energieaufteilung; r, Bahnradius bei unsymmetrischer Energieaufteilung; Q Strahlenquelle

so gut experimentell [9] gesichert, daß man sie ohne Bedenken als Basis für eine Spektrometeranordnung mit einem Genauigkeitsanspruch von 1% verwenden kann. Spezielle Details, die bei den Korrekturen (D) eine Rolle spielen, wie die Energieaufteilung auf die Paarteilchen und deren Winkelverteilung, wurden experimentell bestimmt.

Die prinzipielle Anordnung (Abb. 3) des Spektrometers wurde zuerst

von Walker [5] angegeben. Aus allen an einer Konverterfolie F gebildeten Paaren werden nach 180° Ablenkung im Magnetfeld und einfacher Richtungs-

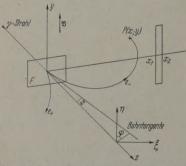


Abb. 4. Geometrie bei der Paarerzeugung. Der γ -Strahl trifft senkrecht auf die Konverterfolie F. Die Detektoren sind sehmale Spalte in der xy-Ebene längs y, zwischen x_1 und x_2

fokussierung nur die registriert, bei denen Energiesumme und -aufteilung auf Elektron und Positron zum Auftreffen auf beide Detektoren D führen. Variation des Magnetfeldes ergibt bei konstantem Abstand der Zähler die Energieverteilung dieser Paare als Abbild (im wesentlichen das Produkt aus Spektrum und Paarbildungsquerschnitt) des γ -Spektrums. Lichtstärke

und Auflösungsvermögen eines solchen Appara werden von mehreren Faktoren bestimmt, die einzelnen behandelt werden sollen.

2. Die zulässige Breite der Konverterfolie

Die Differenz der Gesamtenergie der beiden Abb. 3 gezeichneten Paare darf nicht größer sein es das gewünschte Auflösungsvermögen zuläßt:

$$\begin{split} \frac{E}{m_0\,c^2} &= \varepsilon = \sqrt{1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 - 1}\,;\\ 2\,\sqrt{1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 - \left(\sqrt{1 + \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^2 + \sqrt{1 + \left(\frac{2r - r_1}{r_0}\right)^2}\right)} \\ &= \frac{\varDelta E_\gamma}{m_0\,c^2} = \varDelta\,k\,;\\ r_0 &= \frac{m_0\,c}{e\cdot B}\,;\quad \frac{r_0}{\mathrm{cm}} = \frac{1.7}{B/\mathrm{kGauB}}\,. \end{split}$$

 r_0 wird zur Vereinfachung der Formeln als Maß das Magnetfeld eingeführt. Dabei ist E die kinetis Energie der Elektronen, bzw. Positronen; ε c gleichen, gemessen in Einheiten der Ruheenergie m_{ℓ} E_{γ} die Energie des γ -Quants; $k=\frac{E_{\gamma}}{m_0c^2}$; e die Imentarladung; B die magnetische Feldstärke, guter Näherung findet man

$$\Delta k = \left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \left(\frac{r_1}{r} - 1\right)^2.$$

Dies ist glücklicherweise keine enge Einschränk für die zulässige Breite der Folie und damit auch die des γ -Strahls.

3. Die Winkelverteilung der Paarteilchen und die Apparatefunktion des Paarspektrometers

Da die Elektronenpaare bei ihrer Erzeugung ni genau in γ -Strahlrichtung weiter fliegen, gibt es e prinzipielle Grenze für das Auflösungsvermögen. die Auftreffpunkte P(x,y) der Elektronen auf xy-Ebene, in der die Zähler liegen, findet man (si Abb. 4)

$$\begin{split} x &= 2r\cos\vartheta \approx 2r - r\cdot\vartheta^2; \\ y &= 2r\sin\vartheta\cos\varphi \cdot \text{arctg}\,(\text{tg}\,\vartheta\sin\varphi); \\ r &= \frac{m_0c}{B\cdot c}\,\sqrt{\left(\frac{E}{m_0\,c^2} + 1\right)^2 - 1} \approx r_0(\varepsilon + 1). \end{split}$$

Die Näherungen gelten für kleine Winkel ϑ v $E\gg m_0\,c^2$, was hier gut erfüllt ist. Die benutz Symbole sind in Abb. 4 erklärt. Wichtig ist, daß x-Koordinate des Auftreffpunktes P nur vom Wink des Teilchens gegen die γ -Strahlrichtung abhängt. Verteilung dieser Richtungen kann man gut an hern [10] durch

$$n(\vartheta)\,d\vartheta=rac{c_1\vartheta\,d\vartheta}{(artheta_0^2+artheta^2)^2}; \quad c_1=rac{2artheta_0^2}{1-rac{1}{1+\left(rac{\pi}{artheta_0}
ight)}}\,,$$
damit

 $\int\limits_{0}^{\pi}n\left(\vartheta\right)d\vartheta=1.$

en der Größe und der Messung von ϑ_0 s. Abschnitt Aus (5) erhält man mit (3a) und (4) die Verteiin x-Richtung:

$$\operatorname{re}, r_{0}, x) dx = \frac{c_{1} dx}{2r_{0}(\varepsilon + 1) \left(\vartheta_{0}^{2} + 2 - \frac{x}{r_{0}(\varepsilon + 1)}\right)^{2}} \begin{cases}
\operatorname{für} & \varepsilon \geq \frac{x}{2r_{0}} - 1;
\end{cases} (6)$$

$$n\left(\varepsilon;r_{0};x\right)dx=0\quad\text{für}\quad\varepsilon<\left(\frac{x}{2r_{0}}-1\right).\quad\left(6\,\text{a}\right)$$

selbe gilt für das Positron. Für die Wahrscheinkeit $n(k, r_0)$ des Nachweises von Elektron und itron, die aus einem Quant k gebildet werden mit i zwischen x_1 und x_2 liegenden, in y-Richtung egrenzten Zählern, erhält man damit:

$$n(k; r_0) = \int_{\varepsilon = \frac{x_1}{2r_0} - 1}^{\varepsilon - k - \left(\frac{x_1}{2r_0} - 1\right) - 2} n(\varepsilon; r_0) \cdot n(k - \varepsilon - 2; r_0) d\varepsilon.$$
 (7)

$$\begin{split} n\left(\varepsilon;r_{0}\right) &= \int\limits_{x_{1}}^{x_{2}} n\left(\varepsilon;x;r_{0}\right) d\,x \\ n\left(k-\varepsilon-2;r_{0}\right) &= \int\limits_{x_{1}}^{x_{2}} n\left(k-\varepsilon-2;x;r_{0}\right) d\,x \end{split}$$

leuten. Die Auswertung von (7) für festes k ergibt Apparatefunktion $n(k; r_0)$ für sehr hohe Zähler. gen der Unstetigkeit von (6a) muß das Integral in Teile zerlegt werden mit den Grenzen bei $\left(rac{x_1+x_2}{4r_0}-1
ight)$ t $\left(rac{x_1}{2r_0}-1
ight)$. Die Korrektur auf endliche Zähler-

Be folgt in Abschnitt D 2. Die Dicke der Konverterfolie ist durch die maximal ässige Vielfachstreuung begrenzt. Die Verteilungen Paarbildungs- und Vielfachstreuwinkel sehen verieden [7], [11] aus, ihre Energieabhängigkeit ist aber selbe. Eine Faltung beider Verteilungen zeigt, daß n den Einfluß der Vielfachstreuung in guter Näheig durch Annahme eines größeren ϑ_0 in (5) erfassen m. Zweckmäßigerweise wählt man die Foliendicke $\operatorname{daß} \overline{\sigma_{\mathrm{paar}}^2} \approx \overline{\sigma_{\mathrm{streu}}^2}$, was einen Kompromiß zwischen imaler Auflösung und guter Lichtstärke darstellt.

1. Die Anforderungen an die Koinzidenzapparatur

Da die γ-Energie nicht in einem festen Verhältnis Elektron und Positron verteilt ist, registriert jeder beiden Zähler viele Teilchen, zu denen kein Partner ört, der gleichzeitig den anderen Zähler trifft. Zur schätzung der Anforderungen an die Koinzidenzparatur soll das Verhältnis der Zahl der Einzelpulse n_i eines jeden Zählers zur Zahl der registrierten ten Koinzidenzen n_e und die zu erwartende Zahl zufälligen Koinzidenzen n_z berechnet werden. Dazu n man folgende vereinfachende Annahmen machen:

a) Die Häufigkeitsverteilung $\Phi(k)$ dk der Quanten d durch

$$egin{aligned} \varPhi(k)\,d\,k &= rac{\varPhi_0}{k}\,d\,k\,; & k \leq k_{
m grenz} \ \varPhi(k)\,d\,k &= 0\,; & k > k_{
m grenz} \ \end{aligned}$$

genähert.

b) Für den Verlauf des Paarbildungsquerschnittes σ_p ist im Energiebereich 5 bis 30 MeV

$$\sigma_p(E_{\gamma}) = c_2 \left(\ln \frac{E_{\gamma}}{\text{MeV}} - 0.9 \right) \tag{9}$$

eine gute Näherung [7].

c) Im gleichen Energiebereich ist jedes Energieaufteilungsverhältnis $\varkappa = \frac{\varepsilon}{k-2}$ zwischen 0 und 1 ungefähr gleich wahrscheinlich [7]:

$$w(\varkappa) d\varepsilon = \frac{d\varepsilon}{k}. \tag{10}$$

d) Als Apparatefunktion wird ein Rechteck angenommen, das zwischen $E = E_1$ und $E = E_2$ den Wert l besitzt und außerhalb dieses Intervalls verschwindet.

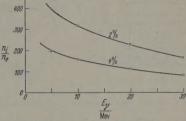


Abb. 5. Das Verhältnis von Einzelimpulszahl n_i zur Zahl der echten Koinzidenzen n_a als Funktion der am Spektrometer eingestellten Energie, berechnet für verschiedene Auflösung $\varDelta E/\overline{E}$ in %, für ein Bremsspektrum mit 32 MeV Grenzenergie

Mit diesen Annahmen erhält man für die Zahl der Elektronen n_i im Energieintervall $E_2 - E_1 = \Delta E$ bei der Elektronenenergie $\overline{E} = \frac{E_1 + E_2}{2}$ den Wert

$$\begin{split} n_i &= \int\limits_{E_2}^{E_1} dE \int\limits_{E}^{\text{Egrenz}} \varPhi(E_{\gamma}) \, \sigma_p(E_{\gamma}) \, w(\varkappa) \, dE_{\gamma} \\ &= c_2 \, \{ (\ln \overline{E} + 0.1) - 0.12 \, \overline{E} \} \, \frac{\varDelta E}{\overline{E}} \, . \end{split}$$

Dabei wird E_{ν} und E in MeV gemessen; $E_{\text{grenz}} = 32 \,\text{MeV}$;

 m_0c^2 ist gegen E_γ und E vernachlässigt. Integriert man über E von E_1 bis E_2 und bei symmetrischer Zählerstellung über E_γ von $2E_1$ bis $2E_2$, so erhält man die Zahl der echten Koinzidenzen:

$$n_e = \varPhi(\overline{E_\gamma}) \cdot \sigma_p(\overline{E_\gamma}) \cdot w(\overline{E_\gamma}) \cdot \frac{1}{2} (\Delta E)^2; \ \overline{E_\gamma} = 2 \cdot \overline{E}; \ (12)$$

das Verhältnis n_i/n_e wird

$$\frac{n_i}{n_e} = \frac{8 \left\{ (\ln \overline{E} + 0.1) - 0.12 \, \overline{E} \right\}}{\ln \overline{E} - 0.2} \cdot \left(\frac{\overline{E}}{\Delta E} \right), \tag{13}$$

dargestellt in Abb. 5, für eine Grenzenergie von 32 MeV. Die Vereinfachungen [besonders a) und c)] machen die Kurven am oberen Ende ungenau, doch sind sie - wie das Experiment zeigt - zur Berechnung der zufälligen Koinzidenzen gut geeignet.

Allgemein erhält man die Zahl der zufälligen Koinzidenzen n, pro Sekunde aus dem zeitlichen Auflösungsvermögen der Koinzidenzschaltung τ (sec) und den Zählgeschwindigkeiten $n_1(\sec^{-1})$ und $n_2(\sec^{-1})$ der beiden Zähler

$$n_z = 2 \tau \, n_1 \cdot n_2 ({\rm sec}^{-1})$$
 . (14)

Setzt man hierin $n_1 = n_2 = n_i$ und benutzt n_i/n_e aus (13), so erhält man

$$n_e = \frac{\alpha}{2\tau} \cdot \left(\frac{n_z}{n_e}\right) \cdot \left(\frac{n_i}{n_e}\right)^{-2} (\sec^{-1}). \tag{15}$$

Der Faktor α wurde in (15) ergänzt. Durch ihn wird die Reduktion der Zählgeschwindigkeit wegen der intermittierenden Betatronstrahlung berücksichtigt: $\alpha = \frac{t_{\gamma}/\mu s}{2 \cdot 10^4} \approx 10^{-3}$; t_{γ} ist die Dauer eines γ -Blitzes.

bei verschiedenen Magnetfeldstärken wurde eine H. Sonde² geeicht. Die beiden Polschuhe bilden Tvon Boden und Deckel einer quadratischen, geschweten Vakuumkammer aus V2A-Stahl³. Sie sind großen Simmerringen⁴ drehbar gegen die Kamnabgedichtet.

Die Konverterfolie ($10\,\mu$ Pt) steht etwa in Mitte des Magnetfeldes. Abb. 7 zeigt einen war rechten Schnitt durch Betatron und Magneten Strahlengang. Am Ort der Folie F besitzt der a

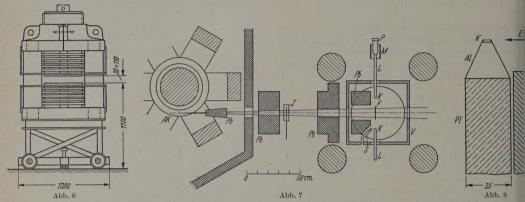


Abb. 6. Elektromagnet mit verstellbarem Polschuhabstand. Erregung mittels elektronisch geregelter 3 Phasen-Thyratrongleichrichtung, max. 5 Luftkühlung

Abb. 7 Waagerechter Schnitt durch das Paarspektrometer. A.K. Antikathode des Betatrons; Pb Bleiblenden; V Vakuumkammer; F Konverterf K Kristalle mit L Lichtleiter und P Photozelle F 8 9A; M magnetische Absehrmung; I Ionisationskammer zur Dosierung; S Sonde zur Magnetieldmes Abb. 8. Der Kristall K, $1,5 \times 3 \times 60$ mm, wird von Al-Folie Al 25 mm vor dem Plexiglashchleiter Pl gehalten, dessen vorderer Querschnitt von 25×70 sich zur Photozelle hin auf 23 mm Φ verjüngt. Bleiabschirmung Pb verhündert Çerencow-Strahlung im Plexiglas; El. Elektronenrichtung

Bei 32 MeV Grenzenergie, Einstellung des Spektrometers auf 10 MeV und $\tau=5\cdot 10^{-9}$ see muß man $n_z=n_e$ zulassen, um auf eine Zählgeschwindigkeit von 5 pro Sekunde zu kommen. Eine Bestimmung von n_z ist demnach prinzipiell nicht zu umgehen. Dies ist das wichtige Ergebnis dieser Abschätzung.

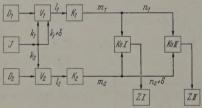


Abb. 9. Blockschaltbild der benutzten Anordnung. Die Signale der beiden Detektoren $D_{1,2}$ werden in den Vorverstärkern $V_{1,2}$ und den Kettenverstärkern $K_{1,2}$ (Anstiegszeit $4\cdot 10^{-9}$ sec; Verstärkung 50fach) geformt und verstärkt ("Rechteck" mit $7\cdot 10^{-9}$ sec Dauer) und den Konzidenzstufen KoI, II zugeführt. Die Prüfimpulse des Impulsgenerators I (Hg-Relais) durchlaufen die gleichen Wege. Die mit k, h, m, no bezeichneten Verbindungen sind Koaxialkabel bestimmter Laufzeit. Es gilt: $k_1 = k_2$; $k_1 = k_3$; $k_1 = k_3$. So der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift ($n_2 + n_d$), II $n_2 = n_2$; $\delta = 10^{-8}$ sec, verschieden wählbar, II registriert ($n_2 + n_d$), II n_2 . Die in II und II enthaltenen Impulshöhendiskriminatoren werden durch Einstellen auf die Prüfimpuls-"Könzidenzen" so justert, daß n_1 gleich n_2 wird. Nicht eingezeichnete Torschaltungen verhindern die Zählung von Injektionsstörungen und Prüfimpuls-"Ginpulsen

C. Experimentelle Anordnung

Das Magnetfeld wurde durch einen Elektromagneten¹ mit 50 cm Polschuhdurchmesser und 9 cm Polschuhabstand erzeugt (s. Abb. 6). Die maximale Feldstärke beträgt bei diesem Abstand 8 kGauß. Durch Aufsuchen der Protonenresonanzfrequenz [12] geblendete Strahl 1×4 cm² Querschnitt. Die orge schen Kristalle 5 mit ihren Fassungen sind in Abl gezeichnet. Ihre Schmalseite definiert den Eintrispalt des Detektors. Im Elektronen- und Positron strahlengang wurden keine Aperturblenden benut

Wegen der oben abgeleiteten Forderung messung der zufälligen Koinzidenzen n_z wurden z Koinzidenzstufen so parallel geschaltet, daß die et $(n_e + n_z)$, die andere n_z simultan mißt. Die notwend Voraussetzung genau gleicher Koinzidenztrennzei wurde mit einem in den Betatronstrahlpausen 50 Hz eingekoppelten Prüfimpuls während der Msung überprüft und, wenn nötig, korrigiert. Das gehörige Blockschaltbild zeigt Abb. 9. Durch wiet holte Kontrollmessungen (Variation von γ -Strahl intensität und Verzögerungskabel δ) wurde das zuv lässige Funktionieren der Schaltung sichergestellt

Die in Abb. 7 eingezeichnete Durchstrahlur ionisationskammer dient in Verbindung mit ein Elektrometerverstärker⁶ und Schreiber als Meßge für die γ -Strahlendosis. Die am Auffänger gesamm Ladung wurde vom Ausgang des Schreibers⁷ kompensiert. So blieb der Auffänger auf Erdpotent Es konnte keine Störung der Anzeige durch die Strahlung beobachtet werden, die das lange Verldungskabel zwischen Kammer und Elektrometer tr

³ Hersteller: C. Canzler, Düren.

⁵ Hersteller: National Radiac, USA

7 "Enograph" von Rhode und Schwarz.

¹ Hersteller: BBC Mannheim.

² Hersteller: Siemens Schuckert, München.

⁴ Wir danken der Firma C. Freudenberg, Weinheim, die kostenlose Überlassung der Ringe.

⁶ Als Elektrometerröhre bewährte sich eine Type 959 Steuerung am Bremsgitter.

D. Korrekturen

1. Totzeit

Die Trennzeit der verwendeten Untersetzer [14] (10⁻⁷ sec) ist so klein, daß sich selbst bei den größten binzidenzzählgeschwindigkeiten eine Korrektur erfrigte.

2. Endliche Zählerhöhe

Das Anwachsen von ϑ_0 mit abnehmender Energie $\mathfrak{d}\mathfrak{d}$ t immer mehr Teilchen in y-Richtung (s. Abb. 4) an da Zählern vorbeifliegen. Wegen der relativ langsnen Änderung von ϑ_0 kann man die endliche Zählerhen ach den Integrationen (7) als Korrekturfaktor k_1 hücksichtigen. Die Unsicherheit in der theoretischen Enntnis von ϑ_0 in (5) macht eine experimentelle Besmung von k_1 erforderlich. Die Verteilung (5) der Fchtungen der Bahntangenten beim Austritt aus der Flie kann man durch die Verteilung der Durchstoßpakte auf der Hilfsebene (ξ,η) im Abstand 1 von der Folie ersetzen: $n(\xi,\eta)$ $d\xi$ $d\eta$. Durch Integration der ξ erhält man $n(\eta)$ $d\eta$, was bis auf einen konstanta Faktor die Verteilung n(y) dy der Auftreffpunkte Elektronen auf die Zählerebene wiedergibt:

$$(\theta) d\theta = \frac{c_1 \theta d\theta}{(\theta_0^2 + \theta^2)^2} = \frac{c_1 d\xi d\eta}{2\pi (\theta_0^2 + \xi^2 + \eta^2)^2}; (\eta) d\eta = \frac{c_1}{2\pi} \int_{-\xi = 0}^{\infty} \frac{d\eta d\xi}{(\theta_0^2 + \xi^2 + \eta^2)^2} = \frac{c_1 d\eta}{8(\theta_0^2 + \eta^2)^{\frac{3}{2}}}.$$
 (16)

my) dy wurde durch Einsetzen von Bleiblenden in vschiedener Höhe y vor einen Zähler gemessen. Die unden (kleinen) Einfluß von γ -Strahlen-Fleck-Höhe (em) und Blendenöffnung (0,5 cm) korrigierten Meßkrven sind in Abb. 10a-c für drei verschiedene Ektronenenergien dargestellt. Durch Messen der Tilchen einer Energie in verschiedenen Abständen x und damit verschiedener Höhe y auf dem Detektor wrde die Ansprechwahrscheinlichkeit f(y) der Zähler betimmt, s. Abb. 10d. Hieraus wurde k_1 berechnet:

$$k_{1} = \frac{\int_{0}^{\infty} n(y) \cdot f(y) \, dy}{\int_{0}^{\infty} n(y) \, dy}.$$
 (17)

Libei wurde die Meßkurve n(y) dy durch eine Kurve de Form (16) angenähert, was bei allen Energien durch Vahl eines passenden Winkels ϑ_0 sehr gut zu erreichen vr. Das Ergebnis zeigt Abb. 11. Die Anwendung der giehen Korrektur auf den anderen Zähler setzt voras, daß die Verteilungen der beiden Teilchen völlig uabhängig voneinander sind. Dies ist streng nicht rhtig [5], [7], wegen des vom Kern aufgenommenen Lipulses und wegen der Vielfachstreuung in der Folie aer, wie eine Abschätzung zeigt, zur Bestimmung deser Korrektur ausreichend gut erfüllt.

3. Apparatefunktion, Auflösung

Die nach (7) mit dem empirisch aus $n(y)\,d\,y$ erttelten $\vartheta_0(E_\gamma)$ für die beschriebene Anordnung berhneten Apparatefunktionen sind für verschiedene bergien in Abb. 12 dargestellt. Eine direkte experientelle Prüfung dieser Kurven war nicht möglich, wil keine monochromatische γ -Strahlenquelle ausrehender Intensität zur Verfügung stand.

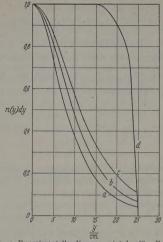


Abb. 10. a-c Experimentelle Kurven n(y) dy für E=27.4 MeV (a); 23,1 MeV (b); 18,8 MeV (c) bei $x_1=11$ cm. d Ausprechwahrscheinlichkeit der Zähler f(y)

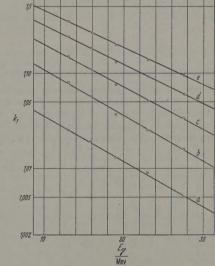


Abb. 11. a-d $k_1(E_\gamma)$ für 4r=10 cm (a); 15 cm (b); 20 cm (d); 30 cm (e). r wie in Abb. 3 definiert

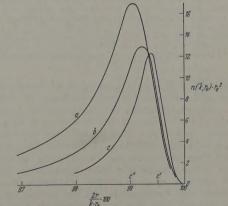


Abb. 12. Berechnete Apparatefunktionen für $x_i = 150 \text{ mm}; x_z = 151,5 \text{ mm}; E = 11 \text{ MeV } (a); 21 \text{ MeV } (b); 31 \text{ MeV } (c). Die Größen <math>k, r_o$ sind in (4) definiert. Wegen der unstetigen Funktion $n(\varepsilon; r_s; x)$, siehe (6), wurde die Integration (7) bei e' und e' in 3 Teile zerlegt

4. Energieaufteilung

Heitler [7] berechnete die Zahl der Paare $n(\varkappa)$ $d\varkappa$ als Funktion der Energieaufteilung $\varkappa=\frac{\varepsilon}{k-2}$. Mit dem Paarspektrometer mißt man die Paare im Intervall $\frac{x_1}{x_1+x_2} \le \varkappa \le \frac{x_2}{x_1+x_2}$. $x_{1,2}$ sind die Detektorgrenzen. Das Verhältnis

$$k_{2} = \frac{\int_{x_{1}/x_{1}+x_{2}}^{x_{2}/x_{1}+x_{2}} \int_{0}^{x_{1}/x_{1}+x_{2}} dx}{\int_{0}^{1} n(x) dx}$$
(18)

hängt schwach von der Energie ab. $n(\varkappa)\,d\varkappa$ wurde empirisch bestimmt¹. Der so erhaltene Faktor k_2 ist in Abb. 13 eingezeichnet.

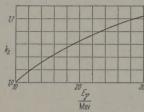


Abb. 13. $k_2(E_\gamma)$, Korrekturfaktor

E. Messung des Bremsspektrums und Auswertung

Es wurde die im evakuierten Ringrohr eingebaute Antikathode benutzt. Ihre Flächendichte in Elektronenstrahlrichtung beträgt 3,5 g/cm² Pt-Ir. Die Strahlung wurde in Richtung der auftreffenden Elektronen beobachtet. Die Grenzenergie war auf 95%

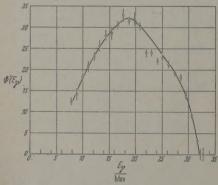


Abb. 14. Unkorrigierte Meßkurve. Die eingezeichneten Fehler sind die mittleren statistischen Fehler

der mit diesem Betatrontyp erreichbaren Energie eingestellt und durch eine Integratorschaltung [15] stabilisiert. Die verbleibenden Schwankungen der Grenzenergie (±0,3% während der Meßzeit von einigen Stunden) tragen zur Unsicherheit der Meßkurve weniger bei als die statistischen Fehler der Zählungen.

Der Expansionsstrom zur Vergrößerung des Sollkreises, normalerweise eine halbe Sinuswelle, erhielt durch Einfügen eines passenden *LC*-Gliedes in die Schaltung eine Komponente mit der dritten Oberwelle, wodurch man eine mehr rechteckige Kurvenform und eine Verlängerung des γ -Blitzes (80 μ s gerüber 20 μ s) erhält. Damit wurde nach (15) die 4 der zufälligen Koinzidenzen reduziert. Das Verhäl n_e/n_z lag zwischen 1 und 3.

Aus der gemessenen Kurve $\Phi'(E_{\gamma})$, s. Abb. wurde unter Berücksichtigung der Apparatefunk $n(E_{\gamma}, r_0)$ (Abb. 12) und der übrigen Korrekturen Bremsspektrum $\Phi(E_{\gamma})$ durch numerische und grasche Integration bestimmt (s. Abb. 15):

$$k_1 \cdot k_2 \cdot \varPhi' \big(E_{\gamma}(r_{\mathbf{0}}) \big) = \int\limits_{0}^{\infty} \sigma_{p}(E_{\gamma}) \, \varPhi \left(E_{\gamma} \right) n \left(E_{\gamma}; r_{\mathbf{0}} \right) dE_{\gamma}.$$

 σ_p wurde den besten bekannten Tabellen [9] ent
n men.

F. Diskussion

Sommerfeld [16] berechnete für den nie relativistischen Fall den Wirkungsquerschnitt Bremsstrahlungserzeugung exakt in differentie

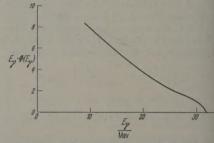


Abb. 15. Bremsspektrum $E_{\gamma} \cdot \Phi(E_{\gamma})$; berechnet nach (19) mit der Meßk Abb. 14

Form. Wiedemann und Kirkpatrick [17] integten über den Elektronenwinkel und erhielten $d^2\sigma/d\Omega$ Bei größeren Energien $E_{\rm el}\approx m_0c^2$ oder größer als n müssen die vollständigen Diracschen Wellenfunktio benutzt werden. Außerdem wird die Abschirmung Kernfeldes durch die Hüllenelektronen mit wachsen Energie und Z immer mehr bemerkbar. Im Rahr der Bornschen Näherung findet Sauter [18] Eösung für Energie- und Winkelverteilungen, jed ohne Abschirmung. Glückstern und Hull [geben dazu eine grobe Abschätzung für kleine Schiff [20] integrierte den differentiellen Bet Heitler-Wirkungsquerschnitt über die Winkel wegfliegenden Elektrons und berücksichtigt die

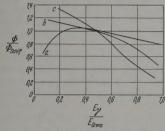
schirmung durch ein Potential $\frac{Z \cdot e}{r} \cdot e^{-\frac{r}{a}}$. Bethe Maximon [8] errechneten ohne Bornsche Näher Wirkungsquerschnitte für extrem relativistische Ergien. Olsen [21] bemerkt hierzu, daß die Berücksitigung der Abschirmung an der Form des Spektrunichts Wesentliches ändert. Dies alles gilt für Elementarvorgang der Bremsstrahlungserzeugungson nur für sehr dünne Antikathoden.

Bei dickeren Antikathoden stört zunächst Vielfachstreuung der Elektronen im Antikathod material die ursprüngliche Winkelverteilung γ -Strahlen. Ein Maß für den Einfluß der Vielfastreuung gibt der Vergleich von $\frac{m_0 c^2}{E}$ mit dem m

leren Vielfachstreuwinkel $\chi_c \cdot \sqrt{B}$ nach Moliere [I Für eine Platin-Antikathode wird bereits bei ei Dicke von einigen μ $\chi_c \cdot \sqrt{B}$ annähernd gleich $\overline{}$

¹ Die Ergebnisse werden zusammen mit Winkelverteilungsmessungen publiziert werden.

Figur [22] kombinierte das Schiffsche Spektrum mit ir Näherung der Moliereschen Vielfachstreutheorie. Die dabei auftretende Parameter $\lambda = \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^{-2} \cdot \sqrt{B}$ besitzt für die bei dieser Arbeit benutzte Aikathode etwa den Wert 1/500. Dies bedeutet, daß is Winkelverteilung der Röntgenbremsstrahlung ihrwiegend durch die Vielfachstreuung der Elektrose in der Antikathode bestimmt ist. Eine Winkelsteilungsmessung der Röntgenstrahlenintensität ergo den Halbwertswinkel zu 6,5° in Übereinstimmung diesen Überlegungen. Die von Sirlin berechneten



b. 16. Vergleich von Bremsspektren mit der Schiffschen [20] Theorie:
 b Messungen von STARFELT und KOCH [1] bei 4,5 und 9,66 MeV und 5,8 g/cm² Antikathode; c diese Arbeit, 32 MeV und 3,6 g/cm²

ektren unterscheiden sich nur wenig vom Schiffektrum, integriert über alle Winkel der emittierten uanten. HISDAL [23] erhält durch numerische Inteation Korrekturfaktoren zu diesem integrierten hiff-Spektrum. Dabei wird die Vielfachstreuung für rschieden dicke Platinantikathoden berücksichtigt.

Ein weiterer Einfluß auf die Form des erzeugten remsspektrums resultiert bei der hier verwendeten eken Antikathode aus den Energieverlusten der lektronen durch Ionisation und Anregung und durch rzeugung von Bremsstrahlung im Antikathoden-aterial. Eine näherungsweise Berechnung hierzu ammt von Wilson [24]. Er kommt zu dem Erebnis, daß man zur Berücksichtigung dieser Energieerluste das Spektrum $\Phi(E,E_{
m grenz})$ gut durch ein $(E,E_{
m grenz}-ec{arDelta})$ annähern kann. Dabei ist arDelta die älfte des Energieverlustes der Elektronen beim urchgang durch die Antikathode, in unserem Falle 2,5 MeV. Dieses summarische Verfahren ist aber nur ann annähernd richtig, wenn man die gesamte nittierte Strahlung betrachtet und nicht, wie beim orliegenden Versuch, nur die Intensität in einem einen Winkelbereich ($\pm\,0.7^\circ$) in Primärrichtung der lektronen.

Da demnach noch keine exakte Berechnung des remsspektrums für den vorliegenden Fall vorhanden t, schließen wir uns dem Vorgang von STARFELT und OCH [1] an und vergleichen das gemessene Spektrum mit der Schiffschen [20] Kurve für den Emissionswinkel 0°. In Abb. 16 ist das Verhältnis der Meßkurve zum Schiffschen Spektrum dargestellt, zusammen mit den Ergebnissen von Koch [1] bei 4,5 und 9,7 MeV. Wie zu erwarten war, werden die bei kleineren Energien vorhandenen Abweichungen wegen der zunehmenden Energieverluste und der Absorption der γ-Strahlen in der Antikathode stärker ausgeprägt. Dies ist bei der eingangs erwähnten Auswertung von (γ, n) -Anregungstunktionen — besonders oberhalb der Riesenresonanz — zu beachten.

Zusammenfassung

Mit einem magnetischen Paarspektrometer guter Lichtstärke und etwa 2% Auflösung wird ein Betatronbremsspektrum aus einer dicken Antikathode gemessen. Das Ergebnis wird mit der Form des Bremsspektrums nach Schiff verglichen.

In Dankbarkeit gedenke ich meines hochverehrten Lehrers, Professor Dr. Chr. Gerthsen, der leider den Abschluß dieser Arbeit nicht mehr erleben konnte.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Firma Brown Boveri u. Co danke ich für materielle Unterstützung.

Literatur: [1] Koch, H. W., and N. Starfelt: Phys. Rev. 102, 1598 (1956). — [2] Motz, J. W., W. Miller and H. O. Wyckoff: Phys. Rev. 89, 968 (1952). — [3] Groshey, L. V. e. a.: Proc. intern. conf. atomic energy, Genf 2, 39 (1955). — [4] Ulmer, K., u. B. Ziegler: Z. angew. Phys. 8, 49 (1956). — [5] Walker, R. L., and B. D. McDaniel: Phys. Rev. 74, 315 (1948). — Kinsey, B. B., and G. A. Bartholomew: Canad. J. Phys. 31, 537 (1953). — [6] Foote, R. S., and H. W. Koch: Rev. Sci. Instrum. 25, 746 (1954). — [7] Heitler, W.: The Quantum Theory of Radiation. Oxford 1954. — [8] Bether, H. A., and L. C. Maximon: Phys. Rev. 93, 768 (1954). — Davies, H., H. A. Bethe and L. C. Maximon: Phys. Rev. 93, 788 (1954). — [9] Davisson, Ch. M.: Interaction of γ-Radiation with Matter in "Beta- and Gamma-Ray Spektroscopy herausgeg. von K. Siegbahn. Amsterdam 1955. — [10] Heitler, W.: Proc. Roy. Soc. Lond., Ser. A 146, 83 (1934). — [11] Mollerge, G.: Z. Naturforsch. 2a, 133 (19447); 3a, 78 (1948). — [12] Knoebel, H. W., and E. L. Hahn: Rev. Sci. Instrum. 20, 942 (1950). — [15] Katz, L. e. a.: Canad. J. Res. A 28, 113 (1949). — [16] Sommerfeld, A.: Ann. Phys. 11, 257 (1931). — Atombau und Spektrallinien. Braunschweig 1951. — [17] Kirkpatrick, P., and L. Wieder Phys. 20, 404 (1934). — [19] Gluckstern, R. L., and M. H. Hull: Phys. Rev. 90, 1030 (1953). — [20] Schiff, L. I.: Phys. Rev. 83, 252 (1951). — [21] Olsen, H.: Phys. Rev. 99, 1335 (1955). — [22] Sirlin, A.: Phys. Rev. 106, 637 (1957). — [24] Wilson, R.: Proc. Phys. Soc. Lond. 4 66, 638 (1953). — [23] Hisdal, E.: Phys. Rev. 105, 1821 (1956).

Dr. Bernhard Ziegler, Physikalisches Institut der Technischen Hochschule Karlsruhe

Röntgen-Interferenz-Messungen mit Proportional-Zählrohr und Einkanal-Diskriminator

Von Apolf Trost

Mit 8 Textabbildungen

(Eingegangen am 10. Mai 1958)

Aufbauend auf Entwicklungen, die bis 1940 zurückreichen [1], wurden sowohl in Deutschland [2] wie auch in den USA [3] Einrichtungen für Interferenzmessungen mit Geiger-Zählrohren beschrieben, die eine große Verbreitung gefunden haben. Die normalen, im Auslösebereich betriebenen Zählrohre sind allerdings wegen ihres begrenzten Auflösevermögens von etwa 10⁻⁴ sec nur zum Ausmessen schwacher oder mittelstarker Linien geeignet; deshalb wurde vom Verfasser eine spezielle Betriebsweise entwickelt [4],

die auch mit Geiger-Zählern bis über 10^5 Stöße/sec aufzulösen ge-

stattet.

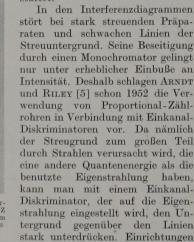




Abb. 1. Das Proportional - Zählrohr IZ 10/P mit seitlichem Fenster 3×25 mm

dieser Art wurden in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen, vor allem in den Philips Laboratories und im Labor Prof. Berthold in Wildbad, entwickelt. Parrish und Kohler [6] sowie Dowling, Hendee, Kohler und Parrish [7] haben ausführlich über Einkanalmessungen an Röntgeninterferenz-Linien berichtet, die mit dem "Norelco"-Gerät der Philips Laboratories und mit Proportionalzählern sowie Szintillometern ausgeführt wurden. Die beiden Meßorgane unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ansprechempfindlichkeit und ihres Energieauflösungsvermö-Die Empfindlichkeit des Szintillometers ist. besonders im kurzwelligen Gebiet, z.B. für MoK-Strahlung, größer als die des Proportionalzählers, dagegen ist seine Energieauflösung schlechter. Trägt man die Häufigkeit der Impulse, die für eine bestimmte Wellenlänge erhalten werden, in Abhängigkeit von ihrer Größe auf, so erhält man eine Kurve mit einer endlichen Halbwertbreite. Das Verhältnis dieser Halbwertbreite (HWB) zur mittleren Impulsgröße ist ein Maß für die Energieauflösung des Systems. Parrish und Kohler geben für Cu K-Strahlung eine HWB von 20% für den Proportionalzähler und von 50% für das Szintillometer an. Sie messen ferner für ein bestimmtes Pulverpräparat (Silikon) das Verhältnis Linie zu Untergrund bei einer Kanalbreite, welche die an zeigte Linienintensität um 10 % reduziert, und wäh als willkürliches Maß für die Güte des Meßorgans or Produkt aus Empfindlichkeit und dem Verhält Linie zu Untergrund. Bei dieser sehr subjektiven I wertung erhalten sie nicht nur für MoK-Strahlunsondern auch für CuK-Strahlung höhere "Gütaktoren" für das Szintillometer als für den Propetionalzähler.

Einen Vergleich zwischen Szintillometer un Geiger-Zähler führten Möller und Brasse [8] durc Leider ziehen sie zum Vergleich ganz ungeeigne Geiger-Zähler heran: sie geben als Empfindlichkeit verhältnis zwischen Zählrohr und Szintillometer swohl für Mo K- als auch für Co K-Strahlung das Vehältnis 1:10 an, obwohl schon die 1941 von Lindmann und Trost beschriebenen Zählrohre eine Abslutempfindlichkeit für Co K-Strahlung von 50 hatten! Außerdem wird als wesentlicher Nachteil dZählrohres das schlechte Auflösungsvermögen vil 10⁻⁴ sec angeführt, obwohl bekannt ist, daß sich au mit Geiger-Zählern ein mindestens 10mal höheres Aulösungsvermögen erreichen läßt.

Bei eigenen Untersuchungen mit Proportion zählern und Einkanal-Diskriminatoren des Labor. Pr Berthold ergab sich eine wesentlich bessere Energ auflösung und eine etwas größere Empfindlichkeit bei Parrish u. Mitarb. Damit würden sich z. B. l Cu K-Strahlung höhere "Gütefaktoren" für den Pr portionalzähler als für das Szintillometer errechne wenn man diesen willkürlichen Maßstab beibehalt wollte. Über diese Untersuchungen sei im folgend berichtet.

Das Proportional-Zählrohr

Abb. 1 zeigt das benutzte Zählrohr. Die Strahlu tritt durch das seitlich angebrachte Fenster $(3 \times 25 \,\mathrm{m})$ ein, das mit 10 µ dicker Glimmerfolie abgedeckt i die innen einen leitenden Überzug trägt. Der Inne durchmesser des Rohres (Strahlungsweg) beträ 24 mm, der Drahtdurchmesser 0,2 mm auf einer Län von 55 mm. Um möglichst homogene Feldverhältnis im Mittelteil des Drahtes zu erhalten, läuft der Dra in verdickten Enden aus. Als Kathodenmaterial wur Aluminium gewählt, damit der nichtabsorbie Strahlenanteil an der dem Fenster gegenüberliegend Kathodenwand keine störende Eigenstrahlung at lösen kann. Der Draht ist nicht genau in der Zä rohrachse, sondern um 1 mm seitlich versetzt gefüh damit er nicht vom einfallenden Strahl getroffen u dadurch, insbesondere bei kleiner Spaltbreite, Feh bei Intensitätsmessungen verursacht werden könne Als Zählrohrfüllung wurde für Cr-, Co-, Fe- u $Cu K_{\alpha}$ -Strahlung 300 mm Xenon und 12 mm Methy gewählt. Aus den von Taylor und Parrish [9] a gegebenen Kurven für den Massenabsorptionskoef zienten ergibt sich für $\operatorname{Cu} K_{\alpha}$ -Strahlung eine Absor tion im Füllgas von 78% der durch das Fenster e etenen Quanten. Da die Absorption im Fenster b beträgt, werden 70% aller auffallenden Quanten Zählung ausgenutzt.

Verstärker und Diskriminator

Will man mit dem Proportionalzähler eine eindfreie Proportionalverstärkung der Impulse ersten, so muß man genügend weit unterhalb der satzspannung des Geiger-Bereiches arbeiten. Im ger-Bereich werden alle Impulse unabhängig von Energie der auslösenden Röntgenquanten auf che Größe verstärkt, der Verstärkungsfaktor ist umgekehrt proportional zur Quantenenergie. Im portionalbereich dagegen ist die Impulsgröße protional zur Quantenenergie, der Verstärkungsfaktor abgesehen von kleinen statistischen Schwankungen, stant. Im Übergangsbereich ist der Verstärkungsfor auch bei Quanten gleicher Energie nicht einlich, seine statistische Schwankung ist groß; der grangsbereich eignet sich somit nicht für Impulsenmessungen.

Eine Abgrenzung der Bereiche ergibt sich, wenn Zählrohrstrom bei einer bestimmten Einstrahlung rithmisch in Abhängigkeit von der Spannung getragen wird. Abb. 2 zeigt eine solche Zählrohrrakteristik, aufgenommen bei 1000 Imp/sec. Im portionalbereich erhält man im logarithmischen Bstab einen linearen Anstieg mit der Spannung, Übergangsbereich nimmt die Steigung zu und im entlichen Geiger-Bereich wird sie wieder kontinuich kleiner (im normalen Maßstab lineare Zunahme steigender Spannung). Bei dem benutzten Protional-Zählrohr reicht der Proportionalbereich bis ta 2200 V, der Strom, bzw. die Împulsgröße, nimmt Volt um 0,9% zu. Der Übergangsbereich ist wegen hohen Xenondruckes sehr breit; auch bei 2400 V der eigentliche Geiger-Bereich noch nicht erreicht. Will man Impulsgrößenmessungen auch bei sehr den sekundlichen Stoßzahlen durchführen, so ist Einfluß der positiven Raumladung um den Zählht als Folge der Entladungen zu beachten. Sie zt die Feldstärke am Zähldraht herab und vermint dadurch die Impulsgröße, d.h. bei steigender Bzahl wird die Impulsgröße kleiner. Da die Stärke Raumladung mit der Zählrohrspannung steigt, pfiehlt es sich, bei möglichst kleiner Spannung zu eiten. Kleinere Spannung erfordert aber größere rstärkung, deren Begrenzung im Verstärkerrauschen t, das genügend klein gegenüber der Impulsgröße iben muß. Um den Rauschpegel klein zu halten, d nur ein enges Frequenzband verstärkt; die Zeitstante des RC-Gliedes für den Impulsanstieg begt 0,3 µsec, die für den Abfall 0,7 µsec. Da ferner Stoßgröße am Zähldraht umgekehrt proportional Kapazität des Systems ist, wurde das Zählrohr mittelbar in einen am Goniometerarm sitzenden thodenfolger eingesteckt, dessen Kathode mit der schirmung des Zähldrahtsystems verbunden wird, die wirksame Kapazität klein zu halten.

Zur Vereinfachung der Bedienung des Gerätes und mit jeweils die eingestellte Zählrohrspannung nach igen Gesichtspunkten optimal ist, wird mit konstan-Verstärkung und Ansprechschwelle gearbeitet. Die sprechschwelle des Diskriminators beträgt etwa V und liegt so hoch, daß Änderungen der Röhrendaten keinen merklichen Einfluß auf ihre Größe haben können. Die maximalen Rauschamplituden am Diskriminatoreingang betragen etwa ± 2 V, die mittleren ± 0.7 V. Die Eingangsempfindlichkeit des stark gegengekoppelten und übersteuerungssicheren Proportionalverstärkers liegt bei I mV. Damit ergab sich für Cu K_{α} -Strahlung beim Zählrohr IZ/10 P eine Ansprechspannung von 1900 V.

Die Löschschwelle ist zwischen etwa 40 und 65 V einstellbar, entsprechend einer Kanalbreite von 0 bis 50%, bezogen auf die mittlere Impulsgröße. Die Impulsgröße wird mit der Zählrohrspannung eingestellt: Man wählt zunächst die gewünschte Kanalbreite vor und bestimmt den Bereich, in dem die Anzeige annähernd unabhängig von der Zählrohrspannung ist, d.h. man bestimmt die obere und untere Spannungsgrenze, bei der die Anzeige merklich abfällt. Als

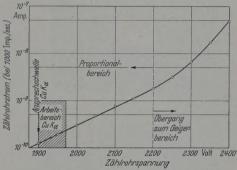


Abb. 2. Strom-Spannungs-Kurve des Zählrohres IZ/10 P

Arbeitsspannung nimmt man den Mittelwert aus diesen beiden Spannungen. Da die Impulsgröße pro Volt um 0,9% zunimmt, ist eine sehr gut stabilisierte Hochspannung erforderlich. Sie ist beim Gerät IDS/A bei 2000 V und bei Netzspannungen zwischen 190 und 240 V auf ± 1 V konstant. Die Dauerstabilität entspricht den Eigenschaften der Präzisionsröhre 85A2.

Die Impulsbreite am Ausgang des Proportionalverstärkers beträgt etwa 1,5 µsec, die Auflösezeit für Impulszählung 2,5 usec und für die Löschung 5 usec. Die nicht gelöschten Impulse werden in bekannter Weise [4] auf das Gitter eines Stromtores gegeben. Durch jeden Impuls wird ein zwischen Anode und Kathode des Stromtores liegender Kondensator entladen und der mittlere Anodenstrom gemessen. Die Kondensatorgröße bestimmt den Meßbereich (7 Meßbereiche von 0 bis 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 30000 Impulse/sec). Das Verfahren hat gegenüber den mit Gleichstromverstärkern arbeitenden Ratemeterschaltungen den Vorzug, daß Nullpunktfehler nicht auftreten, da bei der Intensität 0 auch die Stromstärke 0 wird, und daß die Abweichungen von der Proportionalität zwischen Anzeige und Strahlenintensität bei hohen Stoßzahlen klein bleiben. Um das zu verstehen, bedarf es der folgenden Überlegungen: Kommen zwei Impulse sehr rasch aufeinander, so ist der Stoßkondensator über den Anodenwiderstand noch nicht wieder auf die volle Anodenspannung aufgeladen, der zweite Stoß wird daher kleiner als normal. Die dadurch bedingte Abweichung ist bei idealem Zählrohr und Verstärker und bei statistisch regellosem Strahleneinfall nur durch den mittleren

Spannungsabfall am Gesamtwiderstand im Anodenkreis im Verhältnis zur Anodenspannung bestimmt und bei konstantem Widerstand unabhängig vom Meßbereich [4]. Um diesen Einfluß des Spannungsabfalles auszuschalten und damit auch beim Aufschrieb von Diagrammen zur Intensität proportionale Auslenkungen zu erhalten, wurde eine besondere Stabilisierungsschaltung entwickelt, welche die mittlere Spannung am Stoßkondensator unabhängig von der Stoßzahl konstant hält (der Spannungsabfall an den Widerständen wird automatisch durch Erhöhung der Betriebsspannung ausgeglichen). Eine Abweichung von der Linearität entsteht somit nur durch das endliche Auflösungsvermögen des Diskriminators. Die dadurch ausfallenden Impulse mit kleinem Zeitabstand



Abb. 3. Gerät IDS/A mit Einkanal-Diskriminator (oben) sowie Goniometer mit angebautem Kathodenfolger und eingesetztem Proportional-Zählrohr (links), Präparatträger (Mitte) und Eingangsblende (rechts)

vom vorhergehenden Impuls würden aber nur zu Entladestößen im Stromtor führen, die erheblich schwächer als die normalen Entladestöße sind; deshalb ist der prozentuale Ausfall an Meßstrom viel kleiner als der prozentuale Ausfall an Impulsen, der beim normalen Ratemeter zur Wirkung kommt. Beispielsweise würde sich bei 10⁴ Imp/see bei normaler Ratemeterschaltung und einem Auflösungsvermögen von 2,5 µsee eine um 2,5 % zu kleine Anzeige ergeben. Im vorliegenden Fall beträgt die Zeitkonstante der Kondensatoraufladung im Stromtorkreis 7,5 µsee für den Bereich 10⁴ Imp/see. Damit errechnet sich ein Anzeigeausfall von nur 0,4 % bei 10⁴ Imp/see.

Unmittelbar nach einem Impuls liegt jedoch die Ansprechschwelle wegen des Rückimpulses etwas höher als normal. Das angegebene Auflösungsvermögen gilt daher nur bei großen Impulsen bzw. großen Kanalbreiten; bei kleiner Kanalbreite aber, bei der zwangsläufig die Impulsgröße nur knapp über der Ansprechschwelle liegt, ergibt sich ein schlechteres Auflösungsvermögen. Deshalb wurde der wahre Ausfall bei Impulsdichten von 10^4 Imp/sec durch Absorptionsmessungen an Cu K_{α} -Strahlung mit Al-Folie von $100 \, \mu$

Dicke bei verschiedenen Kanalbreiten experimer bestimmt. Man erhielt einen Ausfall von etwa 0, ohne Kanal, von 1% für 50% Kanalbreite, von für 20% Kanalbreite und von 6% für 10% Kanalbreite iener Impulsdichte von 104 Imp/sec. Man k demnach ohne Kanal und bei einer Kanalbreite 50% mit einer ,,linearen" Anzeige (Abweichung 51 im Meßbereich bis 10000 Imp/sec, bei 20% Kanalbreite im Ber bis 3000 Imp/sec und bei 10% Kanalbreite im Ber bis 1500 Imp/sec rechnen.

Abb. 3 zeigt das Gerät IDS/A sowie das Goniom mit dem angebauten Kathodenfolger und dem ein steckten Proportionalzähler IZ/10 P.

Messungen an einer $Cu K_{\alpha}$ -Interferenzlinie

Abb. 4 zeigt die Abhängigkeit der Stoßzahl der Zählrohrspannung bei einem Zählrohr IZ/Igemessen ohne Kanal mit nickel-gefilterter Cu Strahlung an einer intensiven Al-Interferenzlinie. Ansprechschwelle für die Energie der CuK_{α} -Strahlliegt bei 1900 V. Da die Impulsgrößen statistisch

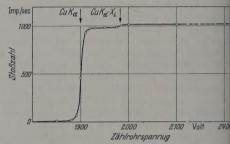


Abb. 4. Zählcharakteristik eines Rohres IZ/10 P mit CuK_{α} -Strat (Gerät IDS/A)

den Mittelwert streuen, ist der Anstieg nicht unend steil, die maximale Streuung entspricht dem Si nungsbereich zwischen 1880 und 1920 V. Von 1 und 1970 V steigt die Anzeige um etwa 1%. Zwisc 1970 und 2000 V ist deutlich eine Ansprechschw erkennbar, die Anzeige steigt um etwa 3%. Di Anstieg entspricht dem von Parrish und Koh entdeckten "escape-peak" und entsteht dadurch, zum Teil durch die CuK_x-Strahlung die L-Abs tionskante des Xenon angeregt und XL-Strahl erzeugt wird. Wird diese XL-Strahlung wiederun Gasraum absorbiert, so entsteht ein normaler Z rohrstoß. Wird das XL-Quant aber nicht absorb so bleibt für die ausgelöste Elektronenenergie nur Energiedifferenz zwischen Cu K_{α} - und XL-Strahb Von 2000 bis 2400 V hat man einen bemerkenswe guten "Konstanzbereich", die Anzeige ändert innerhalb der Meßgenauigkeit nicht. Da sich Impulsgröße von 1900 bis 2400 V gemäß Abb. 2 den Faktor 400 vergrößert und der Verstärker 2400 V etwa 200fach übersteuert ist, zeigt die l sung, daß der Verstärker eine hohe Sicherheit ge Übersteuerung hat (es treten weder Mehrfach-Imp auf, noch werden Impulse "verschluckt").

Bei Messungen ohne Kanal kann man entwede Bereich über 2000 V arbeiten und hat dann den Vo etwas größerer Empfindlichkeit, oder im Konst bereich zwischen den beiden Ansprechschwellen hat dann den Vorzug eines geringeren Verbrauches Dampfzusatzes. Die Steilheit des Kurvenanstiegs bei 1900 V gibt eits ein ungefähres Bild der Energieauflösung des bres. Eine genauere Messung der Impulsgrößenteilung erhält man, wenn bei konstanter mittlerer pulsgröße, d.h. konstanter Zählrohrspannung, und konstanter Einstrahlung die Abhängigkeit der Ange von der Einstellung der Löschschwelle gemessen d (Abb. 5). Die Zählrohrspannung wird zwecksißig so gewählt, daß die mittelere Impulsgröße etwa gler Mitte des Regelbereiches der Löschschwelle liegt.

Angezeigt werden alle Impulse, die kleiner sind als eingestellte Spannung der Löschschwelle und ßer als die feste Spannung der Ansprechschwelle tegralkurve). Wie die bei niederen Impulszahlen altenen Kurven zeigen und wie aus Abb. 4 bei der utzten Zählrohrspannung hervorging, sind prakhalle Impulse, die der Energie der $\operatorname{Cu} K_{\alpha}$ -Strahlung sprechen, größer als die Ansprechschwelle, dagegen 1 die Impulse der Energiedifferenz $\operatorname{Cu} K_{\alpha}$ -XL kleiner die Ansprechschwelle und werden nicht erfaßt. nessen wurde an einem starken Al-Reflex mit kelfilter.

Leider stand für diese Messungen und die noch genden Aufschriebe keine Röntgenanlage für Gleichnnung, sondern nur eine Anlage mit Halbwellenaltung zur Verfügung. Die tatsächlich auf das nlrohr fallenden Impulsdichten sind daher wesentn höher als die angezeigte mittlere Impulszahl/sec. diesen Faktor zu bestimmen, wurde der zeitliche lauf der Impulsdichte mit einem Oszillographen ch Beobachten des momentanen Zählrohrstromes genommen. Es ergab sich, daß die tatsächliche pulsdichte im Zählrohr etwa 3,6mal größer ist als angezeigte mittlere Impulszahl. Außerdem war zu ichten, daß die beschriebene Linearisierungsschalig exakt nur für statistisch regellosen Strahlenfall, also nur für Gleichspannung — aber nicht für Ibwellenbetrieb - arbeitet. Die Abweichungen der Linearität der Anzeige konnten aber aus dem pulsdichtenfaktor leicht errechnet werden, die Bwerte wurden entsprechend korrigiert.

Die Meßkurven Abb. 5 wurden bei 1000, 3000 und 000 Imp/sec aufgenommen, sie entsprechen also pulsdichten bzw. angezeigten Stoßzahlen bei Röntgleichspannung von 3600, 10 800 und 36 000 Imp/sec. Anzeigen bei hohen Löschspannungen wurden auf 0% normiert. Aus den Integralkurven ist leicht die erwartende prozentuale Impulszahl bei verschienen Kanalbreiten zu entnehmen. Bei einer mitten Impulsgröße von 48,5 V entspricht z.B. 10% nalbreite einer Spannungsdifferenz von 4,85 V. Aus Differenz der Anzeigen bei 50,9 und 46,1 V ergibt a somit, wieviel Prozent aller Impulse im 10%-nal liegen. Man erhält bei niedrigen Impulszahlen to 70% aller Impulse im 10%-Kanal und über 90% 20%-Kanal

20%-Kanal.
Bemerkenswert ist die Abhängigkeit der Integralven von der Stoßzahl. Bei hohen Stoßzahlen wern die Kurven flacher, sie verschieben sich in Richig kleiner Spannungen. Außerdem verschwindet die
zeige nicht, wenn Löschschwelle und Ansprechwelle gleich sind, wegen des unterschiedlichen Aufungsvermögens der beiden Kreise. Bei der Impulshte 10000/sec beträgt der Ausfall an Löschung etwa
% und ist damit praktisch unbedeutend. Die Veriebung und Abflachung ist zum Teil auf die Er-

höhung der Löschschwelle bei sehr rasch aufeinanderfolgenden Impulsen zurückzuführen, wesentlicher dürfte aber der Einfluß der Raumladungsbildung im Zählrohr auf die tatsächliche Impulshöhe sein: er ist bei Erhöhung der Impulsdichte unmittelbar im Oszillographen zu sehen, außerdem ergab sich bei einem mit 2000 V betriebenen Zählrohr eine doppelt so große Verschiebung. Aus diesem Grund wurde, wie sehon ausgeführt, eine verhältnismäßig niedere Zählrohrbetriebsspannung gewählt.

Bei der Impulsdichte 10800/sec beträgt die prozentuale Impulshöhenverminderung nur etwa 0,5%. Sie liegt an der Grenze der Meßgenauigkeit und ist ohne Einfluß auf praktische Messungen.

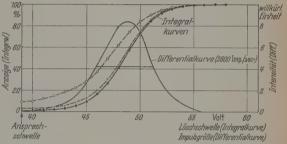


Abb. 5. Impulsgrößenverteilung bei einem Zählrohr IZ/10 P mit Cu K_{α} -Strahlung

Kurve	Imp/sec Anzeige Impuls-dichte		Impulse im Kanal		Ausfall der Lö- schung	Kanal- ver- schie- bung	Halb- wert- breite HWB
-x-x- -o-o-	1000 3000 10000	3600 10800 36000	68,5% 67% 61%	93 % 92 % 84 %	1% 2,5% 9%	0,3 % 2,5 %	11%

Trägt man die Steigung der Meßkurven in Funktion von der Spannung auf, so erhält man die Häufigkeit der Impulse/sec in Funktion ihrer Größe, d.h. die Impulsgrößenverteilung, die zur Quantenenergie der CuK_{α} -Strahlung gehört. Diese Verteilung wurde in Abb. 5 für die Impulsdichte 3600/sec eingetragen. Die Halbwertbreite (HWB) ergibt sich zu 11 % der mittleren Impulsgröße. Bei Prüfung verschiedener Rohre erhielten wir eine Streuung dieser HWB zwischen 11 und 15%. Diese Streuung dürfte vor allem auf Unregelmäßigkeiten der Drahtdicke und des Drahtquerschnittes über die Drahtlänge zurückzuführen sein. Eine Änderung der Drahtdicke um 1 μ (0,5%) entspricht nämlich einer Spannungsänderung von 0.4%, also von 7.5 V, und damit für sich allein schon einer Unschärfe der Impulsgröße von 7%. Leider kann die Homogenität des Drahtes vor dem Einbau nicht so genau kontrolliert werden, wie es demnach wünschenswert wäre.

Aufnahme von Interferenzdiagrammen

Das Arbeiten mit Kanal ist besonders vorteilhaft bei Präparaten mit starkem Streuuntergrund und schwachen Linien. Abb. 6 zeigt Aufschriebe mit einem Präparat aus Yttererde-Oxyd, bei dem sich ohne Kanal ein relativ hoher Untergrund ergab (der Untergrund kann nicht wesentlich durch Y-Eigenstrahlung verursacht sein, da er sonst schon bei 50% Kanalbreite unterdrückt wäre; der Aufschrieb ohne Kanal

erfolgte bei 1950 V entsprechend Abb. 4). Ohne Nickelfilter erhält man neben den α -Linien auch die entsprechenden β -Linien, von denen im Aufschrieb aber nur die der stärksten α -Linie (14,5°) zugehörige β -Linie (13°) alleinstehend und auffällig erscheint; sie wurde daher besonders markiert und ausgemessen.

Die Aufschriebe zeigen eindrucksvoll, wie durch Einschalten und Verengen des Kanals der Untergrund im Verhältnis zur Linie ganz wesentlich unterdrückt werden kann. Dagegen ist das Aussieben der β -Linie mit Kanal allein nicht genügend; dazu bleibt das

hält man bei 50% Kanalbreite die ungeschwäc Intensität, bei 20% Kanalbreite noch etwa 90% i bei 10% Kanalbreite etwa 70% der Linienintensit

Nimmt man eine Linienschwächung von 10% Kauf, so ergibt sich als zweckmäßige Einstellung ei Kanalbreite von 20%. Dabei wird der Untergrurelativ zur Linie um den Faktor 3,1 ohne Nickelfilbzw. 4,1 mit Filter geschwächt. Der bessere Faktor 1 Filter ergibt sich durch die spezielle Wirksamkeit Filters für Wellenlängen, die nur wenig kleiner sind die Eigenstrahlung und daher vom Diskriminator nie

ausgeschieden werd Die Kombination & Kanal und Filter wi daher besonders günst

Zieht man zum V gleich die Angaben w Parrish und Kohl heran, daß die Ha wertbreite der Energ auflösung des Szintil meters bei Cu K,-Stra lung 50% beträgt, ergibt sich, daß be Szintillometer mit K nalbreiten über 50% (arbeitet werden müß und infolgedessen mehr als doppelt so sta ker Untergrund erh ten würde. Die um et 25% höhere Absolt empfindlichkeit des Szi tillometers wiegt na Ansicht des Verfasse diesen Nachteil nic auf, um so mehr, als im allgemeinen dur geringe Erhöhung d Spannung oder des Str mes der Röntgenröh auszugleichen ist. Hin: kommt, daß beim Pi portionalzähler ein dü

ten würde. Die um et 25% höhere Absolu empfindlichkeit des Szitillometers wiegt na Ansicht des Verfasse diesen Nachteil nie auf, um so mehr, als im allgemeinen dur geringe Erhöhung d Spannung oder des Stimes der Röntgenröh auszugleichen ist. Him kommt, daß beim Phortionalzähler ein düneres Nickelfilter nigeringerer Linienschwächung als beim Szintillomet verwendet werden kann, weil nur beim Proportionalzähler eine wesentliche Schwächung der β-Intensit durch den Kanal erhalten wird. Erst bei Mol Strahlung dürfte die höhere Empfindlichkeit der stellten wird.

Besonders starken Streuuntergrund erhält met bekanntlich, wenn Eigenstrahlung im Probenmateri ausgelöst wird. Aus diesem Grund können bish eisenhaltige Proben nicht mit Cu K_{α} -Strahlen unte sucht werden. Abb. 7 zeigt solche Untersuchungen et Hochfrequenzeisen Ferrocube IIIB mit verschiedem Kanaleinstellungen. Der Kanal wurde möglichst syn metrisch auf die Cu K_{α} - oder auf die FeK-Energeingestellt. Je enger der Kanal, desto vollständigt ist die Trennung zwischen Cu K_{α} - und FeK-Strahlungen 20% Kanalbreite und Einstellung auf die FeK-Energie ist die Cu K_{α} -Linie nur noch schwach mit ein gen % ihrer wirklichen Intensität erkennbar. Entsprechend erhält man bei 20%-Kanal und Einstellung au

Szintillometers von wesentlicher Bedeutung sein.

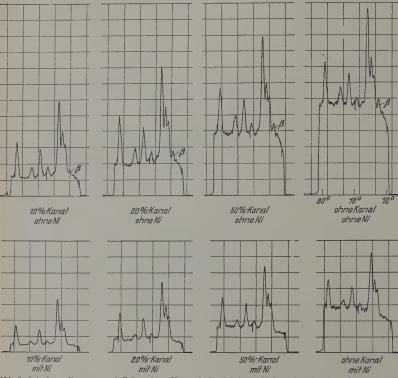


Abb. 6. Interferenzdiagramme mit Präparat aus Yttererde-Oxyd bei verschiedenen Kanalbreiten, ohne β -Filterung (obere Reihe) und mit Filterung durch 17 μ -Nickelfolie (untere Reihe)

Nickelfilter notwendig, es kann aber etwas dünner sein als üblich. Verwendet wurde ein Nickelfilter von 17 μ Dicke, das die Cu K_{α} -Intensität um 45% schwächte. Ausreichend wäre ein Filter von 10 μ Dicke mit einer Schwächung der Nutzstrahlung um 30%.

Tabelle 1. Einfluß der Kanalbreite auf die Intensitäten von Linie und Untergrund bei Yttererde-Oxyd (Aufschriebe Abb. 6)

Kanal		Ohne	50%	20%	10%
Filter	٠	$-17\mu \text{Ni}$	$-17\mu Ni$	$-17\mu \text{Ni}$	$-17\mu N$
α -Linie β -Linie					
Grund		100 100	66 56	29 23	13.5 12
α-Linie/Grund					

Um den Einfluß des Kanals quantitativ zu erfassen, wurde jeweils die Höhe der stärksten α - und der markierten β -Linie sowie des Untergrundes ausgemessen und die Höhen ohne Kanal gleich 100 gesetzt. Die Ergebnisse zeigt Tabelle~1. In Übereinstimmung mit der beschriebenen Messung an der Einzellinie er-

iie $\operatorname{Du} K_{\alpha}$ -Energie 90% der $\operatorname{Cu} K_{\alpha}$ -Linie und nur noch ir e % der Eisenstrahlung. Damit ist aber eine Unterdung von eisenhaltigen Stoffen mit $\operatorname{Cu} K_{\alpha}$ -Strahmöglich.

Zählrohre für Molybdänstrahlung

PARRISH und KOHLER [6] berichten, daß bei der ung von Molybdänstrahlung mit kryptongefüllt Zählrohren etwa 55% der Intensität in einem gefüllte. Bei beiden Füllungen werden 78% einer einfallenden $\mathrm{Cu}\,K_\alpha$ -Strahlung absorbiert. Das Rohr kann daher auch zu Untersuchungen mit $\mathrm{Cu}\,K_\alpha$ -Strahlung benutzt werden; nachteilig gegenüber dem nur mit Xenon gefüllten Rohr ist dabei die erheblich höhere Betriebsspannung sowie die 2 bis 3mal höhere Empfindlichkeit im kurzwelligen Gebiet oberhalb der KrK-Kante, die beim Arbeiten ohne Kanal einen etwas stärkeren Streuuntergrund bewirkt.



Abb. 7. Untersuchung einer Eisenverbindung (Ferrocube IIIB, Fa. Valvo) mit CuKg-Strahlung bei verschiedenen Kanaleinstellungen

eape-peak" erscheint, welcher der Energiedifferenz K-KrK entspricht. Dadurch wird bei Messung i Kanal die ausnutzbare Empfindlichkeit auf etwa idHälfte reduziert. Die Linienaufspaltung wird durch &Bildung von Krypton-Eigenstrahlung verursacht, hur wenig in der Krypton-Füllung geschwächt wird. a kann aber einen beträchtlichen Teil dieser Quandurch Zusetzen von Xenon zur Füllung wieder orbieren. In diesem Fall wird wiederum die gete Energie der Molybdänstrahlung in Elektronengie umgesetzt, die der Energiedifferenz Mo K_{α} -KrKsprechende Linie wird schwächer und die Linie K_{α} stärker. Abb. 8 zeigt die Verteilung bei einem ur, das mit 480 mm Krypton und 200 mm Xenon eillt wurde (Messung mit Mo-Röhre, Zr-gefiltert, in m Al-Reflex für Mo Ka-Strahlung). Bei der Kanalte von 5% wurde die sekundliche Stoßzahl in Abgigkeit von der Zählrohrspannung aufgetragen. Da Logarithmus der Impulsgröße der Spannung protional ist (vgl. Abb. 2), entspricht 5% Kanalbreite eils derselben Zählrohrspannungsbreite von 5,5 V, Linienintensitäten entsprechen also den Linienhen; außerdem kann die Spannungsskala leicht ch eine Energieskala in keV ergänzt werden. Bei 5 keV erscheint die starke Mo K_{lpha} -Linie, bei 4,8 keV Linie $\operatorname{Mo} K_{\alpha} - \operatorname{Kr} K_{\alpha}$, ferner bei 3,4 keV die Linie $K_{\alpha} - \operatorname{Kr} K_{\beta}$. Auf die beiden Differenzlinien zuumen entfallen nur noch 29% der gesamten Intent, auf die Hauptlinie 71%. Da 45% der Mo K_{lpha} ahlung im Gasgemisch absorbiert wird, ergibt sich Messungen im Kanal eine ausnutzbare Empfindkeit von immerhin 32% für Mo K_{α} -Strahlung. Berdem ist bemerkenswert, daß das Rohr im langligen Gebiet bis zur KrK-Absorptionskante diebe Empfindlichkeit hat wie das mit 300 mm Xenon

Lebensdauer der Proportional-Zählrohre

Die zu erwartende Lebensdauer wurde an einem der mit Xenon gefüllten Rohre für Cu*K*-Strahlung untersucht. Da Messungen über die Lebensdauer, d.h. über Änderungen der Zähleigenschaften durch die Benut-

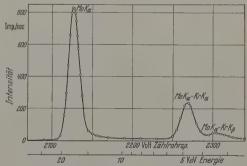


Abb. 8. Amplitudenverteilung beim Kr—X-Zählrohr für Mo K_{α} -Strahlung (Kanalbreite 5%)

zung, unter normalen Betriebsbedingungen außerordentlich lange Zeit erfordern würden, wurde die Einstrahlung so stark gemacht, daß bei normaler Betriebsspannung (1920 V) der Zählrohrstrom 4·10-6 A betrug. Diese Belastung entspricht nach Abb. 2 einer Stoßzahl von 2,7·10⁷ Stößen/sec. Nach 10stündigem Betrieb, also nach 10¹¹ Stößen, war die Ansprechschwelle um 23 V angestiegen (das Absinken der Stromstärke während der Versuche wurde durch Spannungserhöhung ausgeglichen). Außerdem wurde im 10%-Kanal, bezogen auf gleiche Stoßzahl ohne Kanal, eine um 6% kleinere Anzeige als vor der Belastung erhalten, d.h. die HWB der Impulsgrößen-

verteilung war etwas größer geworden. Immerhin war das Rohr noch durchaus als brauchbar anzusprechen, so daß bei normaler Betriebsweise mit einer Lebensdauer von mindestens 10¹¹ Stößen gerechnet werden kann. Bei einer mittleren Impulszahl von 1000/sec würde dies einer Lebensdauer von 30000 Std entsprechen.

Zusammenfassung

Aufbau und Eigenschaften der Proportional-Zählrohre und des Diskriminators werdeneingehend beschrieben. — Anzeige und Ausgangsstrom sind bei 50% Kanalbreite bis zu 10000 Imp/sec, bei 20% bis zu 3000 Imp/sec, auf 1% proportional zur Intensität. — Die Absorptionsempfindlichkeit der Zählrohre für CuK-Strahlung beträgt 78%, die Halbwertsbreite der Impulsgrößenverteilung nur 11 bis 15% der mittleren Impulsgröße. Dadurch erhält man mit Kanalbreiten von etwa 20% wesentlich bessere Interferenzdiagramme, als sie mit Szintillationszählern erreichbar sind. —

Beim Zählrohr für MoK-Strahlung wird durch besondere Gasmischung die Aufspaltung in zwei schiedene Impulsgrößen wesentlich unterdrückt so bei einer Absorptionsempfindlichkeit von 45% Ansprechempfindlichkeit von 32% im Kanal erre Die Zählrohre haben eine sehr lange Lebensde sie entspricht etwa 10¹¹ Stößen.

Literatur: [1] LINDEMANN, R., u. A. TROST: Z. P. 115, 456 (1940). — [2] BERTHOLD, R., u. A. TROST: Schw Arch. angew. Wiss. Techn. 18, 1 (1952). — [3] z. B. RISH, W., E. HAMACHER u. K. LOWITZSCH: Philips Techn. 16, 123 (1954/55). — [4] TROST, A.: Z. angew. Phys. 2 (1950). — [5] ARNDT, U. W., and D. P. RILEY: Proc. 2 Soc. Lond. 74, 74 (1952). — [6] PARRISH, W., and T. R. LER: Rev. Sci. Instrum. 27, 795 (1956). — [7] DOWLIN C. HENDEE, T. KOHLER u. W. PARRISH: Philips Techn. 18, 262 (1956/57). — [8] MÖLLER, M., u. F. BRASSE: Eisenhüttenw. 28, 831 (1957). — [9] TAYLOR, J., and W. RISH: Rev. Sci. Instr. 26, 367 (1955).

Dr. Ing. habil. Adolf Trost, Laboratorium Prof. Dr. Bertho Wildbad i. Schwarzwald

Einige Eigenschaften dünner, im elektrischen Felde aufgedampfter Einkristallschichten aus Barium-Strontiumtitanat

Von Alexander Moll

Mit 7 Textabbildungen
(Eingegangen am 2. Juni 1958)

Bariumtitanat wurde im Jahre 1943 von Salomon ($\frac{3}{4}$ 4 und Wainer [1] als ferroelektrisch erkannt. Im Gegen-

Abb. 1. DK und tgs δ einer BaTiO₃-Keramik, gemessen bei 1 kHz und einer Feldstärke von 2,29 V/cm (nach A. V. HIPPEL)

Stoffen besitzt es eine einfache Kristallstruktur, die dem Perowskittypus entspricht. Oberhalb des Curie-Punktes ist Bariumtitanat kubisch und die Suszeptibilität befolgt das Curie-Weißsche Gesetz; doch ist die Curiesche Konstante (150000) mehrere Zehnerpotenzen größer als die von der Theorie geforderte $(\frac{3}{4} T_c)$, und der Ausdruck für das wirksame Fe

$$E' = E - rac{4}{3} P_{
m Ti} - P_{
m Ba} - \ - \left(rac{a}{3} - 1
ight) P_{
m 0\,I} - \left(rac{a}{3} - 2
ight) P_{
m 0\,II} *
ight\}$$

unterscheidet sich von dem für das Mosottische deinige Zusatzglieder.

Im Curie-Punkt wird die Dielektrizitätskonst (im folgenden mit DK abgekürzt) sehr groß, es spontane Polarisation ein, und der Kristall wird abnehmender Temperatur infolge von Verlagerun Ti⁴⁺-Ions tetragonal und ferroelektrisch. Megav zeigte, daß im Curie-Punkt sowohl die kubisch auch die tetragonale Phase existieren kann, wäh von Hippel [4] fand, daß die Differenz der Krienergien beider Phasen klein und die Potentialm des Ti-Ions sehr flach ist. Kleine elektrische Fvermögen daher schon einen Phasenwechsel he zuführen oder Richtung und Größe der Polarist zu ändern.

Diese im polarisierten Licht gut sichtbare scheinung benutzte Merz [5], um den Domädurchmesser ($d \approx 10^{-4}$ cm) zu bestimmen, wäh Känzte [6] durch Anlegen höherer Feldstä ($3 \cdot 10^4 \, \mathrm{V \cdot cm^{-1}}$) zu Eindomänenkristallen gelangte sich allerdings nach Abschalten des Feldes weger stets vorhandenen inneren Spannungen und and Ursachen reorientierten.

^{*} Die P bedeuten die Polarisationen der einzelnen P arten, wobei der Index die Atomart angibt. P ist ein Trza P berechneter Gitterfaktor.

ine der wichtigsten und interessantesten Eigennten des Bariumtitanats ist seine hohe DK. Ihre
molle Ausnutzung ist aber stets an den Curierch gebunden, denn einerseits hat die DK in
sem Bereich ein Maximum und andererseits sind
lie Verluste besonders gering (Abb. I). Da nun
Furie-Bereich reinen Bariumtitanats hinsichtlich
technischen Anwendung temperaturmäßig unnig liegt, wurden seit der Entdeckung seiner ferrorischen Eigenschaften zahlreiche Versuche unternen, den Curie-Bereich nach tieferen Tempenen zu verschieben.

achdem Merz [7] eine lineare Druckabhängigkeit somit die Abhängigkeit des Curie-Punktes vom rparameter erkannt hatte, vermochten Rushman STRIVENS [7a] den Curie-Bereich dadurch zu verben, daß sie einen Teil der Bariumatome durch ritium ersetzten1. Zugleich ermöglicht die Exivon Fremdatomen eine erhöhte Polarisation Materie und somit eine Steigerung der DK. Der iteil von Barium-Strontiumtitanatgemischen ist rallem ihrer polykristallinen Struktur zuzuschrei-Bei ihrer Verwendung verzichtet man somit auf antliche Eigenschaften der Einkristalle zugunsten DK. Da die Herstellung der Barium-Strontiumat-Keramiken nur bei Temperaturen von etwa bis 1500° C möglich ist, wird ihre DK durch die unvermeidbaren Restspannungen analog dem magnetischen Fall stark herabgesetzt, während die durch unregelmäßige Anordnung polykristal-Gebiete verursachten Inhomogenitäten in einer zahl von Resonanzstellen im HF- und UHFich äußern.

Aus diesem Grunde sind die Bestrebungen auf dem iete der Ferroelektrica in neuerer Zeit darauf auschtet, ein selbst im Frequenzbereich 10⁸ bis 0¹⁰ Hz brauchbares Material mit hoher DK und baren Verlusten zu finden. Veröffentlichungen derartige Höchstfrequenzkeramiken sind bislang daus kommerziellen Gründen nicht erschienen, ere Arbeiten von DAVIS [8] lassen jedoch erkennen, der Füllfaktor² des Materials eine ausschlagende Rolle spielt. Der naheliegende Gedanke, hkristalle gegebener Zusammensetzung aus einer natgemisch-Schmelze zu züchten, scheitert an der derung nach strenger Einhaltung kleiner Abkühlhwindigkeiten bei relativ hohen Temperaturen. Eine andere Möglichkeit, Mischkristalle von gege-

err Zusammensetzung zu erhalten, bietet sich in talt einer Kondensation aus der Gasphase an. se Möglichkeit soll in der vorliegenden Arbeit näher ersucht werden. Gleichzeitig wird dabei das Ziel Auge gefaßt, ein spannungsfreies, sehr dünnes coelektricum herzustellen.

beiektricum nerzustellen.

nentarvorgänge beim Aufbau eines Festkörpers aus Gasphase und die Beeinflußbarkeit seiner Struktur

Drei Elementarprozesse bestimmen im wesenten den Aufbau eines Festkörpers aus der Gasphase: 1. Die Kondensation des mit thermischer Gevindigkeit ankommenden Moleküls,

- 2. eine Oberflächenwanderung des Moleküls auf der Oberfläche des entstehenden Kristalls nach einer Wachstumsstelle und
- 3. das Einschwingen des Moleküls an einer Wachstumsstelle.

Die Kondensation von Molekülen an einer Fläche ist eine Frage der kritischen Kondensationstemperatur, der Verweilzeit und des Akkommodationskoeffizienten. Während die kritische Kondensationstemperatur von der Wahl des Oberflächenmaterials und von der Temperatur abhängt, ist der Akkommodationskoeffizient bis auf den Sonderfall der dünnsten Schichten bereits durch den zu verdampfenden Stoff festgelegt. Die Oberflächenwanderung des Moleküls auf der Kristalloberfläche ist im wesentlichen temperaturabhängig. Von der Möglichkeit eines Platzwechsels wurde Gebrauch gemacht, indem die Temperatur an der Kondensationsstelle so gewählt wurde, daß bei genügender Kondensationsgeschwindigkeit eine maximale Platzwechselgeschwindigkeit gegeben war. Es zeigte sich eine starke Abhängigkeit der Kristallgüte von der Temperatur, die auf das Einschwingen der Moleküle in Wachstumsstellen zurückzuführen war. Derartige Effekte wurden erstmalig von König [9] an Germanium- und Eisenschichten gefunden. Eine weitere Beeinflussung der aufgedampften Schichten ist im Falle der Einkristallzüchtung von Ferroelektricis durch die Anwendung eines elektrischen Feldes möglich. Vorversuche ergaben, daß die Anwendung eines elektrischen Feldes während des Aufdampfprozesses und darauf folgende Abkühlung eine "geordnete" Kristallisation bewirkt, indem die Domänenund Achsenrichtung des werdenden Kristalls durch die Richtung des elektrischen Feldes vorgegeben werden. Gleichzeitig wird die Bildung der hexagonalen Modifikation³ des Titanats durch das Feld unterbunden, da die kubische Modifikation im Felde eine kleinere Energie besitzt.

Der Molekularstrahlofen und die Verdampfung von Barium-Strontiumtitanat

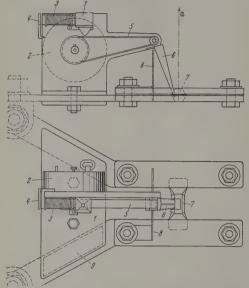
Ein wesentlicher Grund dafür, daß Bariumtitanat bislang nicht in aufgedampfter Form benutzt wurde, liegt in der großen Schwierigkeit, dieses Material zu verdampfen. Fast alle in Frage kommenden Ofenmaterialien werden während des Verdampfungsprozesses zerstört. Neben einer chemischen Umsetzung der beteiligten Stoffe findet vor allem — wie im Falle des Platins und Wolframs — ein Auflösen des Metalls in fein verteilte Form statt. Das Titanat wird ähnlich dem metallisches Natrium enthaltenden Natriumchlorid blau verfärbt und nimmt die Eigenschaften eines Halbleiters an.

Es wurden nun zwei Methoden entwickelt, die es ermöglichen, Titanate oder deren Gemische beliebiger Zusammensetzung zu verdampfen. Die erste Methode beruht auf der Löslichkeit von Bariumtitanat und Strontiumtitanat in Strontiumoxyd bei 1500° C, wobei das Bariumtitanat als ein BaTiO₃—SrTiO₃—TiO₂-Gemisch aus einer im Wolframschiffchen befindlichen SrO-Lösung nach vorheriger gründlicher Entgasung bei 2000° C verdampft wird.

Zum Beispiel liegt der Curie-Punkt einer Bariumtitanatumik mit 30% Strontiumtitanat bereits bei 15° C. Der Füllfaktor f wird definiert als das Produkt f = NV, si V das Volumen eines Dipols und N die Zahl der Dipole er Volumeinheit ist.

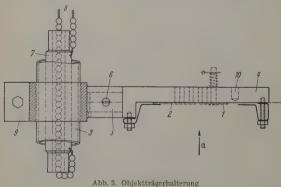
 $^{^3}$ Die hexagonale Modifikation (mit gewöhnlichen dielektrischen Eigenschaften) erhielt Matthias [10] beim Züchten von ${\rm BaTiO_3\text{-}Einkristallen}$ neben der kubischen.

Die nach dieser Methode hergestellten harten und klar durchsichtigen Schichten erreichten infolge der beschränkten Titanatmenge eine Dicke von 0,1 µ. Bei größeren Dicken¹ (1 bis 2 µ) zeigen sie eine gelbliche Färbung und ihre Sprödigkeit nimmt zu. Die chemische Zusammensetzung der Schicht ist von der jewei-



Vollautomatisches Förderband zu Bedampfung mit Stoffgemischen

ligen Ofentemperatur sowie von der Bedampfungszeit stark abhängig; infolgedessen sind ihre das Ausgangsmaterial bei weitem übertreffenden ferroelektrischen Eigenschaften zeitlich nicht konstant, der Curie-



Bereich erstreckt sich über ein größeres Temperaturintervall, und die Reproduktion einer Schicht ist nur mit größerem Aufwand zu erzwingen. Wesentlich bessere Reproduzierbarkeit erhält man mit der zweiten Methode:

Ein in Abb. 2 dargestelltes und speziell für die Bedampfung mit Stoffgemischen entwickeltes Förderband transportiert beim Einschalten des Ofenstromes das zu verdampfende Material in Form eines Granulats (z.B. BS 73, bestehend aus 73% BaTiO₃ und 27% SrTiO₃) aus dem Trichter (1) zum berylliumoxydgeschützten Ofen (7), wo es sofort verdampft und e Molekularstrahl mit der Achse a bildet2.

Ein vibrierender Elektromagnet und die rich Einstellung des Trichters verhindern seine Vers fung. Ein Messingschirm (8) dient als Schutz des Silicongummi bestehenden Förderbandes (5) vor Ofenstrahlung.

Der Vorteil des Verfahrens besteht im folgene

1. Die chemische Zusammensetzung der gewünten Schicht ist vorgebbar.

2. Die zu verdampfende Materialmenge ist w schränkt und hängt von der Trichtergröße ab.

3. Die Schichtdicke ist der Bedampfungszeit str proportional. (Bei einfachen Dampfquellen besteht Proportionalität nur in erster Näherung.)

Der Nachteil des Verfahrens liegt vor allem da daß man keine Vorentgasung des Materials du führen kann, ein Umstand, der sich bei späteren dampfungen mit elektrischem Feld störend bemerk machte.

Die bei größeren Dicken blaßgelben Schich besaßen gegenüber den nach der ersten Methode l gestellten eine wesentlich höhere DK, die monatel konstant blieb. Ihre polykristalline Struktur w. sich jedoch immer dort nachteilig aus, wo eine e. trische Beanspruchung oder eine Erwärmung nicht umgehen ist. Die Domänenstruktur ändert sich de irreversibel.

Kondensator und Objektträgerhalterung

Um zu einer domänenzerfallsbeständigen B kristallschicht mit ausgerichteten Domänen zu langen, lag es nahe, einerseits die Kondensation so die Abkühlung der Schichten in einem elektrise Felde ablaufen zu lassen und andererseits die Schie dicke in der Größenordnung des Durchmessers

biler Domänen zu belassen. Im Gegensatz den von Känzig und Blattner [6] erl tenen Titanateinkristallen mit ausgerichte Domänen, konnte eine gewisse Strukturstal tät der durch Kondensation hergestellten I kristallschichten schon deshalb erwartet werd weil hier innere Spannungen praktisch aus schlossen werden können. Der zur Felderzeug benötigte Kondensator bestand in einfachs Weise einerseits aus der Objektträgerhalten (Abb. 3) — das Objekt sollte ja dem Felde a gesetzt werden -, andererseits aus einer de verschiebbar angebrachten polierten Metallel trode, die durch Trolitul-Gleitschienen gehal wurde. Das zwischen 0 und 8kV/cm regelb elektrische Feld wurde durch einen Hochsp nungsgleichrichter gespeist.

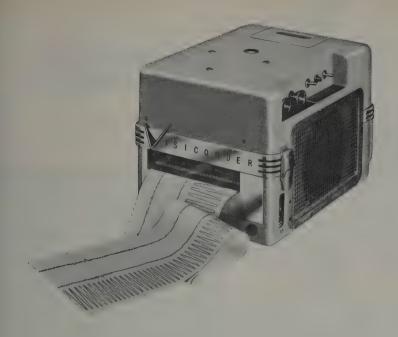
Die Objektträgerhalterung (4) in Abb. 3, besteht aus einem massiven Kupferstück, dient als Heizt des Objektträgers (1), als Feldelektrode und als Trä eines zur Schichtdickenbestimmung benötigten M plättehens (2). Sie wird durch einen Zapfen (5) einer auf dem Kühlfinger³ (3) vertikal verschiebba

 2 Das Wesentliche an dieser Methode liegt unter ander darin, daß den in den Ofen hineinfallenden Teilchen ko Zeit bleibt, das Wolfram anzugreifen. Sie verdampfen inte ihrer Kleinheit und der hohen Temperatur des Ofens, be ein richtiger Kontakt zwischen ihnen und dem Ofen hergest Der BeO-Überzug ist eine Sicherheitsvorkehrung.

³ Es handelt sich hier um einen aus der Vakuumtech

geläufigen kupfernen Kühlfinger, der hier aber nicht zum A

¹ Diese wurden durch mehrfaches Aufdampfen hergestellt.



Dieser von Honeywell entwickelte direkt schreibende

Lichtstrahl-Schleifenoszillograph kann in zwei Ausführungsformen zur Registrierung von maximal 8 oder 14 dynamischen

Größen geliefert werden. Der Schreibfrequenzbereich reicht bei hoher Galvanometerempfindlichkeit von 0—2000 Hz oder

0—3000 Hz. Der dynamische Vorgang ist auf dem Papier direkt sichtbar, beständig und bedarf keinerlei Nachbehandlung.

Maximaler Papiervorschub 1 m/Sek. mit 16 Abstufungen bis herab zu 0,4 cm/h. Sein geringes Eigengewicht und seine Handlichkeit machen den Visicorder zum idealen

Registrier-Oszillographen in der Forschung und im Betrieb.

Honeywell



Schrittmacher der Regeltechnik

NEYWELL GMBH FRANKFURT AM MAIN • BERLIN-WILMERSDORF • DÜSSELDORF • HAMBURG • STUTTGART • MÜNCHEN

An die	9							
HONE'	YWELL G	МВН	FRANK	FURT A. M.	BEETHOV	ENSTR. 18	3 »WERBE	ABTEILUNG
Bitte	senden	Sie u	ıns die	e genaue	n technis	chen Da	ten des '	Visicorders
Name								on outcome to delay.
Anach								



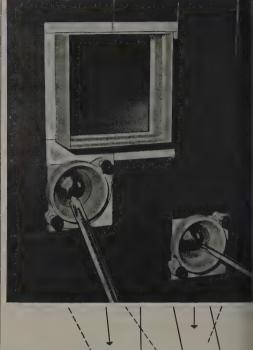
TK 6,

ein neues Innenkreis-Reflexklystron, durchstimmbar von 6,3...7,7 GHz. HF-Ausgangsleitung 190 mW. Elektronische Bandbreite 40 MHz. Extrem niedriger Temperaturkoeffizient 10 kHz/°C; dadurch frequenzstabiler Betrieb auch bei starken Temperaturschwankungen. Besonders geeignet für bewegliche Anlagen.



TELEFUNKEN RÖHREN-VERTRIEB ULM-DONAU





Bleiglasfenster aus hochbleihaltigen Gläsern mit Di von 3,2 - 6,2 als Strahlungsschutz zur Absorption Gammastrahlen für alle Anwendungsgebiete.

Diese Spezialgläser sind in Größen bis maximal 1300 Kantenlänge und je nach Glasart in Dicken von 150 300 mm lieferbar.

Hervorragend geeignet sind diese Gläser für "heiße Zel für Bestrahlungsversuche, Isotopenlaboratorien usw Die Schutzwirkung dieser Bleigläser mit der Dichte 3,2 entspricht der von Baryt-Beton.



JENAER GLAS

Isschette (9) gehalten, kann um die Achse A geret und in jeder Winkelstellung arretiert werden. Jur Temperaturregulierung der Objektträgerhalterwird ein Widerstand (7) (100 W) in den Kühlner (3) herabgelassen und bei (8) über einen regelan Vorwiderstand sowie hitzebeständig isolierte Zusingen gespeist. Eine

e peraturkontrolle erly in (10).

Die Messung der Schichtdicke

Sind Dichte ϱ des edampften Stoffes wahre Oberfläche F bedampften Objekters bekannt, so läßt die Schichtdicke d h die beim Bedampentstehende Massenbrung Δm des Obträgers ausdrücken:

$$d=rac{arDeta m}{F\cdotarrho}$$

Dichtewert wurde enige kompakten erials zur Schichtcenberechnung herezogen, da der Füllor der Schicht ine richtiger Tempeung des Objektträpraktisch den Wert 1 ahm. Eine Oberflänkorrektur war bei s nicht erforderlich. es wurde der Faktor : 1,01 eingeführt, so-1 Glimmer als Meßttchen Verwendung Sämtliche Meßttchen aus Glimmer r Glas hatten eine $ke \text{ von } ^2/_{100} \text{ mm und}$ rden nur im frisch gestellten Zustand wendet.

Die Genauigkeit der gemethode ist der be-

npften Fläche des Meßplättchens proportional. Im meisten Dickenbestimmungen wurden zunächst teiner Fläche von 7 cm² durchgeführt und daeine Waage benutzt, die ½0 mg abzulesen gettete. Nach einer späteren Überprüfung der Zeitportionalität der Schichtdicke wurden auch bere Glimmerplättchen bis zu 25 cm² bedampft.

ren benutzt wurde, sondern zur Befestigung und Unterngung der Objektträgerhalterung sowie des Heizwiderndes.

⁴ Die Zeitproportionalität der Schichtdicke wurde so eng eingehalten, daß sie später bei der Massenherstellung mer (Ba, Sr)-TiO₃-Schichten zur Dickenmessung benutzt rden konnte. Die Wägemethode wurde dann lediglich zeitise zur Kontrolle eingeschaltet. Die Übereinstimmung beider Dickenbestimmungen war gut.

Der mittlere relative Fehler der Schichtdickenmessung betrug bei einer Schichtdicke von 0,1 μ etwa $\pm\,13\,\%$, während Schichtdicken von 1 μ mit einem mittleren relativen Fehler von 3% behaftet waren.





Abb. 4a—c. a Einkristallschicht aus Barium-Strontiumtitanat. Kondensationstemperatur 100° C, Feldstärke 8 kV/cm Vergrößerung 500fach. b Türmchenreihen bei stärkerer Vergrößerung, c Statistisch verteilte Türmchen bei Kondensationstemperatur von 50° C. Die Türmchen sind infolge Oberflächenwanderung von Kristallhäufehen umgeben. (Vergrößerung 2000fach)

Eigenschaften der Einkristallschichten

Dünne Barium-Strontiumtitanatschichten zeigen auf Glimmer, Glas und Metall eine gute Haftfestigkeit. Während sehr dünne Barium-Strontiumtitanatschichten völlig farblos aussehen und an dünne Glashäute erinnern, zeigen Schichten mit einer Dicke von 0,1 µ eine deutlich blaßgelbe Färbung, die mit zunehmender Schichtdicke in eine gelbbraune und schließlich in eine braungrüne übergeht. Gleichzeitig wird ab 0,1 µ eine Schichtstruktur deutlich sichtbar. Die gesamte Kristallschicht erscheint mit einer Vielzahl von feinen parallelen Streifen durchzogen, welche ihrerseits aus einer Menge paralleler Querstreifen bestehen. Abb. 4 zeigt eine Einkristallschicht, welche durch Bedampfen

eines auf 100°C erwärmten NaF-Objektträgers und nachträgliches Ablösen in destilliertem Wasser hergestellt wurde. Eine genauere Betrachtung der Parallelstreifen läßt erkennen, daß diese aus einer Vielzahl paralleler Türmchen aufgebaut sind. Streifenrichtung und Bedampfungsrichtung schließen nahezu einen Winkel von 90° ein. Es ist bemerkenswert, daß die Türmchen keine statistische Verteilung zeigen wie bei einer gewöhnlichen Schrägbedampfung. Vielmehr existieren hier auf Geraden gelegene Orte, an denen die Kondensation bevorzugt erfolgt. Eine nochmalige Vergrößerung eines Streifens (Abb. 4b) offenbart eine völlig geordnete Streifenstruktur. Die Wachstumsstellen der Türmchen folgen mit bestechender Regelmäßigkeit, wobei der mittlere Türmchenabstand etwa 10⁻⁴ cm beträgt¹:

Das Entstehen von Türmchen ist ein stark temperaturabhängiger Bedampfungseffekt. Läßt man z.B. den Objektträger nach anfänglicher Bedampfung auf

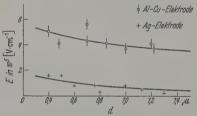


Abb. 5. Durchschlagfeldstärke E in Abhängigkeit von Schichtdicke und Elektrodenmaterial

50° C abkühlen und bedampft erneut, so nimmt die Türmchenverteilung mehr den Charakter einer statistischen Verteilung an (Abb. 4c). Die Türmchen werden zu großen spitzen Kegeln ausgebildet, die infolge molekularer Oberflächenwanderung von mikrokristallinen Häufchen eingeschlossen werden. Erfolgt die Bedampfung oberhalb von 150° C, so kommt praktisch keine Türmchenbildung mehr zustande.

Um nun festzustellen, welchen Einfluß die Objektträgeroberfläche auf die Struktur der Schicht ausübt, wurden außer der NaF-Bedampfung auch Glas- und Glimmerbedampfungen in gleicher Weise untersucht. Hier zeigten sich die gleichen Effekte; nur bei dünnsten Schichten wurden einige Unterschiede gefunden.

Da die dünne Barium-Strontiumtitanatschicht ein vielversprechendes Dielektricum zu sein schien, wurde vorerst ihre Durchschlagfestigkeit untersucht. Das zu untersuchende Material wurde als Dielektricum eines durch schichtenweises Aufdampfen hergestellten Kondensators einer meßbaren Spannung ausgesetzt. Die Trägerelektrode bestand aus hochglanzpoliertem Vakon, die andere Elektrode aus Ag, Cu oder Al. Um eine etwaige Veränderung der Schichtstruktur zu vermeiden, wurden die Messungen mit Wechselspannung durchgeführt². Es stellte sich heraus, daß die Durchschlagfestigkeit einer aufgedampften Schicht entscheidend vom Material der aufgedampften Elektrode abhängt (Abb. 5). Während aufgedampfte Ag-Schichten — wahrscheinlich infolge von Diffusion des Ag schon bei relativ geringen Feldstärken zum Durchschlag führen, lassen verkupferte Al-Elektroden 5- bis

8mal höhere Feldstärken³ zu. Nach dünnen Schick hin nimmt die Durchschlagfeldstärke etwas zu erreicht mit $5\cdot 10^5$ V/cm* die Durchschlagfeldstä der besten Isolatoren. Messungen an Schichtdie unter 0.3 μ sind nicht mehr sinnvoll, weil die Streuder Meßwerte mit abnehmender Schichtdicke st zunimmt. Da diese Schichten teilweise 1 bis 2 T nach der Herstellung stark veränderte Werte ergalwurden nur frisch hergestellte Schichten ausgemes Die Ursachen für den Alterungseffekt sind wahrschlich in der Absorption von Fremdstoffen (Was Luft) zu suchen. Indes ist eine Strukturumwandlinnerhalb der Schicht nicht unwahrscheinlich, gleichzeitig eine sprunghafte Änderung der DK obachtet werden konnte.

Eine weitere Eigenschaft dünner Barium-Strtiumtitanatschichten ist wert, erwähnt zu werden: Gegensatz zu gewöhnlichen Bariumtitanat-Kerami zeigen dünne Barium-Strontiumtitanatschichten MHz-Bereich keine piezoelektrischen Resonanzerse nungen; ein Effekt, der sich durch die geringe Di des Materials erklären ließe. Im Versuch wurde e $20\,\mu$ dicke Barium-Strontiumtitanatschicht als elektricum eines lose gekoppelten Parallelschwikreises benutzt. Die Spannung über dem Kondense des Kreises wurde mit Hilfe eines Oszillographen messen. Bemerkenswert ist die große Dämpfung mit aufgedampfter Schicht betriebenen Kreises, ne dem Fehlen jeglicher piezoelektrischer Resonanzen

Die Dielektrizitätskonstante aufgedampfter Bariu-Strontiumtitanatschichten bei höchsten Frequenze

Da von dünnen, im elektrischen Felde aufgedamten Barium-Strontiumtitanatschichten in Hinsicht ihre DK bei höchsten Frequenzen noch nichts bekaigeworden ist, schien es angebracht, die Freque abhängigkeit der DK solcher Schichten näher untersuchen. Als Meßgerät bot sich in dem hau sächlich interessierenden Frequenzbereich 1000 2000 MHz die homogene konzentrische Meßleitung Sämtliche Messungen wurden nach der von ESAU 1 PRÖSDORF [11] beschriebenen Methode ausgefül Für kleine Probenlängen, d. h. $d < 0.02 \ \lambda/|/\varepsilon$ hat mfür die DK (ε) und den Verlustwinkel (δ) die sehr g Näherung:

$$\begin{split} \varepsilon &= 1 - \frac{\varDelta l_b}{d} \;, \\ \mathrm{tg} \; \delta &= \frac{2\pi \varepsilon}{m_b} \cdot \frac{d}{\lambda} \,. \end{split}$$

Hierin bedeutet Δl_b die Knotenverschiebung, m_b wellenverhältnis und d die Dieke der zu messend Schicht

Zur Messung selbst wurde die auf ein ²/₁₀₀ n dickes Glimmerplättchen aufgedampfte Schicht in d Spannungsbauch einer Meßleitung gebracht und i Differenz der Minimumdistanzen zum Objekt (Probei Messung mit bzw. ohne Objekt für die Bestimmu der DK ausgewertet. Der Verlustwinkel ergab si aus der Knotenbreite im Leerlauf der Probenleitung

Die Messungen wurden mit einer handelsüblich Meßleitung der Firma Rohde & Schwarz (Nr. B

* Meßspannung 20 V.

¹ Es liegt nahe, diese Regelmäßigkeit zu verwerten.

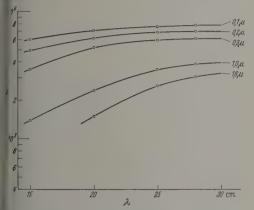
² Die der jeweiligen Schichtdicke entsprechende Durchschlaggleichspannung ist wesentlich höher.

³ In einem Falle war die Durchschlagfestigkeit einer Schic mit verkupferter Al-Elektrode sogar eine Größenordnu höher als diejenige einer Schicht mit Ag-Elektrode.

5/60) durchgeführt. Diese hat einen Wellenwiderd von 60 Ω. Die nötige Hochfrequenzenergie rten Sender der gleichen Firma mit sorgfältig ilisierten Netzgeräten, die eine hohe Amplituden-Frequenzkonstanz gewährleisteten.

Besondere Sorgfalt erforderte die Einführung der proben in die Meßleitung. Die Schwierigkeit lag in, einerseits Luftspalte und mangelhaften Kontakt schen Innenleiter, Außenleiter und Probe zu verden, andererseits aber die Probe vor Deformation bewahren, um die Forderung nach einer wirklich ben Meßprobe zu erfüllen. Alle Kontaktstellen en versilbert.

Die Meßergebnisse sind in Abb. 6 wiedergegeben. er Meßpunkt ist der Mittelwert aus Messungen an



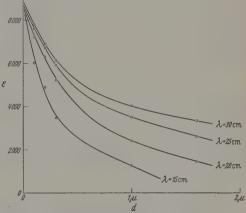
Frequenz- und Schichtdickenabhängigkeit der DK im elektrischen aufgedampfter Barium-Strontiumstitanatschichten (BS 73) bei Zimmertemperatur

10 Schichten. Als Parameter ist rechts oben die eilige Schichtdicke in µ aufgetragen. Bemerkensrt ist hier die Zunahme der Frequenzabhängigkeit DK mit wachsender Schichtdicke, die darauf hinist, daß sich die Struktur dickerer Schichten von jenigen dünnerer unterscheidet. Die im Gegensatz DK dünner Schichten wesentlich kleinere DK läßt muten, daß gewisse Restspannungen im Material stehen, die eine beschränkte elektrische Beweglicht des Materials zur Folge haben. Diese Vermutung d unter anderem durch eine weitere Eigenschaft lkerer Schichten ab 1,2 μ gestützt: Sie ändern zum lil nach einer Versuchszeit von 8 bis 10 Tagen ihre I sprunghaft. Die Wirkungsweise dieses irreverlen Alterungsprozesses konnte im einzelnen noch ht geklärt werden. Es liegt die Vermutung nahe, ß sich die Schichtstruktur außerhalb eines zur hichtenherstellung benötigten Feldes im labilen eichgewicht der Domänenkräfte befindet. Die Wahrneinlichkeit für die Bildung von Fehlstellen während s Aufdampfprozesses ist bei dicken Schichten viel ißer als bei dünnen. Infolgedessen enthalten dickere hichten viele Stellen, an denen die inneren Kräfte r spärlich kompensiert sind. Diese Fehlstellen den höchstwahrscheinlich die Ausgangspunkte für s Zusammenbrechen der labilen Domänenordnung. le einsetzenden Wandverschiebungen, verursacht rch geringe äußere Energie (z.B. Leitungsfeld), rden zum Stillstand gebracht, sobald eine Komnsation der inneren Kräfte erreicht ist. Dieser

Prozeß kann bei dickeren Schichten unter Umständen völlige Umordnung der Schichtstruktur mit sich bringen.

An dünnen Schichten konnten solche unstetigen Alterungsprozesse nicht beobachtet werden. Ihre DK blieb monatelang konstant und fiel selbst nach einem halben Jahr nur unmerklich ab.

Die Schichtdickenabhängigkeit der DK ist in Abb. 7 wiedergegeben. Die DK wird wie oben gezeigt mit abnehmender Schichtdicke größer, frequenzunabhängiger und strebt einem Grenzwert ($\varepsilon \rightarrow 9000$) zu. Man gewinnt den Eindruck, daß nur sehr dünne Schichten eine Abkühlung im Felde überstehen ohne innere Spannungen durch Fehlstellen zu erleiden. Die Fehler bei der Messung der DK lassen sich zurück-



Schichtdickenabhängigkeit der DK von Barium-Strontium-titanatschichten (BS 73) bei Zimmertemperatur

führen auf ungenaue Bestimmungen der Minimumsdistanzen und Schichtdicken; sie betragen etwa 15%, Selbstverständlich hängt die erzielbare Meßgenauigkeit auch von der Homogenität der Schicht und Konstanz der Schichtdicke innerhalb der Meßfläche ab. Die durch diese Größen entstehenden Fehler waren vernachlässigbar, da die Schwankungen der Schichtdicke durch das Herstellungsverfahren äußerst klein gehalten werden konnten. Das gleiche gilt für die Homogenität der Schichten.

Herrn Professor Dr. Lochte-Holtgreven danke ich für stete Förderung und für sein dauerndes Interesse an der Arbeit.

Für die Überlassung der Bedampfungsapparatur sei der Deutschen Forschungsgemeinschaft an dieser Stelle besonderer Dank ausgesprochen.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, die bisher technisch nicht durchführbare Züchtung des ferroelektrischen Barium-Strontiumtitanat-Einkristalls aus einer Schmelze durch eine Züchtung aus der Gasphase zu erreichen. Nach Entwicklung von zwei Verdampfungsvorrichtungen für Barium-Strontiumtitanat werden Bedampfungen hauptsächlich im elektrischen Feld durchgeführt. Die bei einer einstellbaren Kondensationstemperatur von etwa 200° C erhaltenen Einkristalle mit ausgerichteten Domänen werden näher untersucht. Bemerkenswert ist die Schichtdickenabhängigkeit der Dielektrizitätskonstante, die mit,

abnehmender Schichtdicke im Frequenzbereich 1000 bis 2000 MHz einem Grenzwert $\varepsilon \rightarrow 9000$ zustrebt. Nur bei dickeren Schichten wurde ein unstetiger Alterungsprozeß beobachtet, der auf die bei dickeren Schichten zahlreicher vertretenen Fehlstellen und die dadurch verursachten Verschiebungen der Domänenwände zurückgeführt wird.

Die Durchschlagfestigkeit der Schichten erreicht maximal den Wert $5 \cdot 10^5 \text{ V/cm}$.

Literatur: [1] Salomon, A.N., and E. Wainer: Titanium Alloy Manufacturing Co., Elect. Rep. 8 (1942), 9 and 10

(1943). — [2] Tiza, L.: Phys. Rev. 70, 954 (1946); 72, (1947). — [3] Megaw, H.: Proc. Roy. Soc. Lond., Ser. A 189 (1947). — [4] Hippel, A. v.: Rev. Mod. Phys. 22, 221 (1950 [5] Meez, W.: Phys. Rev. 76, (2), 1221 (1949). — [6] Bl. Ner, H., W. Känzig u. W. Merz: Helv. phys. Acta 22 (1949). — [7] Merz, W. J.: Proc. Amer. Phys. Soc. 25, N 36 (1950). — [7a] Rushman, D. F., and M. A. Strivens: Traraday Soc. A 42, 231 (1946). — [8] Davis, L.: J. A. Phys. 24, 1194 (1953). — [9] König, H.: Reichsber. Phy 4 (1944). — [10] Blattner, H., B. Matthias, W. J. Mer P. Scherrer: Experimenta 3, 4 (1947). — [11] Esau, A. D. Prösdorf: Naturwiss. 9, 208 (1954).

Dr. ALEXANDER MOLL, Institut für Experimentalphysik der Universität Kr

Zur Wirkungsweise des n-p-n-Phototransistors

Von Arnulf Hoffmann

Mit 4 Textabbildungen (Eingegangen am 12. Juli 1958)

I. Einleitung

Unter Photo,,transistor" verstehen wir ein Halbleiterbauelement, das im Gegensatz zur Photo,,diode" nicht aus zwei, sondern aus drei Schichten besteht, also einen Emitter-, einen Basis- und einen Collectorbereich enthält¹. Da bisher eine Theorie des Phototransistors² fehlt, beschränken sich auch die Erklärungen seiner Wirkungsweise im allgemeinen auf recht pauschale Betrachtungen [2].

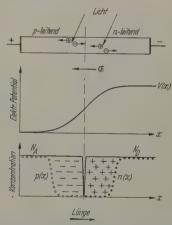


Abb. 1. Zur Deutung des p-n-Photoeffektes; p-n-Kristall (oben), Potentialverlauf (Mitte) und Konzentrationsverteilung (unten). Die durch Licht erzeugten Trägerpaare werden im elektrischen Feld getrennt und in verschiedene Richtungen getrieben

Zu einer einfachen und befriedigenden, allerdings auch nur qualitativen Deutung kommt man, wenn man den Phototransistor zunächst auftrennt in z Bauelemente, nämlich in eine Photodiode und einen normalen Transistor und beide parallel schal (Abb. 3)3. Bei weiteren Diskussionen zeigte es si nun, daß man merkwürdigerweise das lichtelektrisc wirksame Element sowohl zwischen Collector u Basis wie zwischen Basis und Emitter anschließ kann; in beiden Fällen kommt man zu einer V stärkung des primären Photostromes (vgl. Abs. II Die Betrachtung und der Vergleich beider Ersa bilder ist insofern interessant, als der eine Fall ein Ausleuchtung des p-n-Überganges am Collector, d andere einer Ausleuchtung nur des emitterseitig p-n-Überganges entspricht. Die hierbei auftretend Unterschiede ergeben Hinweise, ob und in welche Maße man die eine oder andere der beiden Raw ladungsschichten bei der Ausleuchtung bevorzug müßte.

II. Der Photoeffekt an einer p-n-Schicht

Zum besseren Verständnis wollen wir noch ku auf den einfachen p-n-Photoeffekt eingehen; wir folg hierbei im wesentlichen der von K. Lehovec gegebenen Erklärung4. Lichtquanten ausreichend Energie können Elektronen-Loch-Paare im Halbleit erzeugen, indem sie Valenzelektronen ins Leitung band anheben. Erfolgt die Paarbildung innerha der Raumladungszone, so werden die Paare in übe wiegendem Maße vom elektrischen Feld getren bevor sie wieder rekombinieren (Abb. 1). Aber au diejenigen Trägerpaare, die in den feldfreien Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft des p-n-Übergang erzeugt werden, tragen zum Photoeffekt bei, in de Maße nämlich wie die jeweiligen Minoritätsträg durch Diffusion bis zur Raumladungszone gelange dort vom Potentialgefälle erfaßt und auf die ande Seite des p-n-Überganges geführt werden. Wie Abb zeigt, ist das Raumladungsfeld der p-n-Schicht gera so gerichtet, daß p-Teilchen ins p-Gebiet, n-Teilch

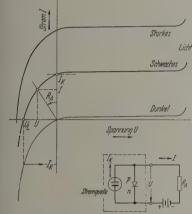
¹ N. Shive und P. Zuk [5] gebrauchen schon für die einfache p-n-Photodiode die Bezeichnung Phototransistor, offenbar um auf die Steuerung durch das Licht hinzuweisen. Eine echte Verstärkung des primären Photostromes erfolgt jedoch erst in der Drei-Schichtanordnung, weshalb wir die Bezeichnung Phototransistor auf diese Anordnung beschränken wollen.

² Hinweise findet man allerdings bei W. Shockley u. Mitarb. [1]. Im Gegensatz dazu ist der einfache p-n-Photoeffekt sehr viel eingehender behandelt worden, s. beispielsweise [4].

³ Diesen Hinweis verdanke ich Herrn R. Emeis.

⁴ Eine zusammenfassende Darstellung des *p.n*-Phot effektes einschließlich der Theorie findet man bei R. WII NER [4].

Die Photostromkennlinie versteht man am besten u einem Ersatzschaltbild, das in erster Näherung wh eine Stromquelle mit der Ergiebigkeit I_K und in Stelle einer ohmschen inneren Ableitung — wh einen parallelliegenden p-n-Gleichrichter darget twerden kann (s. Abb. 2). Bei fehlender Belichung verschwindet die Stromergiebigkeit ($I_K = 0$) und



1.2. Oben: Kennlinien einer p-n-Schicht. 1. — als Gleichrichter enüber der üblichen Darstellung um 180° gedreht). 2. — bei ehtung verschiebt sich die Kurve um den Strom I_K Unten: Schaltung mit Ersatzbild der Photo-p-n-Schicht

n erhält für den Strom I=f(U) die normale Kenne des p-n-Gleichrichters (in der Abb. 2 dünn austogene Kurve; gegenüber der üblichen Darstellung erdings um 180° gedreht). Durch das einfallende aht wird die Einströmung I_K erzeugt, die sich dem handenen Strom einfach überlagert¹. Die Photomkennlinie (stärker ausgezogen) ist daher um den ten Betrag I_K gegenüber der Gleichrichtercharaktistik verschoben. Die Ergiebigkeit I_K wächst mit tigender Lichtintensität.

Im Kurzschluβfall ($R_A=0$) wird an den äußeren emmen die Spannung U=0 erzwungen; die "innere sleitung" (der p-n-Gleichrichter) ist dann hochohmig genüber dem äußeren Kurzschluß und die volle giebigkeit der Quelle I_K fließt über den Außenkreis. er Zustand der p-n-Schicht wird im Kennlinienfeld r Abb. 2 durch den Punkt $I=I_K$, U=0 repräsent. Man sieht, daß die Ergiebigkeit I_K mit dem Kurzschlußstrom" identisch ist.

Im Leerlauffall $(R_A = \infty)$ wird im äußeren Stromsis der Strom I = 0 erzwungen. Die lichtelektrisch zeugte Einströmung I_K kann nur über die parallelschaltete "innere Ableitung", d.h. über den in urchlaßrichtung gepolten p-n-Gleichrichter zurückseßen. An den Klemmen tritt die Leerlaufspannung

 U_L auf. Der Zustand der p-n-Schicht wird im Kennlinienfeld der Abb. 2 durch den Punkt I=0, $U=U_L$ repräsentiert. Man sieht, daß wegen der vertikalen Parallelverschiebung der Gleichrichterkennlinie I=f(U) die Leerlaufspannung U_L und der Kurzschlußstrom I_K durch dieselbe funktionale Beziehung:

$$I_K = f(U_L) \tag{1}$$

miteinander verknüpft sind.

Rein schaltungsmäßig unterscheidet man häufig noch zwischen "Photoelement" und "Photodiode" je nachdem, ob man ohne Hilfsspannung im äußeren Kreis arbeitet oder ob man die $p\text{-}n\text{-}\mathrm{Schicht}$ in Sperrichtung vorspannt (vgl. hierzu Abb. 2: Kennlinien des Photoelements links im 2. Quadranten zwischen (0, I_K) und $(U_L,0)$; Kennlinien der Photodiode rechts im 1. Quadranten. Die Quellenergiebigkeit I_K erhöht sich bei der Photodiode noch um den Sperrstrom $I_{\mathrm{sp}}(U)$, der bei fehlender Belichtung schon als "Dunkelstrom" fließt.

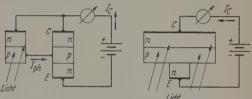


Abb. 3. Photodiode und Transistor als Ersatzbild (links) für einen Phototransistor (rechts), dessen Collectorseite allein belichtet wird

III. Phototransistor

Zur Erklärung des Phototransistors trennt man ihn zweckmäßigerweise gedanklich in ein Photoelement und in einen gewöhnlichen Transistor auf. Der im Photoelement erzeugte Photostrom $I_{\rm Ph}$ wird zur Steuerung des abgetrennten Transistors benutzt. Hierbei sind zwei verschiedene Ersatzbilder möglich:

a) p-n-Photoelement parallel zu Basis und Collector (Abb. 3)

Es liegt dann der größte Teil der äußeren Spannung an der lichtelektrischen p-n-Schicht und spannt diese in Sperrichtung vor. Das Element wird als Photodiode betrieben. Bei Belichtung fließt ein (positiver) 2 Photostrom $I_{\rm Ph}$ von der Diode in die Basis des Transistors und nimmt den Weg zur negativen Batterieklemme über den emitterseitigen p-n-Ubergang; die positive Einströmung löst nun umgekehrt eine Elektroneninjektion des Emitters aus, die zu einem Collectorstrom $\alpha^*I_{\rm Ph}$ führt (Transistoreffekt) 3 . Im Lastkreis gewinnt man insgesamt also den Strom

$$I_C = (\alpha^* + 1) I_{\text{Ph}}.$$
 (2)

b) p-n-Photoelement parallel zu Basis und Emitter (Abb. 4)

Auch hier fließt in die Basis ein positiver Photostrom der den Transistor "öffnet", so daß man im Außenkreis den verstärkten Strom

$$I_C = \alpha^* I_{\text{Ph}}$$
 (3)

¹ Es wird mit der Annahme gearbeitet, daß sich lichtktrisch erzeugte Strömung und Stromanteil des p.n-Gleichhters unabhängig voneinander superponieren; diese Anhme ist nur in gewissen Grenzen erlaubt.

² Hier und im folgenden wird auf die Polung der n-p-n-Schichtung der Abbildungen Bezug genommen. Sinngemäß lassen sich alle Überlegungen natürlich auf p-n-p-Strukturen übertragen.

³ α* = Stromverstärkungsfaktor in Emitterschaltung.

Der Vergleich von (2) und (3) läßt bei flüchtiger Betrachtung beide Ersatzschaltungen annähernd gleichwertig erscheinen. Tatsächlich unterscheiden sich jedoch die Ströme I_{Ph} auf der rechten Seite der Gl. (2) und (3) wertmäßig ganz wesentlich voneinander. Im Fall der Abb. 3 ist der steuernde Photostrom etwa dem Kurzschlußstrom I_K gleichzusetzen (vgl. Kennlinie im 1. Quadrant der Abb. 2). Im Gegensatz dazu arbeitet das Photoelement der Abb. 4 gegen eine äußere Spannung, nämlich gegen die am Emitter des Transistors liegende Spannung U_{BE} . Diese schwächt den Photostrom, d.h. der Arbeitspunkt auf der Kennlinie (Abb. 2 im zweiten Quadranten) rückt nach links zu kleineren Strömen hin. Die Höhe der sich einstellenden Gegenspannung richtet sich nun aber nach dem gesamten Emitterstrom $I_E = I_{Ph} + I_C$ (d.h. nach Basis-

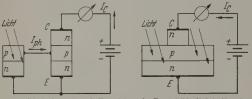


Abb. 4. Photoelement und Transistor als Ersatzbild (links) für einen Phototransistor (rechts), dessen Emitterseite allein belichtet wird

und Collectorstrom). Für eine genauere Abschätzung müssen wir hier, da der p-n-Übergang (Abb. 4) ja nur gedanklich in einen lichtbestrahlten und in einen Emitter-Teil getrennt wurde, mit gleichen Eigenschaften der beiden p-n-Strukturen rechnen. Dann gilt aber auch für den p-n-Übergang des Emitters dieselbe Stromspannungsbeziehung

$$I = f(U), (4)$$

die wir schon in Gl. (1) für das Photoelement benutzt haben. Bei einem Emitterstrom von der Größe I_K würde also die Spannung U_{BE} , gegen die das Photoelement arbeitet, gerade U_L betragen und der Photostrom $I_{\rm Ph}$ wäre völlig unterdrückt (Leerlauffall). Im Transistor ließe sich ein Emitterstrom I_K mit verschwindendem Basisstrom nur bei unendlich hoher Stromverstärkung α^* realisieren. Bei α^* -Werten von 50 bis 100 wird man sich jedoch dem Leerlauffall weitgehend nähern; d.h. der steuernde Photostrom $I_{\rm Ph}$ bleibt klein gegen den Kurzschlußwert und erst der verstärkte Gesamtstrom I_E erreicht beinahe I_K .

In den zwei Ersatzbildern gewinnt man durch Zusammenfügen der nebeneinanderliegenden p- und n-leitenden Bereiche den Phototransistor als Einheit (rechter Teil der Abb. 3 und 4). In beiden Fällen wird der primäre Photostrom richtig verstärkt, insbesondere liegt in beiden Fällen entsprechend der positiven Einströmung eine Potentialanhebung der Basis gegenüber dem Emitter vor, die häufig zur Erklärung des Phototransistors herangezogen wird. Quantitativ ergibt sich dagegen ein deutlicher Unterschied: Die Ausleuchtung der collectorseitigen p-n-Schicht (einschließlich ihrer Nachbarbereiche) ist wesentlich wirkungsvoller als die der emitterseitigen.

Man kann diesen Unterschied (grob) auch durch die beiden Grenzfälle des p-n-Photoelements erklären. Bei Belichtung der collectorseitigen p-n-Schicht (Abb.3) wird das Element über die "durchlässige" EmitterSperrschicht mit der Batterie "kurz"-geschloss $(R_A \rightarrow 0)$, d. h. die volle lichtelektrische Ergiebigkeit wird am Emitter zur Steuerung des n-p-n-Transist wirksam. Im anderen Fall (Abb. 4) wird die belietete p-n-Schicht des Emitters dagegen über die "sprende" Collectorrandschicht an den äußeren Krgelegt $(R_A \rightarrow \infty)$. Hier nähert man sich dem Le lauffall, d. h. die Spannung zwischen Basis und Emitt muß $\leq U_L$ bleiben, und der über diesen p-n-Übgang fließende Strom I_E kann somit nach der schoben gegebenen Erklärung nicht über I_K anwachse Im ersten Fall darf man daher am Collector ein Strom von der Größe α^*I_K im zweiten dagegen nannähernd I_K erwarten 1.

IV. Experimentelle Bestätigung

Um die obigen Überlegungen zu stützen, wurde einige Messungen in den Ersatzschaltungen der Abb. und 4 durchgeführt¹. Wir benutzten ein Siliziur Photoelement und einen Si-Transistor bei 6 V Colectorspannung; gemessen wurde der Strom I_{CE} b verschieden starker Belichtung (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1

Belichtung	Abb. 3 Photodiode am Collector	Abb. 4 Photoelement zwischen Emitter und Basis	Kurzschluß- strom I _K des Photoelement	
	mA	mA	mA	
Dunkel Schwach Hell	2,9 47,2 83,7	0,003 0,68 1,17	0,83 1,4	

Mit diesen Werten werden, wie wir glauben, de obigen Überlegungen recht gut bestätigt.

Zusammenfassung

Eine recht einfache Erklärung des Phototransistor ergibt sich durch Auftrennung in zwei Bauelement nämlich in einen normalen Transistor und in ein Photodiode, die parallel zur Collector-Basisstreck liegt. Schaltet man die Photodiode parallel zur Basis Emitterstrecke des Transistors, so kommt man schei bar ebenfalls zu einer richtigen Deutung. Eine ge nauere Betrachtung zeigt jedoch, daß man nur ir ersten Fall eine echte Verstärkung des primäre. Photostromes erhält. Diese Überlegungen werdel durch einige Messungen bestätigt.

Für Diskussionen möchte ich den Herren R. EMEIS A. HERLET und E. SPENKE herzlich danken.

Literatur: [1] SHOCKLEY, W., M. SPARKS and G. T. TEAL Phys. Rev. 83, 157 (1951). — [2] Wiesner, R.: Radio Mento. 21, 630 (1955). — Dosse, J.: Der Transistor, S. 67. München R. Oldenbourg 1957. — [3] LeHOVEC, K.: Z. Naturforsch 1a, 258 (1946). — [4] Wiesner, R.: In W. Schottky, Halb leiterprobleme, Bd. III, S. 859—874. Braunschweig: F. Vieweg & Sohn 1956. — [5] SHIVE, N., and P. ZUK: Bell Labor Rec. 33, 445 (1955). — [6] SHIVE, N.: Bell Labor. Rec. 28 337 (1950).

Dr. Arnulf Hoffmann, Siemens-Schuckert-Werke AG. Laboratorium Pretzfeld i. Ofr.

diesen Messungen danken.

 $^{^1}$ Dem Stromunterschied entsprechend wächst im erstel Fall auch die Basis-Emitterspannung über U_L an; sie wir von der treibenden äußeren Batterie-Spannung geliefert. 2 Herrn H. Benda möchte ich für seine Unterstützung be

Eine Prüfapparatur für Photohalbleiter

Von REINHARD GERETH und HELMUT A. MUSER

Mit 9 Textabbildungen

(Eingegangen am 16. April 1958)

Einleitung

Photowiderstände als Strahlungsempfänger werden tisch immer in Wechsellichtanordnung verwendet. ei entsteht an einem mit dem Photowiderstand in de geschalteten Arbeitswiderstand ein Wechselnungssignal.

Maßgebend für die Güte eines Photowiderstandes in erster Linie die Empfindlichkeit (Größe des egebenen Signals bei gegebener Bestrahlungsung¹), die spektrale Verteilung der Empfindlichund die kleinste nachweisbare Strahlungsleistung. erdem interessiert die Proportionalität des Sis zur eingestrahlten Leistung (Intensitätsproporalität) und zur angelegten Spannung (Ohmsches nalten), sowie die Abhängigkeit des Signals von der ulationsfrequenz der Belichtung. Um die besten ingungen für den Nachweis einer möglichst kleinen hlungsleistung zu ermitteln, muß die günstigste enspannung und Modulationsfrequenz bekannt . Das schließt die Notwendigkeit ein, die Abhäneit des Halbleiterrauschens von der Zellenspang und das Frequenzspektrum des Rauschens zu

im folgenden wird eine Apparatur beschrieben, die estattet, die Daten eines Photowiderstandes und e günstigsten Betriebsbedingungen in einfacher se zu bestimmen. Das Hauptproblem besteht n, das Rauschen des Photowiderstandes soweit wie lich zu unterdrücken. Es wird durch Verwendung sphasenempfindlichen Gleichrichters gelöst.

1. Zur Theorie

Die Theorie des inneren Photoeffektes in ihrer einsten Form nimmt an, daß in dem Photowiderstand ih Belichtung zusätzliche Leitungsträger erzeugt den, die nach Ablauf einer mittleren Lebensdauer τ ler in den gebundenen Zustand zurückkehren. Bei τ Wechselbelichtung der Amplitude L und der isfrequenz ω wird nach Schönwald [1] die Größe Signals dem Faktor $L\tau/\sqrt{1+\omega^2\tau^2}$ und der angten Spannung proportional. Danach sollte das all solange unabhängig von der Belichtungsuenz sein, wie $\omega \ll 1/\tau$ ist, und für größere Belichtsfrequenzen proportional zu $1/\omega$ abfallen. Vorausing ist dabei, daß τ groß gegenüber der Zeitstanten RC des Meßkreises ist.

Das Rauschen besteht aus zwei Anteilen: dem uist-Rauschen und dem Stromrauschen. Das uist-Rauschen ist von der Zellenspannung unabzig, das Stromrauschen dagegen der Zellenspan-

Bei einer exakten Definition der Empfindlichkeit muß günstigste Arbeitsbedingungen voraussetzen und auf linearen Zusammenhang zwischen Signal und Bestrahsleistung extrapolieren. nung proportional. GISOLF [2] gibt für den Effektivwert des Stromrauschens folgende Formel an:

$$I_{\mathrm{eff}}^{2}(f) = rac{e\,\mu\,F^{2}\, au}{R}\int\limits_{f}^{f+\Delta f}\!\!\!\left(rac{\sin\,\pi\,f\, au}{\pi\,f\, au}
ight)^{\!2}df$$

(e= Elementarladung, $\mu=$ Beweglichkeit, F= Feldstärke, $\tau=$ Lebensdauer, R= Widerstand des Halbleiters, $\Delta f=$ Bandbreite der Meßanordnung).

Für niedrige Frequenzen ($f\tau \ll 1$) wird das Integral gleich der Bandbreite Δf , und in dieser Näherung ist

$$I_{\mathrm{eff}}^{2}(f) = \frac{e \,\mu \, F^{2} \,\tau}{R} \,\Delta f.$$

Für Frequenzen $f>1/\tau$ erhält man für den Effektivwert des Rauschstromes einen Abfall mit 1/f. Der Zusammenhang zwischen Rauschstrom und Rauschfrequenz ist also ganz ähnlich wie der Zusammenhang zwischen Signal und Belichtungsfrequenz.

Aus dieser einfachen Theorie lassen sich folgende Regeln für das Arbeiten mit Photowiderständen ableiten:

- Man arbeite mit so großer Zellenspannung, daß das Stromrauschen groß gegen das Nyquist-Rauschen wird. Eine weitere Steigerung der Zellenspannung bringt keinen Vorteil mehr, weil dann Signal und Rauschen spannungsproportional ansteigen, ihr Verhältnis sich also nicht weiter verbessert.
- 2. Man sollte das Signal mit einem Verstärker von möglichst geringer Bandbreite verstärken, damit alle die Anteile des Rauschens unterdrückt werden, die nicht die Belichtungsfrequenz ω haben.
- 3. Die Belichtungsfrequenz sollte beliebig sein, da Signal und Rauschen den gleichen Frequenzgang zeigen.

Die genannten Folgerungen liefern wertvolle Richtlinien für das praktische Arbeiten mit Photowiderständen; doch können die Abweichungen von der einfachen Theorie so groß sein, daß sie für die Praxis nicht zu vernachlässigen sind. Diese Abweichungen können folgende Auswirkungen haben:

1. Wenn das Widerstandsverhalten merklich von Übergangswiderständen (zwischen den Halbleiterkörnern einer polykristallinen Schicht oder zwischen Halbleiter und Zuführungselektrode) bestimmt wird, ist das Signal nicht mehr spannungsproportional;

2. bei starker Bestrahlung ist das Signal nicht intensitätsproportional (stark ist jede Bestrahlung, bei der der Photostrom nicht klein gegen den Dunkelstrom ist);

3. die Beschreibung der Rekombinationsvorgänge durch eine einzige Zeitkonstante τ ist im allgemeinen zu einfach; dadurch gehen die Frequenzgänge von Rauschen und Signal nicht mehr parallel;

4. sobald Effekte durch Erwärmung auftreten, wächst das Rauschen stärker als spannungspropor-

28b

tional. Aus diesen Gründen kann man die Leistungsgrenze eines Photowiderstandes nur experimentell ermitteln.

Die kleinste nachweisbare Strahlungsleistung ist abhängig von der spektralen Empfindlichkeit des Photowiderstandes, ist also je nach der eingestrahlten Wellenlänge verschieden groß. Um zu einer von der Wellenlänge unabhängigen Angabe zu kommen, liegt es für die ultrarotempfindlichen Photohalbleiter (vor allem PbS, PbSe, PbTe) nahe, die Strahlung des Schwarzen Körpers einer durch Konvention festzulegenden Temperatur als Standardverteilung anzusehen und die kleinste nachweisbare Leistung darauf zu beziehen. So kommt man zur Definition des Schwellwertes S, das ist diejenige Strahlungsleistung eines

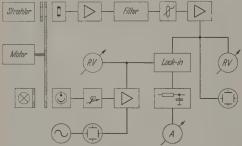


Abb. 1. Blockschaltbild der Meßanordnung

Schwarzen Körpers von 500° K, die am Anzeigeinstrument den gleichen Ausschlag erzeugt wie die Quadratwurzel aus dem mittleren Schwankungsquadrat des Zellenrauschens. Dieses mittlere Schwankungsquadrat ist proportional der Bandbreite Δf der benutzten Meßanordnung; daher wird $S \sim \sqrt{\Delta f}$. Durch Einengen der Bandbreite kann man zwar das Rauschen unterdrücken, doch verlängert man damit die Meßzeit t_M , die dem reziproken Wert der Bandbreite Δf proportional ist. Nach DAHLKE und HETINER [3] ist aber das Produkt $S \sqrt{t_M}$ für die Leistungsfähigkeit eines Strahlungsempfängers maßgebend. Die charakteristische Größe $S \sqrt{t_M}$ oder $S / \sqrt{\Delta f}$ ist ein von der speziellen Meßanordnung unabhängiger, die Güte des Photowiderstandes kennzeichnender Wert.

Der Vorteil der Definition des Schwellwertes liegt darin, daß man nur einen festen Wert und nicht eine spektrale Verteilungskurve zur Charakterisierung eines Photowiderstandes angeben muß; ihr Nachteil ist die Willkür in der Wahl der Temperatur des Schwarzen Körpers.

2. Meßanordnung

Um die störenden Rauschspannungen zu unterdrücken, wird ein sog. "phasenempfindlicher Gleichrichter" (im angelsächsischen Schrifttum "Lock-in" genannt) verwendet. Das Prinzip besteht darin, das Gemisch von Rauschspannungen und Signal mit einer "Referenzspannung" zu überlagern, die nach Frequenz und Phasenlage genau mit dem Signal übereinstimmt, und die so entstehenden Spannungen einem Gleichstrominstrument zuzuführen. Diese Spannungen enthalten eine Gleichkomponente und störende niederfrequente Wechselkomponenten. Die Gleichkomponente wird von denjenigen Anteilen des Signal-Rausch-Gemisches gespeist, die mit der Referenzspannung in

der Frequenz übereinstimmen und eine konstal Phasenlage zu ihr haben. Die Störspannungen ogegen stammen von den Komponenten des Rausche welche nahezu die Signalfrequenz besitzen. "Nahez gleich der Signalfrequenz ist dabei eine Frequenz, weniger als die reziproke Zeitkonstante des Gleistrominstruments von der Signalfrequenz abweid Indem man die Trägheit des Gleichstrominstrume vergrößert, läßt sich (auf Kosten der Einstellzeit, der Meßzeit) das Rauschen beliebig unterdrück (s. Meinke-Gundlach [4]).

Die in der Literatur (z.B. [5], [6]) beschrieben Schaltungen für phasenempfindliche Gleichrich arbeiten meist bei einer bestimmten Frequenz od in einem engen Frequenzbereich. Für den vorliegend Anwendungszweck mußte jedoch ein weiter Frequer bereich zu überstreichen sein. Daher wurde in unsere Lock-in das Prinzip der multiplikativen Mischung d

beiden Spannungen angewandt.

Abb. I zeigt die Meßanordnung im Blockscha bild. Dabei ist als Beispiel an einen ultrarotempfin lichen Photowiderstand gedacht; die Strahlungsque

ist ein Schwarzer Körper.

Dieser Schwarze Körper besteht aus einem hobitzebeständigen Edelstahlrohr¹ von 500 mm Läng 60 mm Durchmesser und 2 mm Wandstärke, das mim Dauerbetrieb bis zu 1000° C erhitzen kann. I wesentliche Querwand im Innern des Schwarz Körpers ist 285 mm von der Strahlenaustrittsöffnu entfernt. Sie ist 14 mm dick und mit ringförmig Rillen versehen, deren Flächennormale um 20° geg die Achse des Ofens geneigt ist, damit kein Fläche element senkrecht zur Achse steht. Die strahlen Öffnung des Schwarzen Körpers hat einen Durt messer von 28 mm. Auf sie folgen in Richtung auf Querwand 3 Blendenringe. Die Temperatur im Horaumstrahler wird mit Hilfe eines Pt-PtRh-Thern elementes gemessen.

Vor der strahlenden Öffnung des Schwarzen Kopers befindet sich ein Blendensystem. Es soll

- 1. die Erwärmung der Modulationsscheibe w hindern;
- 2. die Abkühlung des Schwarzen Körpers vimeiden, die durch starke Luftbewegung bei hoh Motordrehzahlen verursacht wird;
- 3. die Ofenstrahlung zu unterbrechen gestatten Abb. 2 zeigt, wie das erforderliche Blendensyste ausgeführt ist. Alle Blendenöffnungen sind so dime sioniert, daß die letzte Blende vor der Scheibe is Lichtmodulators die Strahlung begrenzt. Eine Kotrollmessung ergab, daß die Temperatur im Schwarz Körper mit vorgesetztem Blendensystem bis zu eine Abstand von 220 mm von der Querwand auf ±2

Unmittelbar vor der strahlenbegrenzenden Blen wird die Strahlung durch eine rotierende Lochschei moduliert. Diese wird durch einen Gleichstrom-Nebe schlußmotor angetrieben, dessen Drehzahl in eine weiten Bereich (etwa 40 ... 7000 Umdrehungen/Min te) regelbar ist. Die Scheibe hat einen Durchmess von 350 mm. Sie besteht aus 1,5 mm starkem Dural minium. Zur Versteifung wurden von beiden Seit nach außen konisch zulaufende Aluminiumflanso

konstant war.

¹ "Thermax 10 A" der Deutschen Edelstahlwerke, K feld, denen wir für die kostenlose Lieferung dieses Rohdanken.

mm Durchmeser) angebracht. Durch diese Kontion wurde erreicht, daß die Scheibe auch noch 7000 Umdrehungen pro Minute mechanische lität besitzt. Im Abstand von 160,5 mm von der enmitte sind 72 Schlitze (7×15 mm), um je 5° tzt, in die Scheibe eingefräst. Um die Strahlungssität sinusförmig modulieren zu können, wird ttelbar vor die Scheibe in der Höhe der Schlitze Sinusblende eingesteckt. Sie kann durch Blenden er Form ausgewechselt werden.

ie modulierte Strahlung fällt auf den zu unternden Photowiderstand. Mit ihm in Reihe liegt rbeitswiderstand R, der den Eingang des "Sianals" bildet (Abb. 1, oberer Pfad). Der Wider-R muß so klein sein, daß die unvermeidlichen tkapazitäten auch bei den höchsten Belichtungsenzen noch keinen merklichen Nebenschluß

as am Arbeitswiderstand abgegriffene Signal wird NF-Breitbandverstärker zugeführt. Es ist ein tufiger, RC-gekoppelter Verstärker mit einer breite von 1 Hz bis 210 kHz bei einer maximalen ärkung von 6 · 104, die in vier Stufen je 1:10 enzunabhängig untersetzt werden kann. angsstufe des Verstärkers wird mit Unterspanen betrieben, um den Funkel-Effekt herabzu-1. Damit der Verstärker unempfindlich gegen anische Erschütterungen ist, wurden alle Röhren inen Dunloprenesockel gesetzt. Dunloprene ist unststoff, der nach einer erlittenen Deformation odisch in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. eßlich wurde der Verstärker noch in einen mit oprene ausgeschlagenen Kasten gesetzt, damit

Mikrophonie auftritt. Das ist wichtig, weil den bei hohen Drehzahlen der Lochscheibe aufnden Pfeiftönen auch solche sind, welche die ne Frequenz besitzen wie das Meßsignal. Sie ten somit trotz anschließender phasenempfind-Gleichrichtung einen Fehlausschlag des Annstrumentes erzeugen.

inter dem NF-Verstärker folgt eine Kathodenzur Anpassung an die nachgeschalteten Terz-l. Diese Bandpässe in π -Schaltung dienen zur n Beschneidung des Frequenzbandes. ch von 50 Hz bis 11,4 kHz ist in 48 halbe Terzen teilt. Bei der Messung ist jeweils dasjenige Terzauszuwählen, dessen Bandmittenfrequenz am n mit der Signalfrequenz übereinstimmt. Auf Bandpässe folgt ein Präzisionsuntersetzer (Fehler) in Form einer Kathodenstufe. Durch ihn kann bsolutmessungen der Verstärkungsgrad der geen Anordnung meßbar auf den gewünschten eingestellt werden. Die Untersetzung geschieht in drei Stufen (1:1, 1:10, 1:100); jede Stufe für st noch einmal logarithmisch in 10 Stufen unter-

ie von dem Meßuntersetzer abgegebene Spanwird einem Nachverstärker² zugeführt. ärkungsgrad ist von $10^{-1} \dots 10^3$ in fünf Stufen 10 regelbar. Auf den Nachverstärker folgt wahl-

zur unmittelbaren Messung ein Röhrenvolt-3, wenn das Signal groß gegen die Störungen ist bei der Bestimmung des Frequenzganges), oder

B-25a, b, c der Firma Wandel & Goltermann, angepaßt $E = R_A = 600 \ \Omega.$

2. die Mischröhre des phasenempfindlichen Gleichrichters, wenn die Rauschspannungen unterdrückt werden müssen.

Parallel zu 1. oder 2. liegt zur visuellen Kontrolle des Signals ein Breitband-Oszillograph⁴.

Die zur Steuerung des phasenempfindlichen Gleichrichters nötige Wechselspannung ("Referenzspannung") wird von einer Vakuumphotozelle erzeugt. Sie erhält eine Wechselbelichtung von der beschriebenen rotierenden Scheibe in Verbindung mit einer Glühbirne (vgl. Abb. 1). Dadurch wird erreicht, daß Signal- und Referenzspannung stets die gleiche Frequenz haben. Um auch die richtige Phasenlage zu gewährleisten, sind Photozelle und zugehörige Lichtquelle diametral gegen das Meßobjekt versetzt auf

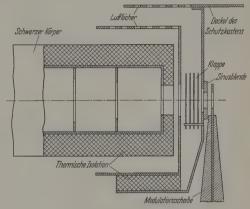


Abb. 2. Blendensystem des Schwarzen Körpers

einem Schlitten angeordnet, der durch eine Schraube auf einem Kreisbogen um die Motorachse als Mittelpunkt beweglich ist. Dieser mechanische Phasenschieber hat gegenüber einem elektronischen den Vorteil, daß man ohne großen Aufwand über den gesamten Frequenzbereich amplitudentreu und frequenzunabhängig die Phasenlage zwischen den zu überlagernden Spannungen verändern kann.

Die von der Vakuumphotozelle abgegebene Sinusspannung von etwa 0,1 Veff gelangt über den "Referenzkanal" zum phasenempfindlichen Gleichrichter. In Abb. 1 besteht dieser Kanal im direkten Pfad nur aus einem Verstärker. Die beiden Abzweigungen dienen zur Messung von Frequenz und Amplitude der Referenzspannung. Die Frequenz erhält man, indem man mit einem Bruchteil der Referenzspannung und der Spannung eines RC-Generators 5 auf einem Oszillographenschirm Lissajous-Figuren erzeugt. Die Amplitude wird mit einem Röhrenvoltmeter gemessen.

Abb. 3 zeigt den eigentlichen phasenempfindlichen Gleichrichter. Man erkennt, daß sich der Referenzkanal hinter dem in Abb. 1 gezeichneten Verstärker fortsetzt. Zunächst folgt eine Kathodenstufe, die eine frequenzunabhängige Regelung der Referenzspannungsamplitude ermöglicht. Durch einen Umschalter kann die Referenzspannung wahlweise statt von der

² Verstärker UBM der Firma Rohde & Schwarz, hier als Breitbandverstärker 45 Hz . . . 400 kHz verwendet.
³ URI von Rohde & Schwarz.

⁵ GM 2315 von Philips (20 Hz ... 20 kHz).

Photozelle direkt aus einem Generator bezogen werden. In diesem Sonderfall benötigt man einen elektronischen Phasenschieber; er ist im Normalfall (Betrieb mit Photozelle) ausgeschaltet, weil dann der mechanische Phasenschieber vorzuziehen ist. Der

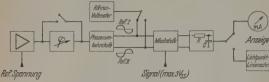


Abb. 3. Blockschaltbild der Lock-in-Anordnung

elektronische Phasenschieber besteht aus einer Phasenumkehrstufe, zwischen deren beiden Ausgängen ein RC-Glied liegt. Vom Mittelpunkt dieses frequenzabhängigen Spannungsteilers erhält man eine gegen Chassis asymmetrische Wechselspannung, deren Phasenschieber und der Phasenschieber Phasenschieber Phasenschieber Phasenschieber Phasenschieber Phasenschieber Phasenschieber besteht aus einer Phasenumkehrstufe, zwische Phasenschieber besteht aus einer Phasenumkehrstufe, zwische Phasenschieber Phasensch

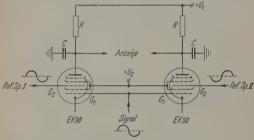


Abb. 4. Schaltung der Mischstufe

senlage durch R und C festgelegt wird. Wird der elektronische Phasenschieber abgeschaltet, so arbeitet die Phasenumkehrstufe als zweistufiger RC-gekoppelter Verstärker mit Stromgegenkopplung. Bei kleinen Eingangssignalen kann man diese Gegenkopplung

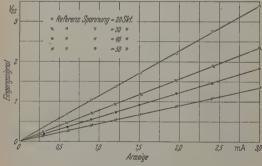


Abb. 5. Eichung des Lock-in

durch drei innere Steckkontakte aufheben und erhöht damit den Verstärkungsgrad jeder Stufe um den Faktor 4. Auf die Phasenschieberstufe folgt eine Phasenumkehrstufe, die die gegenphasigen Steuerspannungen (Ref. I und II in Abb. 3) für die Mischröhren liefert. Sie werden mit einem Röhrenvoltmeter gemessen. Der Verstärkungsgrad der Stufen von der Kathodenstufe bis zur Phasenumkehrstufe beträgt maximal 560 ohne und 56 mit Phasenschieber in einem Bereich von 20 Hz bis 15 kHz.

Signalkanal und Referenzkanal laufen in der Mischstufe zusammen, die das Kernstück des phasenempfindlichen Gleichrichters bildet. Sie besteht zwei Heptoden EK 90. Das Prinzip der Schalt zeigt Abb. 4. Das Signal bzw. das Signal-Rau. Gemisch wird über zwei Kathodenstufen (zur Ikopplung) den vorderen Steuergittern G_1 im Gletakt, die Referenzspannung den hinteren Steigittern G_2 im Gegentakt zugeführt. Die Phasen ist so, daß an der einen Mischröhre Signal- und Rrenzspannung in Phase, an der anderen um 180° schoben sind.

Setzt man Linearität der Kennlinien voraus — trifft bei der EK 90 bei geeigneter Wahl des Arbeipunktes für einen Aussteuerbereich von etwa 3 zu —, dann tritt bei der multiplikativen Mischtzweier Spannungen, die an die beiden Steuergit der Heptoden gelegt werden, in dem Anodenstr

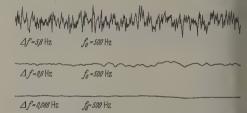


Abb. 6. Demonstration der Rauschunterdrückung durch eine Lock Anordnung (Ausschnitte aus Registrierungen von 50 sec Dauer)

neben den beiden Eingangswechselspannungen r
 noch ihr Produkt auf. Die Wechselspannungen werd durch die Kondensatoren C kurzgeschlossen; die a
 dem Produkt der Spannungen resultierende Gleic spannung tritt als Änderung des Spannungsabfalls:
 den Widerständen R auf. Wegen der Gegenphasigkt der Spannungen an den Gittern G_2 hat diese Änderun an den beiden Röhren das entgegengesetzte Vorzeichen. Das zwischen den Röhren liegende Gleic spannungsinstrument zeigt also das Doppelte dÄnderung an, die an einer Röhre erzeugt wird.

Dieses "Gleichspannungsinstrument" besteht a einer RC-Kombination, die als Tiefpaß mit varibler Zeitkonstante wirkt, einer Röhrenbrücke ut wahlweise einem Milliamperemeter (3 mA, 10 Ω) od einem Lichtpunkt-Linienschreiber¹. Der Tiefpaß if ür die Zeitkonstante der Anordnung maßgeben sie konnte durch Umschalten wahlweise auf 2, 4, und 30 sec eingestellt werden. Andere Zeitkonstant erhält man durch Zuschalten äußerer Kapazitäten millie der dafür vorgesehenen Buchsen. Die Röhre brücke besteht aus zwei als Kathodenstufe geschaltet Trioden, zwischen deren Kathoden das eigentliche Azeigeinstrument liegt. Diese Anordnung zeichnet sie durch große Nullpunktstabilität aus.

Abb. 5 zeigt die Eichgeraden der beschriebenen A ordnung mit der Referenzspannung (in Skalenteildes Röhrenvoltmeters) als Parameter. Die Abweichut von der Linearität ist etwa 2% des Vollausschlage Bei den Messungen wurde die Referenzspannungrundsätzlich auf 40 Skt. eingestellt.

Abb. 6 demonstriert die Wirksamkeit der Rause beschneidung durch den phasenempfindlichen Gleie richter. Es handelt sich dabei um Ausschnitte von drei Registrierkurven des Lichtpunkt-Linienschreibe

 1 RLt 4 N von Hartmann & Braun. Wir danken der Firm die das Gerät leihweise zur Verfügung stellte.

enen Durchlaßfrequenz fo und Eingangsrauschtude konstant blieben, während die Zeitkonstante iefpasses (hier umgerechnet auf "Bandbreite" der dnung) verändert wurde.

3. Beispiel einer Messung

ls Beispiel werden die an einer käuflichen PbS-61 SV (Philips) erhaltenen Meßwerte wiederben. Die Zelle hatte folgende Daten:

enster: Glas,

Virksame Oberfläche: 6×6 mm,

emperatur der Zelle: Zimmertemperatur, pektrale Empfindlichkeit: 0,3 bis 3 u.

Iaximum der spektralen Empfindlichkeit: 2,5 μ,

Ounkelwiderstand: 1,42 M Ω .

Abb. 7 zeigt die Ermittlung der günstigsten Zellennung. Längs der Abszisse ist die an der Zelle und mit ihr in Reihe geschalteten Arbeitswiderstand

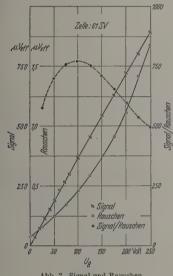


Abb. 7. Signal und Rauschen

 $\mathbf{k}\Omega$) liegende Batteriespannung U_B aufgetragen. der Messung der Rauschspannung wurde der owiderstand nicht belichtet. Die vom Lichtpunktenschreiber aufgezeichneten Rauschdiagramme len mit einem Planimeter¹ ausgewertet, das n dem Mittelwert des Kurvenzuges zugleich auch mittlere Schwankungsquadrat aufzeichnet.

Die Signalspannung wurde unter folgenden Beungen gemessen:

Selichtungsfrequenz (f): 800 Hz,

Sandbreite (Δf): Terzfilter: 712 ... 899 Hz; Lock-1: 0,6 Hz,

'emperatur der Zelle (t_0) : 24° C,

rbeitswiderstand (R): $500 \text{ k}\Omega$,

trahlungsquelle ($\overline{T_s}$): Schwarzer Körper von

00° K, Dichte der Strahlungsleistung am Ort des Emp-

ingers: $3.28 \,\mu\text{Watt/cm}^2$.

us der Abbildung ist zu sehen, daß die günstigste iebsspannung etwa 100 V beträgt.

Grund- und Quadrat-Linearplanimeter von A. Ott, oten.

Abb. 8 zeigt die Ermittlung der günstigsten Belichtungsfrequenz. Bei der Aufnahme des Rauschspektrums wurde der phasenempfindliche Gleichrichter durch einen RC-Generator² gesteuert. Die aus entnommene Batteriespannung von 100 V wurde bei dieser Messung angewandt; im übrigen waren die Meßbedingungen die gleichen wie oben. Als günstigste Belichtungsfrequenz ergibt sich 2 kHz. Wäre dieser Wert erheblich von der bei Abb. 7 benutzten Frequenz von 800 Hz verschieden, so hätte

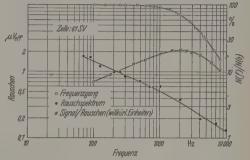


Abb. 8. Rauschspektrum und Frequenzgang

man diese Messung mit der (aus Abb. 8 ermittelten) Frequenz 2 kHz zu wiederholen.

Der Frequenzgang des Signals ist bei höheren Belichtungsfrequenzen durch den großen Arbeitswiderstand etwas verfälscht, wie Abb. 9 zeigt. Bei der dieser Abbildung zugrunde liegenden Messung wurde

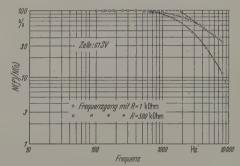


Abb. 9. Frequenzgang bei verschiedenen Arbeitswiderständen

mit einem großen Signal (Temperatur des Schwarzen Körpers 1143°K) die Abhängigkeit des Signals von der Belichtungsfrequenz (bei sonst gleichen Bedingungen) einmal mit einem Arbeitswiderstand von $500 \text{ k}\Omega$ und einmal mit $1 \text{ k}\Omega$ aufgenommen. Wenn man die Zeitkonstante des Photoeffektes bestimmen will, wird man einen derartig kleinen Arbeitswiderstand anwenden müssen. Beim Nachweis kleiner Signale ist der große Arbeitswiderstand aus Anpassungsgründen notwendig.

Bei einer Temperatur des Photowiderstandes von 24° C betrug bei günstigsten Arbeitsbedingungen und einer Bandbreite von 0,6 Hz der Schwellwert 1,3 · 10⁻⁹ Watt. Dabei wurde eine relative Widerstandsänderung von 2,0 · 10⁻⁸ nachgewiesen. Die Zeitkonstante des Photoeffektes war 89 usec.

² GM 2315 von Philips.

Zusammenfassung

Mit der beschriebenen Prüfapparatur können Ohmsches Verhalten, spektrale Empfindlichkeit, Stromrauschen, Rauschspektrum und Schwellwert von Photohalbleitern bestimmt werden. Die zu untersuchende Strahlung wird mechanisch durch eine rotierende Lochscheibe moduliert; damit können Belichtungsfrequenzen zwischen 50 Hz und 8 kHz eingestellt werden. Die am Arbeitswiderstand der Photozellen auftretende Signalspannung wird durch einen phasenempfindlichen Gleichrichter nachgewiesen, dessen Kernstück eine Mischröhre ist, die Signal und Störspannungen mit einer Referenzspannung multipliziert. Dieser phasenempfindliche Gleichrichter arbeitet frequenzunabhängig zwischen 20 Hz und 15 kHz.

An einer Philips-PbS-Zelle 61 SV erhaltene l ergebnisse werden als Beispiel mitgeteilt.

Zum Schluß danken wir Herrn Professor M. Czerny und der Deutschen Forschungsgen schaft, die die apparativen Hilfsmittel für diese Alzur Verfügung stellten.

Literatur: [1] SCHÖNWALD, B.: Ann. Physik 15, (1932). — [2] GISOLF, J.H.: Physica, Haag 15, 825 (1949 [3] DAHLKE, W., u. G. HETTNER: Z. Physik 117, 74 (1941 [4] MEINKE-GUNDLACH: Taschenbuch der HF-Ted S. 1036ff. Berlin-Göttingen-Heidelberg 1956. — [5] SSTER, N.A.: Rev. Sci. Instrum. 22, 254 (1951). — [6] (H.L.: Rev. Sci. Instrum. 24, 307 (1953).

Dipl.-Phys. R. GERETH und Professor Dr. H.A. MÜSE Physikalisches Institut der Universität Frankfurt a. M

Messung von Voltaspannungen mit Hilfe der Methode des rotierenden Ankers

Von Werner Schaaffs

Mit 4 Textabbildungen

(Eingegangen am 2. Juni 1958)

1. Definition und Eigenschaften der Voltaspannung

Die Voltaspannung 1 $V_{2,1}$ eines leitenden Stoffes gegen einen anderen leitenden Stoff, insbesondere eines Metalles gegen ein anderes Metall, wird als Differenz der Elektronenaustrittsspannungen beider Stoffe definiert und gemessen. Es ist

$$V_{2,1} = V_2 - V_1$$
.

Die ersten Beobachtungen der durch die Voltaspannung beschriebenen Erscheinungen gehen auf VOLTA

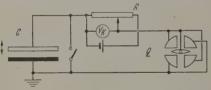


Abb. 1. Klassische Kondensatormethode zur Messung von Voltaspannungen

zurück [1]. Die klassische Meßmethode der Voltaspannung, die sogenannte Kondensatormethode, wurde von Lord Kelvin [2] ausgearbeitet. Das tiefere Verständnis und die atomistische Interpretation der Definition hat zuerst O. W. Richardson [3] gegeben. Befinden sich die beiden Metalle auf etwas verschiedener Temperatur, so ist an der Definitionsgleichung noch eine Korrektur durch den Peltier-Effekt anzubringen. Dieser ist aber vernachlässigbar klein.

Eine Übersicht und einige grundsätzliche Erläuterungen über die Meßmethoden der Voltaspannung haben in neuerer Zeit R. BOURION [4] und K. MÖHRING [5] gegeben. Einige dieser Methoden setzen Hochvakuum voraus, andere beziehen sich nur auf

Gase und Flüssigkeiten. Eine universale Anweibarkeit für Vakuum und Atmosphäre besitzt nur alte Kondensatormethode. Sie existiert in verseldenen Varianten, die auf die klassischen Arbeivon R. Kohlrausch [6] und Lord Kelvin [2] rückgehen.

Die klassische Kondensatormethode ist in Abbskizziert. Bei Bewegungen der oberen Platte des zwei verschiedenen Materialien bestehenden Kodensators C macht das Quadrantelektrometer Q ein Ausschlag. Dieser ist trotz Bewegung der Kondesatorplatte immer dann gleich Null, wenn die Potentiometer R abgegriffene Kompensationsspannung V_k — richtige Polung der Batterie voraussetzt — gleich der Voltaspannung $V_{2,1}$ zwischen deiden Kondensatorplatten ist. In diesem Fall sinämlich die durch die Bewegung hervorgerufen Änderungen von Voltaspannung und Kompensationspannung einander gleich.

Die Definition der Voltaspannung und die Ko densatormethode lassen folgende wichtige Eige schaften erkennen:

1. Die Voltaspannung ist eine relative Größe. 1 Wert hängt von der Elektronenaustrittsspannung des Bezugsstoffes ab, in Abb. I also von dem Mater der unteren Kondensatorbelegung. Als Bezugsst wurde in dieser Arbeit Gold gewählt.

2. Die Elektronenaustrittsspannung bzw. die Voltspannung eines untersuchten Stoffes wird durch d Austrittsbereich der Elektronen, d.h. die Oberfläc bis zu einer gewissen Tiefe nach innen und nach auß hin, sehr stark beeinflußt, weil sich dort durch A sorption oder chemische Bindung Fremdmoleküle au halten, anlagern oder binden. Die Voltaspannu ist daher eine sehr empfindliche Testgröße für Obflächenfremdschichten und verwendbar, wenn ehmische Mikromethoden längst versagen.

3. Aus der Definition geht hervor, daß die ge metrische Gestalt sowohl der Oberfläche des unte suchten Körpers wie des Bezugsstoffes nicht in d

 $^{^1}$ Für die Voltaspannung ist auch die weniger zweckmäßige Bezeichnung Kontaktpotential im Gebrauch. Dieses darf nicht mit dem elektrochemischen Potential, das durch die elektrochemische Spannungsreihe gegeben ist, verwechselt werden. — Die Definition wird oft auch $V_{1,2}\!=\!-(V_1\!-\!V_2)$ geschrieben.

le 1. Aus der Literatur entnommene Voltaspannungen verschiedener Metalle gegen Gold bei Zimmertemperatur und Hochvakuum

	$V_{z,1}$							
	Al	Fe	Ni	Cu	Zn	Ag	Sn	w
MICHAELSON SUHRMANN	$ \begin{array}{c c} -0.84 \\ -0.61 \end{array} $	-0,22 -0,08	$^{+0,26}_{+0,13}$	$\begin{vmatrix} -0,11 \\ +0,24 \end{vmatrix}$	$-0.84 \\ -0.44$	$ \begin{array}{c c} -0.30 \\ -0.01 \end{array} $	-0.47 -0.32	

ergebnis eingeht. Sie hat nur Einfluß auf die azität und damit auf die Meßempfindlichkeit und genauigkeit. Es ist bis heute noch nicht genügend nnt worden, daß diese Eigenschaft der Voltanung sie in geradezu idealer Weise für ein technes Prüfverfahren von Oberflächen prädestiniert. annte Lehrbücher über die Physik dünner Schichzeigen aber, daß die Voltaspannung zur Beur-

ng von Oberflächen praktisch kei-Eingang gefunden hat. Folgende de mögen mitsprechen, obwohl sie

stichhaltig sind:

fan nimmt mit Recht an, daß die aspannung $V_{2,\,1}$ bzw. die Elektronen-rittsspannung V_2 bei gegebener Temtur eine charakteristische Kone ist, wenn sich der untersuchte im höchsten Vakuum befindet und Bedeckung mit Fremdgasmoleküinsbesondere des Sauerstoffs, nicht vorliegt. Man sollte daher meinen, die in der Literatur veröffentlich-Meßwerte, die nach verschiedenen hren gewonnen worden sind und estes Vakuum gelten sollen, einigeren übereinstimmen. Das ist aber eswegs der Fall. Als Beispiel mödie zusammenfassenden Tabellen

Elektronenaustrittsspannungen H.B. MICHAELSON [7] und R. SUHR-[8], aus denen die Voltaspan-

en zu berechnen sind, gelten. Tabelle l gibt einige technisch wichtige Metalle Vergleichse nach Michaelson und Suhrmann. Der Vern wirkt nicht ermutigend, zumal man erwarten daß bei schlechtem Vakuum oder an gewöhnlicher osphäre die Diskrepanzen noch größer werden.

in zweiter Grund dürfte sein, daß die Voltanung im Hochvakuum gar nicht interessiert, darin alle Stoffe verändert sind und gerade jene nschaften nicht zeigen, die sie in Atmosphäre hren Beimischungen von Fremdgasen, Wasserof und Rauch sowie bei Oxydation besitzen.

in dritter Grund für die bei Voltaspannungsingen auftretenden Unsicherheiten liegt in der chweigenden aber falschen Annahme, daß schon gste Fremdbedeckungen den Wert der Voltanung einer Oberfläche bleibend so verändern, lickere Schichten daran nichts wesentliches mehr n. In einer nachfolgenden Arbeit soll vielmehr gt werden, daß die Voltaspannung ausgeprägte na und Minima durchläuft und daß dieser Verdie Ursache für alle bisher beobachteten Uncheiten ist.

. Technisches Meßgerät für Voltaspannungen

ir technische Zwecke ist die klassische Kondennethode nach Abb. 1 zu träge und zu unempfind-Daher sind schon von W. A. ZISMAN [9] und

anderen das Quadrantelektrometer durch eine Elektrometer-Elektronenröhre mit nachfolgendem Verstärker und der handbetriebene Plattenkondensator durch eine periodisch veränderliche Kapazität ersetzt worden. Keine der bekannten Anordnungen hat aber zu einem technisch durchentwickelten Meßgerät geführt, das auch bei kleinsten Kapazitätsänderungen unter 1 p Fin schneller Aufeinanderfolge Messungen

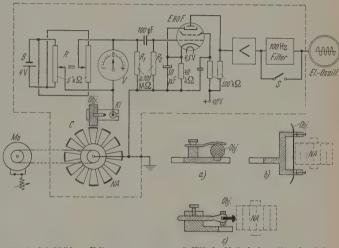


Abb. 2. Schaltbild zur Voltaspannungsmessung mit Hilfe der Methode des rotierenden Ankers

vorzunehmen und gerade dadurch die wichtigen relativ schnellen zeitlichen Änderungen der Voltaspannung zu erfassen gestattete. Ein solches Meßgerät soll hier beschrieben werden¹.

Abb. 2 zeigt das Schaltschema des Geräts und drei Beispiele bewährter Objekthalterungen.

Der Kondensator C der Abb. 1 mit seiner veränderlichen Kapazität ist ersetzt durch einen Kondensator, dessen eine Belegung durch das Untersuchungsobjekt Obj und dessen andere Belegung durch den Nutenanker NA gebildet wird. Gemessen wird die Voltaspannung zwischen dem Objekt und dem vergoldeten Nutenanker. Die Kapazität wird verändert durch Antrieb mit Hilfe des Motors Mo2, dessen Drehzahl regelbar ist. Der Nutenanker³ besteht aus Messing und ist vergoldet. Die Polflächen sind poliert und müssen hellgelbe auf Porenfreiheit hindeutende Farbe haben. Als Antriebsschnur zwischen Anker und Motor hat sich nur dünne Schnur bewährt.

Die Versuchsobjekte Obj können sehr verschiedenartig gestaltet sein. Drei Arten der Halterung, einmal

¹ Erstmals vorgetragen auf dem Physikertag in Heidelberg 1957 [10].
² Geeignet ist ein Rührwerksmotor der Type RM 14,

⁸⁰ bis 2000 Umdr. der Firma Janke & Kunkel KG.

³ Bezeichnung gebildet nach dem entsprechenden Bauteil elektrischer Maschinen.

für massive Zylinder (a), dann für Platten, Blechstreifen oder Drähte (b), und schließlich für kleine Stifte oder Nieten (c) sind in Abb. 2 abgebildet worden. Die Halterungen werden unter den Klemmen Kl des Geräts so befestigt, daß zwischen dem Objekt und den Polen des Nutenankers ein Spalt von einigen Zehnteln Millimeter verbleibt. Die Verwendung von Bernstein oder ähnlichen hochisolierenden Stoffen am Kondensator C oder an den Klemmen Kl ist wegen der nicht zu beseitigenden Haft- oder Reibungsladungen zu vermeiden.

Der von der eingebauten Taschenlampenbatterie B her gespeiste Kompensationskreis enthält ein Potentiometer R, das so gebaut und an B angeschlossen

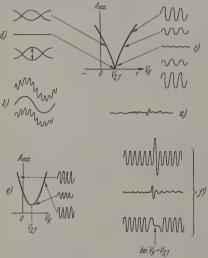


Abb. 3. Erläuterung der Varianten der Meßmethode

ist, daß bei Bewegung des Abgriffs die Teilwiderstände gegensinnig durchlaufen werden. Diese Konstruktion gewährt ein einwandfreies Durchlaufen des Nullwertes der Kompensationsspannung, die am Voltmeter V abgelesen wird. Ausschläge nach links bedeuten negative, nach rechts positive Voltaspannungen des Objektes gegen Gold.

Die bei Bewegung des Nutenankers NA am Widerstand R_1 auftretende Wechselspannung wird der Pentode E 80 F zugeführt. Es ist $R_1 = R_2 \ge 100~\mathrm{M}\Omega$. Diese Philips-Pentode E 80 F arbeitet bei einer Anodenspannung von höchstens 40 V und bei verminderter Heizspannung als Elektrometerröhre, sie hat dabei noch einen Verstärkungsfaktor von etwa 50 und spricht auf mechanische Erschütterungen kaum an. Sie überragt mit diesen Eigenschaften bei der angewendeten Meßmethode alle bekannten Spezial-Elektrometerröhren.

Im Ausgang der beiden Verstärkungsstufen liegt ein Elektronenstrahloszillograph, dessen Verstärker mitbenutzt wird. Auf dem Leuchtschirm des Oszillographen erscheint die an R_1 liegende Wechselspannung verstärkt. Vor dem Elektronenstrahloszillographen befindet sich eine Siebkette, die so bemessen ist, daß sie eine Frequenz von 100 Hz durchläßt und für 50 Hz und 150 Hz eine Dämpfung von 4,6 Neper aufweist. Diese Dämpfungen entsprechen etwa dem Hundertstel der Spannungsamplitude bei 100 Hz.

Die erste Verstärkerstufe mit der Elektrometen tode ergibt einen Verstärkungsfaktor von 50, zweite Stufe verstärkt 10fach, die im Oszillografliegende Stufe hat einen Faktor 500, der aber in seltensten Fällen benötigt wird. Der gesamte stärkungsgrad beträgt 250000; zumeist kommt mit 50000 aus.

Eine Messung der Voltaspannung V2, 1 des suchsobjekts Obj gegen das Gold des Nutenankers geht so vor sich: Nach Einschalten des Motors wird die Drehzahl verändert, bis auf dem Schirm: Oszillographen die sinusförmige Wechselspannung 100 Hz erscheint und ein Maximum wird. Dann di man am Potentiometer R, bis die Amplitude Wechselspannungskurve Null wird, und liest am V meter V den angezeigten Wert ab. Dieser ist gle der Voltaspannung $V_{2,1}$ des Objektes gegen Gold. I Instrument hat Maximalausschläge von ± 2 V; spä wurde ein genaueres Instrument mit +1 V benut Vielfach werden in der Literatur Voltaspannun messungen auf ±1 mV angegeben. Der Verfas bezweifelt es stark, ob diese Genauigkeitsangal sinnvoll sind. Reproduzierbar sind solche Werte nic Ein mittlerer Fehler von $+20 \,\mathrm{mV}$, wie er in die und der nachfolgenden Arbeit zugelassen ist, ist die meisten Voltaspannungsmessungen ausreicher

Zur Meßgenauigkeit und zu den verschieder Varianten der Methodik seien an Hand der Abb. 3 ein Ausführungen gemacht. Arbeitet man ohne Siebket also bei geschlossenem Schalter S der Abb. 2 u damit bei verschiedenen Drehzahlen, so erscheint der Kompensation $V_k = V_{2, 1}$ der Störpegel gem Abb. 3a. Er wird in erster Linie durch Ungleichmäß keiten im Lauf des Nutenankers erzeugt. Diese lass sich auch bei bester Lagerung in Kugellagern u trotz der Bemühung, die Polflächen genau gleichar zu machen, nicht vermeiden. Viel störender ist schon, wenn die technische Netzfrequenz von 501 aus benachbarten Starkstromleitungen oder von d Zimmerbeleuchtung einstreut. Dieser Einfluß ist dur teilweises Hinunterklappen des Deckels des Gerät auszuschalten. Er kann aber nicht behoben werde wenn das an den Klemmen Kl befestigte Versuch objekt zu groß ist, z.B. die Form einer Stange od eines langen Blechstreifens hat und über den Rau des Gerätes hinausragt. In diesem Falle kompensie man gemäß Abb. 3b auf eine glatte Kurve der ei streuenden Netzfrequenz.

Die meisten Voltaspannungsmessungen könn aber in der oben beschriebenen Form mit Siebke gemacht werden. Meist stellt man sich die Kipfrequenz so ein, daß mehrere Wechselspannun perioden auf dem Leuchtschirm erscheinen, und dre den Widerstand R, bis die Amplitude $A_{\rm osz}$ gem Abb. 3c Null wird. Will man aber den Einflschneller und relativ kleiner Änderungen der Volspannung rasch erkennen, z.B. den Einfluß ein Belichtung auf das Objekt während der Rotatides Nutenankers, so erhöht man Kippfrequenz u Verstärkungsgrad, bis eine Kurvenfigur nach Abb. erscheint. Die geringste Abweichung von $V_k = I$ macht sieh dann durch Aufspaltung der zugehörig geraden Linie deutlich bemerkbar.

Bisweilen kommt es vor, daß auf einer Oberflät größere Bereiche verschiedener Voltaspannung neb einander liegen oder daß es dort Stellen mit Ha Raumladung gibt. Das erstere tritt z.B. ein. man eine geschabte Silberfläche durch nur s Eintauchen in Quecksilber unvollständig amalrt, das zweite liegt z.B. bei dem Sirufer geen Material vor, einem für Hochfrequenzübergebrauchten ferromagnetischen Pulver in Polyleinbettung. In solchen Fällen ändert sich die itude Aosz auf dem Leuchtschirm gemäß Abb. 4e. kann nur auf ein Minimum, nicht aber auf Null pensieren. Bei der Deutung und Bewertung er Voltaspannungsmessungen, die man zweckg ohne Siebkette macht, ist Vorsicht geboten. chließlich ist noch jene Variante der Meßmethode nnen, bei der der Bezugsstoff an den Klemmen Kltigt und die zu untersuchende Substanz auf einer Ankerpolflächen aufgebracht wird. In diesem wird die Kippfrequenz des Elektronenstrahllographen so gewählt, daß gemäß Abb. 3f alle 12 h die Ankerpole erzeugten Wechselspannungsden auf dem Leuchtschirm nebeneinander ernen. Die Siebkette ist dabei durch den Schalter S geschlossen. Der Pol mit der künstlich aufgeenen Deckschicht hebt sich heraus. Seine Voltanung wird abgelesen, wenn die Amplitude seiner de Null geworden ist.

n Abb. 4 ist auf Grund einer Messung die Abgigkeit der Amplitude A_{osz} auf dem Leuchtschirm Funktion der kompensierenden Spannung V_{k} bei chiedenen Kapazitäten C des Voltakondensators estellt worden. Die Kurven wurden dadurch erelt, daß ein Metallteil mit veränderlicher Breite bAbstand von 0.5 mm unter dem Nutenanker NAhgeschoben wurde. Die Kapazitäten C sind aus Breiten b überschlägig berechnet worden. Die ven lassen Meßempfindlichkeit und Meßgenauigerkennen. Für b = 10 mm ist C = 1.2 pF, und Verstimmung von V_k um 0,1 V hat man eine blitude von nur 0,5 mm. Setzt man aber den and zwischen Anker und Objekt auf 0,1 mm b, so wächst C auf das fünffache, und zur Vermung um 0.1 V gehört jetzt eine Amplitude A_{osz} etwa 2,5 mm. Die Verminderung des Abstandes damit die Erhöhung der an sich kleinen Kapazität ei kleinen Versuchsobjekten stets der Weg zur hung von Empfindlichkeit und Genauigkeit.

echnische Voltaspannungen einiger Metalle gegen Gold

n der Tabelle 2 ist eine mit dem beschriebenen t gemessene Serie von Werten der Voltaspannung shiedener Metalle gegen Gold zusammengestellt en. Im Unterschied zu den Vakuumwerten haben liesen Werten die Bezeichnung "technische Voltanungen" gegeben. Diese Bezeichnung, die wir öfters gebrauchen werden, soll folgendes zum ruck bringen:

ine Messung in Atmosphäre erfaßt denjenigen flächenzustand des Metalls, der in der Technik ausschlaggebende Rolle spielt. Die Oberfläche Metalls ist auch dann mit einer gewissen Saueroder sogar Oxydschicht bedeckt, wenn sie zuvor sinem definierten Reinigungsverfahren behandelt en ist. Die neue Bedeckung tritt sofort auf und et sich bei unedlen Metallen im Laufe der Zeit v schnell. Die Reinigungsvorschrift, die hin-

reichend reproduzierbare Werte der Voltaspannung gab, war folgende: Bei harten Metallen möglichst plane glänzende oder spiegelnde Oberflächen zunächst

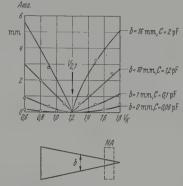


Abb. 4. Die Abhängigkeit der Amplitude der auf dem Schirm des Elektronenstrahloszillographen beobachteten Kurven von der Kapazität des Voltaspannungskondensators

mit Methylalkohol (p. A.), danach mit Äthyläther (p. A.) mittels reinster Watte oder Zellstoff behandelt; bei weniger harten und bei weichen Metallen nach plan

Tabelle 2. Technische Voltaspannungen einiger Metalle gegen Gold ${\it Temperatur etwa~22^{\circ}~C, relative~Luftfeuchtigkeit~20~\%}$

Metall	Technische Voltaspannung $V_{2,1}$ (Volt)	Angaben über Bearbeitung, Form und Reinheit des Metalls	Vakuum- werte von V _{2,1} nach Mi- CHAELSO! (Volt)
Ag	0,25	reinst, Bandform mit polierter Oberfläche	-0,30
Al	0,90	Blech aus Reinstaluminium, spiegel- blank	0,84
Au	0	Hauchvergoldung (0,06 μ) auf Messing mit Palladiumunterlage, glänzend hellgelb	0
Bi	-0,32	grobkristalline, glänzende Brocken, untersuchte Flächen abgeschabt	-0,30
Cd	-0.68	Stangenform, Oberfläche abgeschabt	-0.66
Cu	-0,28	reinst, in Blechform, geschliffen und poliert	-0,11
Fe	-0.25	Eisendraht poliert	-0,22
Hg	-0.25 -0.11	Flüssigkeitsoberfläche; Benutzung eines Nutenankers mit horizontal	-0,06
Мо	-0,36	liegender Achse Blech mit glänzend geschabter Oberfläche	-0,31
Ni	+0.03 bis -0.25	schwieriges Metall, reinst, kein ein- deutiger Wert zu erhalten, unab- hängig davon, ob Draht, Blech oder massiv	+0,26
Pb	-0,60	massiv, reinst, Oberfläche geschlif- fen, danach glänzend geschabt	0,56
Sn	-0,50	massiv, reinst, Oberfläche geschliffen	-0,47
Та	-0,55	Blech mit glänzend geschabter Oberfläche	-0,46
W	-0,15	hochglanzpoliert, reinst, Analyse ergab Beimischungen von C, Cu, Si, Fe jeweils unter 0,01 %	- 0,08
Zn	-0,90	reinst, massiv mit geschliffener Oberfläche	-0,84

abgezogener Oberfläche sofort Reinigung mit Methylalkohol und Äthyläther und danach Abschaben mit einer harten Schneide aus Uhrfederstahl, so daß eine frisch glänzende Oberfläche entsteht. Sollte der

Voltaspannungswert im letzteren Falle von den in der Tabelle 2 angegebenen Werten noch zu stark abweichen, muß noch weiter abgeschabt werden. Die Behandlung mit Methylalkohol dient übrigens vorzugsweise der Beseitigung stärkerer Wasserhäute.

In der letzten Spalte dieser Tabelle wurden die Werte eingetragen, die sich aus den Angaben über die Elektronenaustrittsspannung nach MICHAELSON [7] ergeben und für Hochvakuum gelten sollen. Wenn man vom Nickel, mit dem der Bearbeiter immer nur Schwierigkeiten gehabt hat, absieht, so besteht zwischen den idealen Werten von MICHAELSON und den technischen Voltaspannungen eine erstaunlich gute Diese Übereinstimmung kann Übereinstimmung. keine echte sein. Es kann nach aller unserer bisherigen Kenntnis als sicher gelten, daß wenigstens bei den unedlen Metallen eine monomolekulare oder bimolekulare Sauerstoffbedeckung die Voltaspannungen stark verändert. Wenn hier trotzdem das Experiment eine gewisse Übereinstimmung zwischen Hochvakuumwert und technischem Wert ergibt, dann muß ein besonderer Effekt vorliegen, demzufolge bei etwas dickeren Fremdschichten wieder ein dem idealen Zustand ähnlicherer Voltaspannungswert zustandekommt. Dieser wichtigen Frage ist eine zweite Arbeit gewidmet.

Zu der Messung von Gold gegen Gold ist folgendes zu sagen: Die Güte der Vergoldung des Nutenankers und ihre Konstanz muß öfter überprüft werden. Massives, hochglanzpoliertes Gold als Bezugsstoff steht meist nicht zur Verfügung. Es wurde daher ein Material genommen, welches in Form dünner Messingbleche vorlag und mit einem auf galvanischem Wege hergestellten vorzüglichen Goldüberzug versehen war. Ein solcher Überzug muß hellgelbe, auf Porenfreiheit deutende Farbe haben. Bei Beachtung der Reinigungsvorschriften für dieses Blech und den Nutenanker ergab sich immer die technische Voltaspannung Null.

Zusammenfassung

Nach einigen grundsätzlichen Ausführungen die Bedeutung der Voltaspannung zur Untersuc der Oberflächen von Metallen, die mit Fremdschiel insbesondere aus Sauerstoff und Oxyden bedeckt wird ein neuartiges auf der Kondensatormet fußendes, aber durchentwickeltes Meßgerät zur stimmung technischer Voltaspannungen an bel gestalteten Objekten beschrieben. Die Untersucht objekte können kleine Flächen von einigen Quae millimetern Größe haben. Die Voltaspannung gegen einen rotierenden Nutenanker mit Golde fläche gemessen. Es wird Wert darauf gelegt, die Voltaspannungen an einer größeren Zahl Objekten schnell hintereinander ermittelt wei können. Für 15 Metalle (Elemente) werden gemessenen technischen Voltaspannungen angege

Die Anregung zur Untersuchung der Fragedie Voltaspannung, deren Messung oft als schwund unsicher hingestellt wird, zur Prüfung von Offlächen technisch verwendbar ist, gab Herr Prof. Hellmuth Fischer. Den Herren Ernst Kaefund Fritz Eckhardt habe ich für die sorgfäß Bauweise des Meßgeräts und für seine Erprofin zahlreichen Versuchen sehr zu danken. Die Arwurde im Werkstoff-Hauptlaboratorium der Siem & Halske AG, Berlin-Siemensstadt, ausgeführt.

Literatur: [1] Volta, A.: Ann. Chim. 40, 225 (1801)
[2] Lord Kelvin: Phil. Mag. 46, 82 (1898). — [3] Rich. Son, O. W.: Phil. Mag. 23, 263 (1912). — [4] Bourion, J. Phys. Radium 12, 930 (1951). — [5] Möhring, K. Elektrochem. 59, 102 (1955). — [6] Kohlrausch, R.: Pog dorffs Ann. 82, 1 (1851). — [7] Michaelson, H. B.: "Re of work funktions and methods of determination". J. A. Phys. 21, 536 (1950). — [8] Suhramann, R.: Landolf-B stein-Tabellen, 6. Aufl., Bd. I/4, S. 759, 1955 (Lit. bis F 1950 berücksichtigt). — [9] Zisman, W. A.: Rev. Sci. Instr. 3, 367 (1932). — [10] Schaaffs, W.: Phys. Verh. 8, 114 (19

Prof. Dr. phil. WERNER SCHAAFF Berlin-Siemensstadt, Rieppelstr. 2

Über die Ausbreitung langer elektrischer Wellen in magnetisierten Plasmen und ihren Durchgang durch Plasmaschichten

Von Winfried Otto Schumann

Mit 3 Textabbildungen
(Eingegangen am 5. Juni 1958)

In den Arbeiten [1] und [2] habe ich die Ausbreitung elektrischer Wellen in begrenzten Plasmen diskutiert. Es wurde dort der Einfachheit halber die Dämpfung vernachlässigt. Da aber gerade bei langen Wellen die Stoßdämpfung der Elektronen von sehr erheblichem Einfluß ist, soll diese in folgendem besprochen werden, besonders für den Fall eines äußeren homogenen Magnetfeldes. Verläuft das Magnetfeld B in z-Richtung, so ergeben sich die dielektrischen Verschiebungen, siehe z.B. [3], [4] zu

$$\begin{array}{ll} D_{x} = \varepsilon_{xx} E_{x} + \varepsilon_{xy} E_{y} & \varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} \\ D_{y} = \varepsilon_{yx} E_{x} + \varepsilon_{yy} E_{y} & \varepsilon_{xy} = -\varepsilon_{yx} \\ D_{z} = \varepsilon_{z} E_{z}, \end{array}$$
 (1)

wobei

$$\begin{split} \varepsilon_{xx} &= \varepsilon_0 + \frac{\varepsilon_0 \omega_0^2}{j\omega} \cdot \frac{v + j\omega}{\Omega^2 + (v + j\omega)^2} \\ \varepsilon_{xy} &= \frac{\varepsilon_0 \omega_0^2}{j\omega} \cdot \frac{\Omega}{\Omega^2 + (v + j\omega)^2} \\ \varepsilon_z &= \varepsilon_0 + \frac{\varepsilon_0 \omega_0^2}{j\omega} \cdot \frac{1}{v + j\omega}. \end{split}$$

In diesen Gleichungen ist ε_0 die DK des leeren Raut $\frac{1}{4\pi\cdot 9\cdot 10^9}\frac{F}{m}$ und ν die mittlere sekundliche Stahl der Elektronen mit den umgebenden Gasm külen, $\Omega=\frac{e}{m}$ B die Umlauffrequenz der Elektro im Magnetfeld $B,\,\omega=2\pi\,f$ die aufgeprägte Freque



1875

baute Carl von Linde seine erste Kältemaschine und schuf die Voraussetzung für die Verwendung der Künstlichen Kälte in Industrie und Wirtschaft.

r. Carl von Linde nach seinem Verfahren flüssige Luft in großen en erzeugen konnte, bestand das Problem darin, das Flüssigemisch in seine Bestandteile zu zerlegen. Diese Aufgabe

mehrfache Rektifikation des flüssigen Gasgemisches gelöst, es war bald kein Problem mehr, Sauerstoff und Stickstoff in gewünschten Reinheit zu erzeugen.

eriger ist die Gewinnung der Edelgase; ihr Anteil an der Zuensetzung der Luft beträgt: Argon 0,932°/, Neon 0,0015°/, m 0,0005°/₀ Krypton 0,00011°/₀ Xenon 0,000008°/₀.

-Ingenieure haben die Aufgabe gelöst, Edelgase in höchster eit zu erzeugen und damit erneut bewiesen, daß Linde-Anlagen erlegung von Gasgemischen Spitzenerzeugnisse der KälteLuftverflüssigungsanlage von Carl von Linde



LINDE-Sauerstoff- und Azetylenwerke im gesamten Bundesgebiet und Berlin beliefern Sie mit:

- SAUERSTOFF
- AZETYLEN
- WASSERSTOFF
- STICKSTOFF
- PRESSLUFT
- ARGON
- **SCHWEISSARGON**
- **EDELGASEN**



GESELLSCHAFT FÜR LINDE'S EISMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT HOLLRIEGELSKREUTH

BEI MUNCHEN



Die Mikrowellenspektroskopie erfordert zum Aufbau der elektronischen Einrichtung meimehr Zeit und Arbeit als die Bearbeitung der Meßaufgabe selbst. Dieser Nachteil kannur durch den Einsatz modernster Meßmittel behoben werden, wie sie jetzt zur Frequenz steuerung von Signal- und Überlagerungsoszillatoren mit einer Absolutgenauigkeit vo 10⁻⁸ und einer Verstimmungsgenauigkeit von 10⁻⁹ bis in das K-Band zur Verfügung stehen



 $1 \omega_0^2 = N e^2 / \varepsilon_0 m$ die Resonanzfrequenz des Plasmas N als Elektronenzahl je m^3 .

Ist $v \ll \omega$ so gehen diese Formeln über in die benten für ungedämpftes bzw. schwach gedämpftes sma [4]. Ist hingegen $v \gg \omega$, so entsteht

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{x\,x} &= \varepsilon_0 + \frac{\varepsilon_0 \omega_0^2}{j\omega} \cdot \frac{\nu}{\Omega^2 + \nu^2} \\
\varepsilon_{x\,y} &= \frac{\varepsilon_0 \omega_0^2}{j\omega} \cdot \frac{\Omega}{\Omega^2 + \nu^2} \\
\varepsilon_z &= \varepsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\nu^2} + \frac{\omega_0^2}{j\omega\nu} \right).
\end{aligned} (3)$$

r das ionosphärische Plasma mit $\nu \approx 10^6\,\mathrm{sec^{-1}}$ an unteren Grenze ist schon von einer aufgeprägten equenz von \sim 1 MH aufwärts überall $\omega \gg \nu$, während Frequenzen von $\sim 10 \,\mathrm{kH}$ abwärts $\nu \gg \omega$ ist, wenigns in der D und E Schicht. Für ein Gasentladungssma von $\sim 5 \cdot 10^{-3}$ Torr und kleinen Strömen ist 108 sec⁻¹, so daß erst bei Frequenzen von 100 MH wärts $\nu \ll \omega$ ist, dagegen bei 1 MH schon $\nu \gg \omega$ ist. In den meisten Fällen sind für $\nu \gg \omega$ die reellen teile von ε_{xx} und ε_z zu vernachlässigen, wenn Ω ht extrem groß wird. Es hängt dies mit den großen erten von ω_0 zusammen. Es muß dafür $\omega_0^2/\omega^2 \gg \nu/\omega$ n, und $\Omega^2/\omega_0^2 \ll \nu/\omega$. Dann ist das Plasma nur durch eitwerte" charakterisiert und es ist $\varepsilon_{xx}/\varepsilon_{xy} = v/\Omega$. thrend in der Ionosphäre f_0 bis auf $\sim 10^7$ H geht, igt es bei Entladungsplasmen auf mehr als 109 H, s etwa $N = 10^{10}$ El./cm³ entspricht.

Der Einfluß des Magnetfeldes hängt ebenfalls von ab. Setzen wir z.B. B=0.6 Gß, und $\Omega\approx 10^7$ H, ist für das ionosphärische Plasma ein solches Feld on stark $(\Omega\gg v)$ und beeinflußt die Erscheinungen r wesentlich, während für das Gasentladungssma $B\approx 60$ Gß nötig wären, um den gleichen Effekt erzielen (s. hierzu auch [8]).

Ausbreitung ebener Wellen quer zum Magnetfeld (senkrecht zur z-Richtung)

Von den beiden möglichen Wellentypen dieses les wird der, dessen elektrisches Feld in z-Richtung t, vom Magnetfeld überhaupt nicht beeinflußt. Die ksame DK ist ε_z . Der andere Typ, dessen elektries Feld senkrecht zu z liegt, wird vom Magnetfeld influßt und die wirksame DK für diese Welle ist [4]

$$\varepsilon_q = \varepsilon_{xx} \Big(1 + \frac{\varepsilon_{xy}^2}{\varepsilon_{xx}^2} \Big). \tag{4} \label{eq:epsilon}$$

zt man die Werte aus Gl. (3) ein und vernachigt ε_0 in ε_{xx} , so entsteht

$$n_q^2 \cdot \varepsilon_0 = \varepsilon_q = -j \frac{\varepsilon_0 \omega_0^2}{\omega \nu} \tag{5}$$

bhängig davon, ob $\Omega \geqslant v$ ist, d.h. ε_z nach Gl. (3), in man darin $\varepsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_0^2}{v^2}\right)$ vernachlässigt. Dies ist h verständlich, da auch schon ohne Stoßdämpfung, 0, für $\omega^2 \ll \omega_0^2$, und Ω^2 nicht wesentlich größer als ω_0^2 , DK $\varepsilon_q = \varepsilon_0 \left[1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\Omega^2 + \omega_0^2 - \omega^2}\right]$ schon negativ d, so daß ohne Dämpfung überhaupt keine Austung stattfindet. Wenn die DK negativ ist, so ergibt mit Dämpfung bei kleinem Leitwert \varkappa eine Ausbreig mit großen Wellenlängen und sehr großer Phasenschwindigkeit, und bei großem Leitwert die beschwindigkeit,

kannte Ausbreitung wie in Metallen mit hohem Leitwert, wobei aber auch schon bei kleinem Leitwert die Wellen infolge der negativen DK stark gedämpft sein können. Das Plasma erhält sich also wie ein Leiter vom Leitwert $\kappa_q = j\omega \varepsilon_q = \varepsilon_0 \frac{\omega_0^2}{\nu}$, der für ein Entladungsplasma, wie oben, etwa den Betrag von $\sim 4\,S/m$ hat, während der Leitwert in der Ionosphäre sehr viel kleiner ist.

II. Ausbreitung ebener Wellen längs des Magnetfeldes (in z-Richtung)

Jetzt ist die wirksame DK der beiden möglichen Wellen durch [4] $\varepsilon_{h_{,i}} = \varepsilon_{xx} \pm \varepsilon'_{xy}$, $\varepsilon'_{xy} = -j \, \varepsilon_{xy}$, gegeben, woraus nach den Gln. (2)

$$\varepsilon_{l_{1,2}} = \varepsilon_0 \left[1 - \frac{\omega_0^2}{\omega} \frac{1}{(\omega \pm \Omega) - j\nu} \right] \tag{6}$$

folgt. Nach den Gl. (3), wieder mit Vernachlässigung von in ε_0 in ε_{xx} ergibt sich

$$n_l^2 = \frac{\varepsilon_{l_{1,2}}}{\varepsilon_0} = \frac{\omega_0^2}{\omega} \frac{1}{\mp \Omega + j\nu}.$$
 (7)

Ist $\Omega \ll \nu$, so geht auch diese DK in ε_z über. Beide Wellen fallen zusammen und das Plasma wirkt wie ein Ohmscher Leitwert. Ist dagegen $\Omega \gg \nu$, so verhält sich das Plasma wie ein Dielektrikum und für die eine Welle mit einer positiven DK, für die andere Welle hingegen mit einer negativen DK, wobei diese DK-Werte bei kleinen Frequenzen sehr groß werden können. Die negative DK läßt erwarten, daß längs eines von Luft umgebenen Plasmastrahles dieser Art elektrische Wellen von der Frequenz 0 an bis zu einer bestimmten oberen Frequenz sich ausbreiten können, s. [5] und [2].

Vergleicht man die obigen Werte von ε_{l_1} , mit den Werten des idealen Plasmas mit $\nu = 0$, so gilt dort [4], S. 98 für den Brechungsindex

$$n_l^2 = \frac{\varepsilon_{l_{1,2}}}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_0^2}{(\omega \pm \Omega)\omega}$$

Für $\omega \ll \Omega$ wird

$$n_l^2 = rac{arepsilon_{l_{1,2}}}{arepsilon_0} pprox rac{\omega_0^2}{\omega} \cdot rac{1}{\mp \Omega} \,.$$

Hier ergibt sich im Gegensatz zu I auch ohne Dämpfung für die extraordinäre Welle eine dielektrische Ausbreitung, so daß die Dämpfung nur die Ausbreitung modifiziert. Man erhält also im idealen Fall $(\nu=0)$ für $\omega\ll 2$ die gleichen Werte wie in unserer Näherung für $\omega\ll \nu$, wenn $\Omega\gg \nu$ ist, kann also die Resultate von [1] und [2] unter diesen Bedingungen auch für das Plasma mit Verlusten verwenden. Aus Gl. (7) folgen für die ebene Welle die Ausbreitungskonstanten

$$eta_{1,\,2}^2 = rac{\omega^2}{c^2} \, n_l^2 = rac{\omega_0^2}{c^2} \cdot rac{\omega}{\mp \Omega + j r}$$

Daraus folgt, für $\Omega \gg \nu$, daß, wie bekannt, die "ordinäre" Welle im ebenen Fall keine Ausbreitungsmöglichkeit hat, sondern eine stehende gedämpfte Welle ist, während die "extraordinäre" Welle sich schwach gedämpft ausbreitet mit der Phasengeschwindigkeit $v_p = \frac{c}{n_l} = \frac{c}{\omega_0} \sqrt{\omega \Omega}$, der Wellenlänge $\lambda = \frac{c}{n_l} = \frac{c}{\omega_0} \sqrt{\omega \Omega}$

$$2\pi \ \frac{c}{\omega_0} \sqrt{\frac{\Omega}{\omega}}$$
 und der Gruppengeschwindigkeit $v_g = \frac{1}{2} \, v_p$.

Die Wellenwiderstände beider Wellen sind

$$W = \frac{1}{n_l} \cdot W_0, \qquad W_{1,2}^r = \int_{-\varepsilon_0}^{-\mu_0} \frac{1}{\omega_0} \sqrt{\omega \left(\mp \varOmega + j\nu\right)}.$$

Für kleine Frequenzen ist $W_2 \ll W_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$ also der Wellenwiderstand W_2 sehr klein gegen den der Luft. Die elektrischen Felder sind also auch sehr klein gegen die magnetischen. Es ist dies derselbe Wellentyp, den auch Storev [11] für die Whistler-Ausbreitung vorschlägt.

III. Elektronenbewegungen bei langen Wellen

Eine Ergänzung zum Vorhergehenden gibt der Verlauf der Elektronenbewegung.

Nimmt man ein konstantes \overline{B} -Feld in z-Richtung an, so ist die periodische Elektronengeschwindigkeit in der dazu senkrechten xy-Ebene mit $E=E_0\cos\omega t$, ebenfalls in der xy-Ebene, [4], S. 93

$$v = E_0 \; \frac{e}{m \; (\nu + j\Omega)^2 + \omega^2} \; [(\nu + j\Omega) \cos \omega t + \omega \sin \omega t]. \label{eq:v}$$

Schwingt E in x-Richtung, so bedeutet der imaginäre Teil eine Schwingung in der dazu senkrechten y-Richtung. Setzt man $\omega \ll v$ voraus, so wird

$$v \approx E_0 \frac{e}{m} \frac{1}{v + i\Omega} \cdot \cos \omega t$$

was auch in der Grenze für $\omega \to 0$, statischer Zustand, gilt. Ist $\Omega \ll \nu$, so wird $|v_y| \ll |v_x|$ und es entsteht $v_x = E_0 - \frac{e}{m} - \frac{1}{\nu} \cos \omega t$, eine Geschwindigkeit in Feldrichtung mit der "Beweglichkeit" $b = -\frac{e}{m\nu}$. Ist hingegen $\Omega \gg \nu$, d.h. auch $\Omega \gg \omega$, so entsteht

$$v = -j E_0 \frac{e}{m} \frac{1}{\Omega} \cos \omega t + E_0 \frac{e}{m} \frac{v}{\Omega^2} \cos \omega t.$$

Die Geschwindigkeit in Feldrichtung, v_x ist sehr gering und proportional v. Dagegen ist die Geschwindigkeit senkrecht zur Feldrichtung, v_y , viel größer als jene und wird

$$v_y = -\,j\,\frac{E_0}{B}\,\cos\omega\,t\,.$$

Sie hat die Größe $\frac{E_0\cos\omega t}{B}$ senkrecht zum elektrischen und zum magnetischen Feld, wie sie auch im Vakuum bei statischen E- und B-Feldern bei $\omega=0$ auftritt und ist unabhängig von Ladung und Masse der Teilchen. Der Einfluß der Dämpfung ist verschwunden. Dasselbe erhält man auch ohne Dämpfung ($\nu=0$), wenn $\Omega\gg\omega$ ist. Begründet ist dies dadurch, daß in unserem Fall wegen $\omega\ll\nu$ die Beschleunigungskräfte gegenüber den Reibungskräften verschwinden, und daß wegen $\Omega\gg\nu$ diese Reibungskräfte verglichen mit den magnetischen Kräften bei gleichen Geschwindigkeiten in beiden Kräften ganz unwesentlich sind. Aus den Bewegungsgleichungen in x- und ν -Richtung

$$mv v_x + m \frac{dv_x}{dt} = cE_x + v_y B_z e,$$

 $mv v_y + m \frac{dv_y}{dt} = -v_x B_z e$

folgt dann, daß $v_x \ll v_y$ wird und daß daraus gend die elektrischen und magnetischen Kräftex-Richtung sich nahezu kompensieren müssen, wor dann $v_y = -E_x/B$ folgt. Aus den Werten von v_x un folgen dann auch ε_{xx} und ε_{xy} mit $|\varepsilon_{xx}/\varepsilon_{xy}| = |v_x|$ Nimmt man an, daß für die Ionen die gleichen wegungsgesetze gelten, so würde ein Ion genau gleichen Geschwindigkeiten v_y haben und es widdurch die genau gleichartige Pulsation positiver negativer Ladungen gleicher Dichte kein resultierer Strom im DK entstehen, d.h. das Plasma wäre eine solche Welle praktisch nicht vorhanden und h die DK $\varepsilon_p/\varepsilon_0=1$. Es würde lediglich schwach dä fend wirken. Leider ist das in der Ionosphäre we stens für die tieferen Schichten nicht der Fall, d z.B. für O+-Ionen wäre $\Omega_J \approx 300~{
m sec^{-1}}$ für $\frac{1}{2}$ GB, a die Stoßzahl der Ionen wäre in der D-und E-Sch $\sim 3 \cdot 10^3$ bis $3 \cdot 10^4$ sec⁻¹, d.h. viel größer als $\Omega_{J_{\odot}}$ daß die Ionen praktisch in Feldrichtung mit sehr kleineren Amplituden schwingen würden, also Elektronenbewegungen nicht kompensieren könnt und auf die Ausbreitung der Wellen so gut wie kei Einfluß hätten. Nur in den hohen F-Schichten sehr kleinem v erschiene das möglich, die event nachts, wenn keine D- und E-Schichten da sind, Wellen äußerst geringer Frequenz durchdrun werden könnten. Bei Tage würden D- und E-Schi noch eine besonders zu durchdringende Schicht d stellen, die nach dem vorigen stark dämpfend u reflektierend wirken müßte. Dann würden z.B. Luftraum erzeugte Wellen mit $\omega \ll \Omega_J$ wohl bei T reflektiert werden, aber in der Nacht die Ionosph mehr oder weniger frei durchdringen können, v vielleicht mit ein Grund dafür sein könnte, daß durch Blitze erzeugte Frequenz von 9 H bei Na so sehr viel schwächer ist als bei Tage [12]. D würde aber auch nur für diese geringen Frequenz $\omega \ll \Omega_I$ gelten¹.

IV. Übertritt langer Wellen von Luft in Plasmen

Nachdem wir in Abschn. II gesehen haben, die bei den geringen Frequenzen im allgemeinen nur eif Ausbreitung in der Richtung des Magnetfeldes möglist (von der Mitwirkung der positiven Ionen, die Abschn. III besprochen wurden, sehen wir weitert ab), erhebt sich noch die Frage, nach dem Übertr solcher Wellen von der Luft ins Plasma, wobei wir de Einfachheit halber senkrechten Einfall der Well auf die Trennfläche annehmen. Bei der Ausbreitun der Richtung des Magnetfeldes (z-Richtung) sit die beiden möglichen Wellentypen gegeben durch [4 S. 98]

$$\begin{split} H_{y} &= H_{1}e^{-j\beta_{1}z} + H_{2}e^{-j\beta_{1}z}, \\ H_{x} &= jH_{1}e^{-j\beta_{1}z} - jH_{2}e^{-j\beta_{1}z}, \\ E_{y} &= -jW_{1}H_{1}e^{-j\beta_{1}z} + jW_{2}H_{2}e^{-j\beta_{2}z}, \\ E_{x} &= W_{1}H_{1}e^{-j\beta_{1}z} + W_{2}H_{2}e^{-j\beta_{2}z} \\ W_{1} &= \sqrt{\frac{\mu_{0}}{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{xy}'}}, \qquad W_{2} &= \sqrt{\frac{\mu_{0}}{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{xy}'}}. \end{split}$$

¹ Wie mir Herr D.-H. POEVERLEIN mitteilt, ist er ebenfa auf diese Möglichkeit der Durchdringung der Ionosphä gekommen, siehe eine demnächst erscheinende Arbeit Journal of Atm. and Terr. Physics.

a Durchgang durch eine einfache Grenze (Abb. 1) commt in der Luft eine linear polarisierte E_{x_a} , H_{y_a} .

e' an, so sind die Amplituden der im Plasma irlaufenden Wellen

$$\left[\begin{array}{ccc} H_1 = H_{y_a} & \overline{W_0} \\ \overline{W_1 + W_0} \end{array}, \quad H_2 = H_{y_a} & \overline{W_0} \\ \overline{W_2 + W_0} \end{array} \right.$$

i für die zugehörigen E_y und E_x noch mit W_1 W_2 zu multiplizieren ist. Es gibt auch zwei ktierte Wellen (H_{y_r}, E_{x_r}) und (H_{x_r}, E_{y_r}) wobei

$$\begin{split} H_{x_{\rm r}} &= j H_{y_{\rm d}} \, W_0 \, \frac{W_2 - W_1}{(W_1 + W_0)(W_2 + \overline{W_0})} \, , \\ H_{y_{\rm r}} &= H_{y_{\rm d}} \, \frac{W_0^2 - W_1 \, W_2}{(W_1 + W_0)(W_2 + W_0)} \, . \end{split}$$

whl die durchgehende, als auch die reflektierte ee ist elliptisch polarisiert, wobei die Polarisationse im Plasma beim Weiterlauf entsprechend dem day-Effekt sich dreht. Ohne Verluste ist für diese

$$arepsilon_{l_{1,2}} = arepsilon_{x\,x} \pm arepsilon_{x\,y}' = arepsilon_0 \Big[1 - rac{\omega_0^2}{(\omega \pm \Omega)\,\omega} \Big].$$

ach der verwendeten Frequenz hat $\varepsilon_{l_{1,1}}$ Null- und idlichkeitsstellen [4], S. 100, wo entweder W_1 W_2 gegen ∞ bzw. gegen Null gehen. Wenn ein W dlich oder zu Null wird und das andere endlich t, tritt nur eine zirkularpolarisierte Welle in das na ein, z. B. für $\omega = \Omega$. Im Falle des Abschn. II leinen Frequenzen, $\omega \ll \Omega$, werden beide, W_1 und bei genügendem ω_0 sehr klein gegen W_0 und man t nahezu vollständige Reflexion. Im Plasma en in diesem Falle die elektrischen Felder äußerst gegen die magnetischen.

Durchgang durch eine endliche Schicht (Abb. 2)

Sommt auch hier eine linearpolarisierte (E_{x_a}, H_{y_a}) e an, so gilt für die austretenden Wellen H_{x_d}

$$e^{-j\beta_{0}\delta} = H_{y_{a}} \left\{ \frac{1}{2\cos\beta_{1}\delta + j\left(\frac{W_{0}}{W_{1}} + \frac{W_{1}}{W_{0}}\right)\sin\beta_{1}\delta} + \frac{1}{2\cos\beta_{2}\delta + j\left(\frac{W_{0}}{W_{2}} + \frac{W_{2}}{W_{0}}\right)\sin\beta_{2}\delta} \right\},$$

$$= H_{y_{a}} \left\{ \frac{1}{2\cos\beta_{1}\delta + j\left(\frac{W_{0}}{W_{1}} + \frac{W_{1}}{W_{0}}\right)\sin\beta_{1}\delta} - \frac{1}{2\cos\beta_{2}\delta + j\left(\frac{W_{0}}{W_{2}} + \frac{W_{2}}{W_{0}}\right)\sin\beta_{2}\delta} \right\},$$
(8)

 $eta_{1,2} = rac{\omega}{c} \, n_{l_{1,1}}, \quad W_{1,2} = rac{W_0}{n_{l_{1,1}}}, \quad n_{l_{1,2}}^2 = rac{arepsilon_{l_{1,2}}}{arepsilon_0}.$ The magnetische Kopplung, B = 0, $arepsilon_{xy} = 0$ wird W_2 und $eta_1 = eta_2$ und $H_{y_d} \stackrel{e^{-jeta_0 \, \delta}}{----} = d$ geht über in tibliche Gleichung

$$d = \frac{1}{\cos\beta \, \delta + j \, \frac{1}{2} \left(\frac{W_0}{W} + \frac{W}{W_0} \right) \sin\beta \, \delta} \, \cdot \label{eq:delta_delta_delta_delta}$$

wird dann zu Null s. auch [6].

Im allgemeinen Fall ist die austretende Welle elliptisch polarisiert. Im ungedämpften Fall, $\nu=0$ wird für $\omega=\Omega$, $\varepsilon_{l_{-}}\rightarrow\infty$, $\beta_{2}\rightarrow\infty$, $W_{2}\rightarrow0$. Dann wird $H_{y_{d}}=-jH_{x_{d}}$. Die austretende Welle ist, wie bekannt, in diesem Fall zirkular polarisiert [7]. Geht hingegen $W\rightarrow\infty$, $\varepsilon_{l}\rightarrow0$, so geht $\beta\rightarrow0$, und es wird der entsprechende Term

$$2+j\frac{1}{\delta}\cdot 2\pi$$
,

wenn λ_0 die Vakuumwellenlänge der Frequenz ω bedeutet, bei der $n{\to}0$ geht. Je nach dem, ob die Schichtdicke groß oder klein gegen diese Wellenlänge

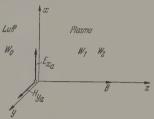


Abb. 1. Wellendurchgang durch eine Grenze

ist, liegt dieser Term zwischen $\frac{1}{2}$ und 0, trägt also viel oder wenig zur durchgehenden Feldstärke bei (s. auch [6]). Schließlich zeigt sich der Einfluß der

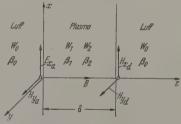


Abb. 2. Wellendurchgang durch eine endliche Schicht

Schichtdicke in den Gliedern $\cos\beta\delta$ und $\sin\beta\delta$. Ist $\beta\delta=g\cdot\pi$ so verschwindet der Einfluß der Wellenwiderstände und der betreffende Term hat den Wert $\pm\frac{1}{2}$. Dies verlangt

$$\delta = \frac{g \pi}{\beta} = g \cdot \frac{\lambda}{2} ,$$

wo λ die Wellenlänge der betreffenden Frequenz im Plasma ist. Die Dicke muß eine ganze Zahl halber Wellenlänge umfassen. Bei größeren Dicken, wo g eine große Zahl ist, wird jede kleinste Dickenschwankung diese Interferenzwirkung zerstören, die auch nur ohne Dämpfung vollkommen auftritt, und mit wachsender Dämpfung klein wird und verschwindet.

Schließlich werden bei kleinen Frequenzen $\omega \ll \Omega$ nach Abschn. II beide W (bei genügend großem ω_0 und nicht zu großem Ω) sehr klein und einer davon, für die ordinäre Welle, imaginär. Die beiden β gehen gegen Unendlich. Dann werden beide Terme der obigen Gl. (8) sehr klein und es geht so gut wie nichts durch die Schicht hindurch. Damit in diesem Gebiet $n_l^2=1$ wird, muß $\Omega=\omega_0^2/\omega$ sein. Das erforderte für das ionosphärische Plasma mit $\omega_{\rm 0max}=2\pi\cdot 10^7\,H$ und für

 $\omega=2\pi\cdot 10^4$ H ein Ω von $2\pi\cdot 10^{10}$ H, d.h. ein Magnetfeld von $\sim\!3500$ Gß und bei kleinen Frequenzen noch viel mehr, d.h. in allen Fällen ist im ionosphärischen Plasma bei Frequenzen unter $10~{\rm kH}~n_l^2$ äußerst großgegen 1, auch noch in der E-Schicht. Bei einem Entladungsplasma mit noch viel größerem ω_0 brauchte man dazu Magnetfelder von $10\,000$ facher Größe und mehr.

c) Durchgang durch eine Schicht mit veränderlicher DK

Nachdem sich zeigt, daß wegen des großen ω_0 bei mäßigem Ω langsame Wellen nach Abschn. IV a und b an unstetigen Schichtgrenzen fast vollkommen reflektiert werden, soll auch der Fall von Schichten deren Elektronendichte stetig verläuft kurz betrachtet werden. Wir betrachten nur den Fall der extraordinären Welle, die ein Medium durchläuft bei dem n_L von 1 bis auf sehr hohe Werte ansteigt und dann allmählich wieder auf 1 absinkt.

Der Durchgang elektromagnetischer Wellen durch eine Schicht mit veränderlicher Elektronendichte läßt

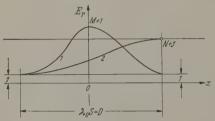


Abb. 3. Kurve 1: Symmetrische Epstein-Schieht, Kurve 2: monotoner Übergang

sich auch für den Fall einer allmählich auf sehr hohe positive Werte von $\varepsilon_l/\varepsilon_0$ ansteigenden und dann wieder auf $\varepsilon_l=\varepsilon_0$ abfallenden DK nach der bekannten Arbeit von K. Rawer [9] berechnen. Während Rawer auf einer Methode von Epstein [10] aufbauend, den Fall abnehmender DK innerhalb der Schicht behandelt, ist es durch Einführung negativer Werte der Konstanten M und N [in Gl. (3), (4) der Rawerschen Arbeit] möglich, einen Verlauf der DK von der Form

$$\frac{\varepsilon_l}{\varepsilon_0} = \varepsilon_r = 1 + N \frac{e^{\varkappa x}}{1 + e^{\varkappa x}} + M \frac{4e^{\varkappa x}}{(1 + e^{\varkappa x})^2}$$

zu erhalten. Der Fall M=0 beschreibt den allmählichen Anstieg der DK vom Werte 1 bei genügend negativen Werten von x bis auf 1+N für genügend große positive Werte von x (monotoner Übergang). Der Fall N=0 beschreibt die symmetrische Schicht, bei der ε_r vom Werte 1 bei großen positiven und negativen x auf den Wert $\varepsilon_{\max}=1+M$ bei x=0 ansteigt, Abb. 3. Dabei ist die "relative Schichtdicke" $S=2\frac{k}{\kappa}\left(k=\frac{\omega}{c}=\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)$ und $\lambda_0 S$ entspricht der "gesamten Schichtdicke" D.

1. Symmetrische Schicht

In diesem Fall ergibt sich der Reflexionsfaktor für eine senkrecht auf die Schicht auftreffende Welle ohne Dämpfung zu

$$RR^* = rac{\cos^2\pi\,d_2}{\cos^2\pi\,d_2 + \sinh^2\pi\,S}$$

und der Durchlässigkeitsfaktor wird

$$egin{align} FF^* &= rac{\sinh^2 \pi \, S}{\cos^2 \pi \, d_2 + \sinh^2 \pi \, S} \ d_2 &= rac{1}{2} \, \left| 1 + 4 \, S^2 \, \epsilon_{r_{
m max}}
ight. \end{array}$$

wobei $M=\varepsilon_{r_{\max}}-1\approx\varepsilon_{r_{\max}}$ ist. Mit steigender I fung nimmt die Durchlässigkeit ab und es wird |F| proportional e^{-S_F} (s. die Rawersche Arbeit, S. Aus den obigen Formeln folgt $RR^*+FF^*=1$ es sein muß. Da $\cos\pi d_2$ zwischen +1 und liegt, ist die Reflexion gering, wenn $\sinh^2\pi S \gg$ Begnügt man sich mit $\sinh \varrho = 2$, $\varrho = 1,44$, so dann mit RR^* höchstens $\frac{1}{5}$, $\pi \frac{D}{\lambda_0} \approx 1,44$, D sein. Setzt man für die Ionosphäre $D\approx 800$ kr so muß λ_0 kleiner sein als 1600 km, was einer Free von ≈ 190 H entspricht. Größere Frequenze: 190 H herab dürften also die Schicht bei ger Dämpfung in erheblichem Maße durchsetzen. Da ist für 10 H, $\lambda_0 = 30000$ km, also viel zu groß. Es calso, abgesehen von dem unwahrscheinlichen $\pi d_2 = (2g+1)\frac{\pi}{2}$ bei der Schichtdicke

$$D = \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\varepsilon_{r_{\max}}}} \cdot \sqrt{(2g+1)^2 - 1}$$

bei 10 H nur ein sehr geringer Prozentsatz an Erdurch die Schicht nach außen abgehen, wenn von der erwähnten Ioneneinwirkung absieht. Es $\lambda_0 \gtrsim 2D$ sein, falls nur wenig reflektiert werden wobei dann der Wert von $\varepsilon_{r_{\max}}$ keinen Einfluß

2. Monotone Übergangsschicht

Hier ergibt sich ohne Dämpfung

$$RR^* = \frac{\sinh^2\left[\frac{\pi S}{2}\left(1 - \sqrt{\varepsilon_{r_{\max}}}\right)\right]}{\sinh^2\left[\frac{\pi S}{2}\left(1 + \sqrt{\varepsilon_{r_{\max}}}\right)\right]}.$$

Sind die Argumente der sinh Funktionen gegen 1, wobei

also
$$\sqrt{arepsilon_{r_{
m max}}}\gg 1, \ rac{D}{\lambda_{
m 0}}\gg rac{2}{\pi\sqrt{arepsilon_{r_{
m max}}}}$$

angenommen ist, so entsteht

$$|R| = e^{-\pi S} = e^{-\pi \frac{D}{\lambda_0}}.$$

Es muß also die Dicke der Übergangsschicht anähert gleich oder größer als die Vakuumwellen sein, damit die Reflexion klein wird und unabhavon der Größe von $\varepsilon_{r_{\max}}$.

Sind dagegen die Argumente der sinh-Fund

Sind dagegen die Argumente der sinn-rung sehr klein, $S \rightarrow 0$, so wird $|R| = \frac{1 - \sqrt{\varepsilon_{r_{\max}}}}{1 + \sqrt{\varepsilon_{r_{\max}}}}$, d.1 ergibt sich die übliche Reflexionsbedingung bei stetigem Übergang.

3. Schichten anderer Verteilung

Falls die Schicht nach Abb. 3 verläuft, sollt bis $\approx 800~\mathrm{km}$ Dicke für Frequenzen $> \approx 200~\mathrm{H}$ dlässig sein, für kleinere Frequenzen dagegen nicht fragt sich aber, ob der Verlauf der Elektronend in der Ionosphäre diesem Bild entspricht, sonder man nicht ein mehr stufenweises Ansteigen der Dhat, zuerst in der D- und E-Schicht und schlie bei der F-Schicht. Sollte das der Fall sein, so es besser, jeweils die Formel für die monotone t gangsschicht bei jedem Anstieg zu benützen. Ni man z. B. für die F-Schicht einen Anstieg auf 10 Länge bis zum Maximum an, so würde etwa $\lambda \le 10$ als Durchlässigkeitsbedingung gelten, mit einer

n viel rascheren Anstieg in $\sim \! 10\,\mathrm{km}$, was eine quenz von mindestens $30\,\mathrm{kH}$ zum Durchtritt stigte. Die größte DK würde hier mit $\varepsilon_{r_{\mathrm{max}}} = \frac{\omega_{0\,\mathrm{m}}^{2}}{\Omega\,\omega}$ $\omega_{0_{\mathrm{max}}} \approx 2\pi \cdot 3,5 \cdot 10^{6}\,\mathrm{und}\,\Omega \approx 10^{7}\,\mathrm{H}\,\mathrm{bei}\,\omega = 2\pi \cdot 3 \cdot 10^{4}$ a $1300\,$ sein, d.h. bei $30\,\mathrm{kH}\,$ immer noch groß in 1. Die E-Schicht wäre darnach für kleinere quenzen ein viel größeres Hemmnis, als die F-cht.

Zusammenfassung

Is wird die Ausbreitung elektromagnetischer Weln gedämpften Plasmen bei "kleinen" Frequenzen, $\omega \ll \nu$ (ν Stoßzahl) diskutiert. Ohne Magnetfeld bei Ausbreitung quer zum Magnetfeld verhält das Plasma wie ein Leiter. Bei Ausbreitung längs Magnetfeldes verhält sich für $\Omega \ll \nu$ das Plasma wie ein Leiter. Dagegen treten für $\Omega \gg \nu$, d. h. Ω die beiden bekannten Wellenarten auf, von dedie ordinäre eine negative DK und die extranäre eine positive DK und nur geringe Dämpfung tzt. Beide DK werden bei kleinen Frequenzen hoch. Die Elektronenbewegung quer zum Mafeld verläuft in diesem Fall wie im Vakuum bei ischen Feldern. Gilt $\Omega_J \gg \nu_J$ auch für die Ionen, och wingen Elektronen und Ionen synchron mit

gleicher Amplitude in der gleichen Richtung und das Plasma hat für Frequenzen $\omega \ll \Omega_J$ die wirksame DK I, wie das Vakuum. Wellen mit $\omega \ll \Omega_e$ (aber nicht mit $\omega \ll \Omega_J$) längs eines Magnetfeldes werden bei kleinen Frequenzen an unstetigen Übergängen Luft-Plasma wegen der sehr hohen DK des Plasmas fast vollständig reflektiert. Bei allmählichem Übergang können sie bei geringer Dämpfung fast reflexionsfrei hindurchgehen, wenn die Wellenlänge gleich oder kleiner als die Schichtdicke oder der Anstieg der Schicht bis zum Maximum ist.

Literatur: [1] SCHUMANN, W.O.: Z. angew. Phys. 8, 482 (1956). — [2] SCHUMANN, W.O.: Z. angew. Phys. 10, 26 (1958). — [3] SCHUMANN, W.O.: Z. angew. Phys. 7, 284 (1955). — [4] SCHUMANN, W.O.: Elektrische Wellen, S. 93. München: C. Hanser 1948. — [5] SCHUMANN, W.O.: Sitzgsber. bayer. Akad. Wiss. 1948, 257. — [6] SCHUMANN, W.O.: Arch. elektr. Übertragung 4, 173 (1950). — [7] GOLDSTEIN, L.: Adv. Electronics and Electronphysics 7, 487 (1955). — IRE Transactions, Vol. MTT-6. Jan. 1958, S. 19. — [8] ALFVÉN, H.: Cosmical Electrodynamics, S. 41. Oxford: Clarendon Press 1950. — [9] RAWER, K.: Ann. d. Physik 5, 385 (1939); 5, 294 (1942). — [10] EPSTEIN, P.S.: Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 627 (1930). — [11] STOREY, L. R.: Phil. Trans. Roy. Soc. Lond., Ser. A 246, 908 (1953). — [12] SCHUMANN, W.O.: Z. angew. Phys. 9, 373 (1957).

Professor Dr. Winfried Otto Schumann, Elektrophysikalisches Institut der TH München

Über den Einfluß asymmetrischer Verteilungsfunktionen bei Präzisionsgitterkonstantenmessungen

Von Manfred Wilkens

Mit 6 Textabbildungen

(Eingegangen am 11. Juli 1958)

I. Einleitung

n letzter Zeit ist verschiedentlich über Gitterstantenmessungen berichtet worden, bei denen ein er $\Delta a/a$ von etwa $5\cdot 10^{-6}$ angegeben wurde [1], [3], [3a].

Lieht man in Betracht, daß weder die Wellene λ der Eigenstrahlung noch die Gitterkonstante a, für eine gegebene Interferenz, der Netzebenenand d scharf definierte Größen sind, daß ferner Meßvorrichtung mit Fehlern behaftet ist, so bt sich die Frage, welche Meßfehler durch das mmenwirken dieser Umstände entstehen können, z.B. durch die bei Gitterkonstantenmessungen oft wandte Extrapolationsmethode nicht zu elimien sind.

Die folgenden Überlegungen ergeben, daß insbelere die Asymmetrie der spektralen Intensitätseilungen der Eigenstrahlungen von Cr-K bis Cu-K ystematischen Fehlern $\Delta a/a$ der Größenordnung führen kann. Sie werden verursacht durch mande Kristallgüte und nichtideale Meßvorrichtung, durch die Einflüsse, die verbreiternd auf das sachtete Interferenzbild wirken. Die Ausschaltung er Fehler aus dem Meßresultat ist auch unter nders günstigen Umständen nur näherungsweise lich.

II. Erläuterung der benützten Funktionen

Bevor die verschiedenen Einflüsse auf das Meßltat abgeschätzt werden, ist eine Erläuterung istehender Funktionen zweckmäßig. a) Die Spektralfunktion $S(\lambda)$,

b) die Kristallfunktion K(d),

c) die kristalleigene Streuintensitätsfunktion $J(\Theta)$,

d) die beobachtete Streuintensitätsfunktion $B(\Theta)$,

e) die Apparatefunktion $G(\varepsilon)$.

Von diesen Funktionen werden einige Kenngrößen benötigt, die wie folgt definiert sind und zwar an einer beliebigen Funktion f(x), die wie die oben erwähnten nirgendwo negativ ist und beiderseits ihres Maximums mehr oder minder rasch gegen Null abfällt (Abb. 1).

Das Maximum liegt bei

$$x_{f, \text{Max}}$$
. (1)

Der Schwerpunkt liegt bei

$$\bar{x}_f = \frac{\int f(x) x \, dx}{\int f(x) \, dx}. \tag{2}$$

Mit $f(x_f^+)$ und $f(x_f^-) = \frac{1}{2} f(x_{f, \text{Max}})$ und $x_f^+ > x_{f, \text{Max}}$; sowie $x_f^- < x_{f, \text{Max}}$ ist die Halbweite

$$\Delta x_{t,\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (x_t^+ - x_t^-) \tag{3}$$

(= die Hälfte der vollen Halbwertsbreite, Benennung im Anschluß an [4]) und die Mitte der Halbwertshöhe

$$x_{f,H} = \frac{1}{2} (x_f^+ + x_f^-).$$
 (4)

Der Index f wird dort fortgelassen, wo die Variable eindeutig auf die Funktion verweist.

Gelegentlich wird eine Deltafunktion mit folgender Bedeutung benötigt:

 $\delta(x) = 0$ für $x \neq 0$; $\delta(0) = \infty$; $\int \delta(x) dx = 1$. (5)

Tabelle 1. Asymmetriererhältnisse v, relative Halbweiten Al/Amax und Dubletteauflösungen verschiedener Eigenstrahlun

			9. Max					
	Nach Parratt [7]					Nach Barden und Shaw [8]		
	ν	$\frac{\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}}{\lambda_{\text{Max}}} \cdot 10^4$	$\frac{\lambda_H - \lambda_{ ext{Max}}}{\lambda_{ ext{Max}}} \cdot 10^5$	$\frac{\lambda_{\alpha_2} - \lambda_{\alpha_1}}{\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}}^{\dagger}$	ν	Δλ ₂ /λ _{Max} · 10 ⁴ ††	$\frac{\lambda_H - \lambda_{\mathrm{Max}}}{\lambda_{\mathrm{Max}}}$	
Cr-K- α_1 α_2 β	1,33 1,14	1,70 1,98	2,4 1,3	9,2	1,39 1,02 1,51	1,85 2,41 2,51	3,0 0,3 5,2	
Fe-K- α_1 α_2 β	1,60 1,35	2,04 2,32	4,7 3,5	9,4	1,61 1,26 1,72	2,19 2,55 2,60	5,1 2,9 6,7	
$\alpha_1 \dots \alpha_n \dots \alpha_n \dots \alpha_n \dots \alpha_n \dots \alpha_n \dots \alpha_n \dots \dots$	1,44 1,30	1,75 2,29	3,2	10,7	1,36 $1,29$ $1,72$	1,90 2,45 3,02	2,9 3,1 7,9	
Ni-K- α_1 α_2 β	1,22 1,25	1,53 2,17	1,5 2,4	10,5	1,23 1,20 1,28	1,59 2,49 3,31	1,6 2,3 4,1	
Cu- K - α_1 α_2 β	1,15 1,28	1,50 2,06	1,1 2,5	14,0	1,12 1,27 1,14	1,60 2,18 3,05	0,9 2,6 2,5	
$Mo-K-\alpha_1 \ldots \alpha_1 \ldots$	1,00 1,03	1,90 1,96	0,0 0,3	31,0				

Für die Halbweiten sind Mittelwerte der α₁-α₂-Komponenten eingesetzt.

†† Die kleinsten der beobachteten, nicht korrigierten Halbweiten.

Von einer wichtigen Eigenschaft der Faltungsintegrale wird mehrfach Gebrauch gemacht: Sind \bar{x}_{j} , \bar{x}_{g} , \bar{x}_{h} die Schwerpunkte der Funktionen f(x), g(x), h(x), dann gilt

$$\bar{x}_h = \bar{x}_f + \bar{x}_g$$
 mit $h(x) = \int f(x - y) g(y) dy$. (6)

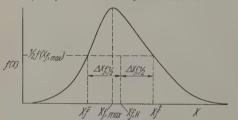


Abb. 1. Erläuterung der Kenngrößen von f(x)

a) $S(\lambda)$ ist die spektrale Intensitätsverteilung der Eigenstrahlung. Nach Literaturangaben (z.B. [5]) liegen bei den für Gitterkonstantenmessungen gebräuchlichen Eigenstrahlungen (Cr-K bis Cu-K)

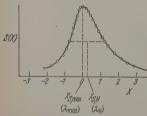


Abb. 2. Analytische Darstellung der Spektralfunktion $S(\lambda)$. s(x) nach Gl. (7) mit $t^*=1,25$, $t^*=0,75$, y=1,65. o Punkte aus der von Parratur [7] angegebenen $S(\lambda)$ -Funktion für Fe-K α_1

die relativen Halbweiten $\Delta \lambda_{i}/\lambda_{\text{Max}}$ alle in der Größenordnung 1,5 bis $2 \cdot 10^{-4}$. Da wegen der Braggschen Gleichung

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = -\frac{\Delta a}{a}$$

gilt, folgt daraus, daß die relativen Halbweiten etwa 50mal größer sind als die eingangs erwähnten, bislang höchsten Genauigkeitsangaben.

Eine Hauptschwierigkeit bei Präzisionsgitterkonstantenmessungen liegt nun darin, daß gerade diese Eigenstrahlungen asymmetrische Spektralfunktionen haben. Nach [6] wird die Asymmetrie durch das Asymmetrieverhältnis $v=rac{\lambda^+-\lambda_{
m Max}}{\lambda_{
m Max}-\lambda^-}$ gekennzeichnet. Etwas anschaulicher als dieses Verhältnis ist der

Ausläufern, gut durch eine Funktion y=s(x) wie gegeben mit $x=\pm \sqrt{\frac{1}{y}-1}+\sigma(1-y); x=\frac{\lambda-\lambda_{10}}{4\lambda_{10}}$ Der Ausdruck $\frac{2+\sigma}{2-\sigma}$ entspricht in dieser Darstell. dem Asymmetrieverhältnis v nach [6]. Einfacher nahezu gleichwertig ist folgende Darstellung: $S(x) = \left[1+\left(rac{x}{t^+}
ight)^2
ight]^{-1} \quad ext{für} \quad x \geq 0\,,$ $S(x) = \left[1+\left(rac{x}{t^+}
ight)^2
ight]^{-1} \quad ext{für} \quad x \leq 0\,,$ mit $x = rac{\lambda-\lambda_{ ext{Max}}}{\Delta\lambda_{rac{1}{2}}}\,, \quad t^+ = rac{\lambda^+-\lambda_{ ext{Max}}}{\Delta\lambda_{rac{1}{2}}}\,,$ $t^- = rac{\lambda_{ ext{Max}}-\lambda^-}{\Delta\lambda_{rac{1}{2}}}\,, \quad rac{t^+}{t^-} = r\,.$

(relative) Abstand zwischen dem Maximum und Mitte der Halbwertshöhe $\frac{\lambda_H - \lambda_{ ext{Max}}}{2} = \frac{v - 1}{v}$

Tabelle 1 enthält einige in der Literatur veröf lichte Werte. Man sieht, daß die Messungen

PARRATT [7] und von BEARDEN und SHAW [8] züglich des Abstandes $\frac{\lambda_H - \lambda_{\text{Max}}}{\lambda_{\text{max}}}$ – abgesehen Cr-Kα und Fe-Kα — nur wenige 10-6 von eina abweichen. PARRATT hat die Verbreiterung der Doppelspektrometer) gemessenen gegenüber den ren Halbweiten Δλ, durch eine halbempirische rekturgleichung ausgeschaltet. Ebenso hat er insbesondere bei Cr-Ka und Fe-Ka schon merk. Überlappung der α_1 - α_2 -Komponenten, allerdings

gefühlsmäßig, berücksichtigt. Somit scheinen s

interessiert, wird eine analytische Darstellung

experimentell gefundenen $S(\lambda)$ -Kurven benötigt. N

[9] werden die beobachteten Kurven, abgesehen von

Da in Abschnitt VI die Asymmetrie beson

Werte etwas verläßlicher zu sein.

Abb. 2 zeigt, daß diese Darstellung z.B. dem v [7] mitgeteilten Profil $S(\lambda)$ für Fe-K α_1 bis in Flanken hinein mit befriedigender Genauigkeit er spricht.

b) Die Kristallfunktion K(d) enthält alle, die Interenz verbreiternden Einflüsse, die durch die Qualides Kristalles bzw. des Kristallpulvers bedingt d. (Der Einfachheit halber seien die folgenden erlegungen auf kubische Substanzen beschränkt, denen Netzebenenabstand d und Gitterkonstante abekannten (hkl) gleichwertig sind.) Häufig wird sich dabei im wesentlichen um innere Spannungen pannungen II. Art) handeln, die man als endliche rteilungsfunktion der Netzebenenabstände d deuten nn. Deswegen ist d als Variable gewählt. Durch ilchenkleinheit verursachte Interferenzverbreiterunı wirken sich für eine gegebene Interferenz in gleier Weise aus. Da die verschiedene Winkelabhängigt beider Effekte im Rückstrahlbereich von unterordneter Bedeutung ist, soll K(d) auch die Teilchen-Benverbreiterung beschreiben. Die endliche Breite Totalreflexionsbereiches, wie sie nach der dynaschen Theorie des Interferenzvorganges zu erwarten sei gleichfalls in K(d) enthalten. Für die folgenden erlegungen soll aber die Möglichkeit ausgeschlossen rden, daß das Präparat Stapelfehler enthält, z.B. verformten kubisch-flächenzentrierten Metallen, durch Interferenzverschiebungen entstehen, die rch Abweichungen von der quadratischen Form ischen Netzebenenabstand und Millerschen Indizes d) verursacht werden [10], [11].

c) Die Braggsche Gleichung $\lambda/d=2\cdot\sin\Theta$ ordnet em Wert des Quotienten λ/d einen bestimmten nkel Θ zu. Sind $S(\lambda)$ und K(d) nicht beide durch e Deltafunktion nach Gl. (5) darzustellen, d.h. hat e der beiden oder haben beide Funktionen eine dliche Breite, dann entsteht bei dem Interferenztgang im Kristall für eine gegebene Netzebenentar die kristalleigene Verteilungsfunktion der Streuensitäten $J(\Theta)$ ebenfalls mit endlicher Breite. Wie se Funktion, die nur bei idealer Apparategeometrie beobachten wäre, von $S(\lambda)$ und K(d) abhängt, in Abschnitt V und VII abgeleitet.

d), e) Sei einmal angenommen, daß $S(\lambda)$ und K(d) rch die Deltafunktionen $\delta(\lambda - \bar{\lambda})$ und $\delta(d - \bar{d})$ geom sind, dann reflektiert der Kristall nur unter

em ganz bestimmten Winkel $\Theta_0 = \arcsin\frac{\lambda}{2\bar{d}}$, und ist auch $J(\Theta) = \delta(\Theta - \Theta_0)$. Man beobachtet aber tzdem eine Streuintensitätsfunktion $B(\Theta)$ mit ender Breite in der näheren Umgebung von Θ_0 , und in sem Fall gilt die Beziehung $B(\Theta) = B(\Theta_0 + \varepsilon) = 0$, wobei ε eine Hilfsvariable ist und $G(\varepsilon)$ die volkommene Apparategeometrie beschreibt. Hat er $J(\Theta)$ eine endliche Breite, was in Wirklichkeit mer der Fall ist, so ergibt sich die beobachtete ensitätsverteilung durch das Faltungsintegral

$$B(\Theta) = \int J(\Theta - \varepsilon) G(\varepsilon) d\varepsilon. \tag{8}$$

n erkennt, daß $B(\Theta)$ nur dann mit der kristallenen Streuintensitätsfunktion $J(\Theta)$ identisch ist, an die Apparatefunktion durch eine Deltafunktion $E(E) = \delta(E)$ gegeben ist, d.h. bei idealer Apparatemetrie. In dem Maße, in dem das nicht zutrifft, d $B(\Theta)$ und $J(\Theta)$ verschieden, und je nach Form dausdehnung von G(E) können insbesondere $\Theta_{B, \text{Max}}$, H_{A} , H_{A} verschieden von den entsprechenden Kennsißen $\Theta_{J, \text{Max}}$, $\Theta_{J, H}$, H_{A} , H_{A} sein.

In Gl. (8) ist vorausgesetzt, daß für eine gegebene erferenz die Funktion $G(\varepsilon)$ in dem Winkelintervall

in dem $J(\theta) \pm 0$ ist, ihrerseits nicht oder nur in einem zu vernachlässigendem Maße vom Winkel θ abhängt. Diese Voraussetzung ist in allen gebräuchlichen Meßvorrichtungen ausreichend erfüllt.

Für verschiedene Interferenzen ist $G(\varepsilon)$ im allgemeinen merklich verschieden. Die Abhängigkeit des zu $G(\varepsilon)$ gehörigen Schwerpunktes $\overline{\varepsilon}$ vom Winkel Θ wird im nächsten Abschnitt im Zusammenhang mit der Extrapolationsmethode noch näher besprochen.

III. Die Extrapolationsmethode

Es sei nun vorläufig angenommen, daß die zu $J(\Theta)$ gehörigen Kenngrößen $\Theta_{J,\mathrm{Max}},\,\Theta_{J,H},\,\bar{\Theta}_J$ mit den entsprechenden Wellenlängen $\lambda_{\mathrm{Max}},\,\lambda_H,\,\bar{\lambda}$ und der Braggschen Gleichung den gesuchten Netzebenenabstand d ergeben. In wie weit das zutrifft, wird in Abschnitt V und VII noch gesondert untersucht.

Da die $S(\lambda)$ -Funktionen wie erwähnt im allgemeinen nicht symmetrisch sind, $\lambda_{\text{Max}} + \lambda_H + \bar{\lambda}$, bedarf es einer vorherigen Festlegung, welche Kenngröße von $S(\lambda)$ und von $B(\Theta)$ zur Gitterkonstantenmessung benützt werden soll. Meist bezieht man sich auf die Wellenlänge λ_{Max} , die den Literaturangaben entspricht, und mißt im Experiment den Winkel $\Theta_{B,\text{Max}}$ von $B(\Theta)$. Eine andere Möglichkeit ist, $\bar{\lambda}$ und $\bar{\Theta}_B$ oder auch λ_H und $\Theta_{B,H}$ zu benutzen. Um nun die durch $G(\varepsilon)$ erzeugte Verschiebung von $\Theta_{B,\text{Max}}$, $\Theta_{B,H}$, $\bar{\Theta}_B$ gegenüber den entsprechenden, aber nicht unmittelbar meßbaren Größen von $J(\Theta)$ auszuschalten, wendet man oft die Extrapolationsmethode an, die im folgenden kurz skizziert werden soll.

Normalerweise wirken in einem Apparat gleichzeitig und unabhängig voneinander mehrere Einflüsse (Fehler), die entweder nur eine Verbreiterung oder nur eine Verschiebung der beobachteten Streuintensitätsfunktion $B(\theta)$ gegenüber der kristalleigenen Funktion $J(\theta)$ oder beides zugleich erzeugen. Jedem dieser Fehler (Index $_i)$ kann man eine Apparatefunktion $G_i(\varepsilon)$ zuordnen [12]. Zwei dieser Funktionen G_i und G_k setzen sich wieder mit einem Faltungsintegral zusammen.

$$G_{ik}(\varepsilon) = \int G_i(\varepsilon - \eta) G_k(\eta) d\eta. \tag{9}$$

Durch wiederholte Anwendung dieser Operation erhält man aus den einzelnen Funktionen $G_i(\varepsilon)$ eine resultierende Funktion $G(\varepsilon)$. Nun ist mit dieser Darstellung nicht viel gewonnen, da man im allgemeinen die Größe des Fehlers nicht genau kennt, der durch die einzelnen Apparatefunktionen beschrieben wird. Meist läßt sich aus der vorgegebenen Apparategeometrie nur entnehmen, wie die Funktionen $G_i(\varepsilon)$ ihrerseits vom Winkel Θ abhängen, und man begnügt sich dabei mit der Angabe des Schwerpunktes $\bar{\epsilon}_i$ von $G_i(\varepsilon)$, für den i.a. in ausreichender Näherung die Darstellung gilt: $\overline{\varepsilon}_i = c_i \cdot f_i(\Theta)$. Dabei ist für die einzelne Messung die Konstante c_i eine Apparatekonstante, die die Größe z.B. der Horizontaldivergenz oder den Absorptionskoeffizienten enthält, und $f_i(\Theta)$ eine reine Winkelfunktion, die nur vom Meßverfahren und der Art des betreffenden Fehlers abhängt. Nach Gl. (6) und (9) gilt dann für den Schwerpunkt der resultierenden Funktion $G(\varepsilon)$:

$$\overline{\varepsilon} = \sum \overline{\varepsilon}_i = \sum c_i f_i(\Theta). \tag{10}$$

Bei Gitterkonstantenmessungen wird meist nur der Rückstrahlbereich $\Theta \ge 60^\circ$ ausgenützt. Es ist nun bekannt, daß bei vielen Meßverfahren die einzelnen $\bar{\epsilon}_i$ Winkelfunktionen $f_i(\theta)$ haben, die bei genügend hohen Winkeln θ sehr ähnlich sind und ungefähr proportional zu $\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ gegen 0 gehen. (Bezüglich Zählrohrgoniometermessungen siehe [12], [13], [14]. Debye-Scherrer- und fokussierende Rückstrahlverfahren sind ausführlich z.B. in [15] behandelt.) Auf die Apparatefunktion der Vertikaldivergenz, für die diese Näherung nicht immer gilt, wird in Abschnitt VIII noch eingegangen.

Beschränkt man sich auf solche Apparateeinflüsse, deren $f_i(\Theta)$ ausreichend ähnlich sind, so kann man näherungsweise setzen

$$\bar{\varepsilon} = f_{\Sigma}(\Theta) \cdot \Sigma c_i, \tag{11}$$

wobei die Größe von Σc_i nicht bekannt ist und $f_{\Sigma}(\Theta)$ die Winkelfunktion $f_i(\Theta)$ ist, die dem voraussichtlich größten der Schwerpunkte $\overline{\varepsilon}_i$ zukommt.

Sieht man einmal von dem Einfluß der winkelabhängigen Dispersion nach Abschnitt V ab und bezieht die Gitterkonstantenmessung auf $\bar{\lambda}$ und $\bar{\Theta}_J$, so folgt aus Gl. (6) und (8), daß man statt des gesuchten Schwerpunktes $\bar{\Theta}_J$ den Schwerpunkt

$$\overline{\Theta}_{R} = \overline{\Theta}_{J} + \overline{\varepsilon} \tag{12}$$

mißt. Der systematischen Winkelfehlmessung $\bar{\varepsilon}$ entspricht eine Gitterkonstantenfehlmessung $\Delta a/a =$ $-\cot \Theta \cdot \overline{\varepsilon} = -\sum c_i \cdot f_{\Sigma}(\Theta) \cdot \cot \Theta$. Trägt man also die an den einzelnen Interferenzen gemessenen Gitterkonstanten über der Funktion $f_{\Sigma}(\Theta) \cdot \cot \Theta$ auf und extrapoliert auf $\Theta = 90^{\circ}$, so erhält man $\Delta a/a = 0$, d.h. die richtige Gitterkonstante ohne Kenntnis der $\sum c_i$. Ist der zu $f_{\Sigma}(\Theta)$ gehörige Schwerpunkt $\overline{\varepsilon}_i$ wesentlich größer als die übrigen $\bar{\varepsilon}_i$ oder sind die verschiedenen $f_i(\Theta)$ -Funktionen hinreichend ähnlich, dann kann man linear auf $\Theta = 90^{\circ}$ extrapolieren. Ist das innerhalb des statistisch bedingten Streubereiches der an den einzelnen Interferenzen gewonnenen Meßwerte nicht möglich, dann ist entweder die Extrapolationsfunktion $f_{\Sigma}(\Theta) \cdot \operatorname{cotg} \Theta$ falsch gewählt oder es treten in der Meßapparatur mehrere $\bar{\varepsilon}_i$ etwa der gleichen Größenordnung und mit wesentlich verschiedenen Winkelfunktionen $f_i(\Theta)$ auf. Um eine mehr gefühlsmäßige krummlinige Extrapolation, die wegen der darin enthaltenen Willkür nicht sehr verläßlich erscheint, zu vermeiden, muß die Meßanordnung soweit verändert werden, bis eine lineare Extrapolation über eine Funktion möglich ist, die natürlich durch die Meßanordnung begründet sein muß. Letztere Bedingung ist um so wesentlicher, je weiter die letzte Interferenz von $\Theta = 90^{\circ}$ entfernt ist. Das ist z.B. an den verschiedenen Extrapolationsfunktionen zu erkennen, die [16] und [16a] versuchsweise bei Debye-Scherrer-Aufnahmen angewandt haben.

Bislang bezogen sich die Überlegungen auf die Messung von Interferenzschwerpunkten. Dieses ist aber in der Praxis sehr mühsam und wegen des kontinuierlichen Überganges zwischen Interferenzausläufern und Streuuntergrund kaum mit der Genauigkeit möglich, die bei höchsten Anforderungen angestrebt wird. Die folgenden Betrachtungen befassen sich deshalb nicht mehr mit Schwerpunktsmessungen sondern vorwiegend mit Messungen des Maximums $\Theta_{B,\mathrm{Max}}$. In diesem Falle setzt man bei der Anwendung der Extrapolationsmethode voraus, daß ähnlich zu

Gl. (12) eine Beziehung

$$\Theta_{B,\,\mathrm{Max}} = \Theta_{J,\,\mathrm{Max}} + \overline{\varepsilon}$$

besteht. Wenn diese Gleichung genau erfüllt wällim folgenden wird diese Frage ausführlich u ersucht — dann ließen sich die gleichen Folgerung wie oben ziehen, und man erhielte nach Extrapolio über $f_{\Sigma}(\Theta) \cdot \cot \Theta$ auf $\Theta = 90^{\circ}$ die richtige Gleichenstante.

IV. Problemstellung

Eine Prüfung der Gl. (13) bedeutet eine Usuchung der Lage des Maximums von Gl. (8)

$$B(\Theta) = \int J(\Theta - \varepsilon) G(\varepsilon) d\varepsilon$$

in Abhängigkeit von den Funktionen $G(\varepsilon)$ und J wobei letztere ihrerseits von den zwei unabhänge Funktionen $S(\lambda)$ und K(d) gebildet wird. Um Verhältnisse übersehbar zu halten, muß man sie einfachen, indem bezüglich der drei Funktionen idealisierten Modellen ausgegangen wird.

Unter gewissen Voraussetzungen lassen sich

fache Aussagen machen:

1. Sind $J(\Theta)$ und $G(\varepsilon)$ beide symmetrische Futionen, bei denen also Schwerpunkt und Maxin koinzidieren, dann hat $B(\Theta)$ das Maximum bei $\Theta_B = \overline{\Theta}_B = \overline{\Theta}_J + \overline{\varepsilon} = \Theta_{J, \text{Max}} + \overline{\varepsilon}$, d.h. Gl. (13) ist erf! Das folgt aus Gl. (6) und aus der Tatsache, dall diesem Fall die resultierende Funktion $B(\Theta)$ ell falls symmetrisch ist.

2. Sind $J(\Theta)$ oder $G(\varepsilon)$ oder beide Funktic asymmetrisch und ist $G(\varepsilon)$ eine "schmale" Funk gegenüber $J(\Theta)$, dann gilt Gl. (13) näherungsw $\Theta_{B, \text{Max}} \approx \Theta_{J, \text{Max}} + \bar{\varepsilon}$. Man ersieht das aus dem Grofall, wenn $G(\varepsilon) = \delta(\varepsilon - \bar{\varepsilon})$ nach Gl. (5) ist. Die 1 tung in Gl. (8) bewirkt dann nur eine Koordinat verschiebung ohne Profiländerung: $B(\Theta) = J(\Theta - \bar{\omega})$

3. Ist $J(\Theta)$ ausreichend schmal gegen $G(\varepsilon)$, ergibt sich aus dem Fall 2. durch Vertauschen $J(\Theta)$ mit $G(\varepsilon)$: $\Theta_{B, \max} \approx \overline{\Theta}_J + \varepsilon_{\max}$. Dieser Fall dü aber im Rückstrahlbereich im allgemeinen ohne deutung sein. Dagegen beruhen die theoretischen 1 experimentellen Untersuchungen von [16] und [1 bezüglich des Debye-Scherrer-Verfahrens auf die Voraussetzung.

Trifft keiner dieser drei Fälle zu, sind beide Futionen $J(\Theta)$ und $G(\varepsilon)$ von etwa gleicher Breite, de hängt die Lage des Maximums von $B(\Theta)$ stark von speziellen Gestalt und Asymmetrie beider Funktion ab, und allgemeine Aussagen lassen sich nicht mach

Bei Anwendung der in Abschnitt III geschilder Extrapolationsmethode wird nun stillschweigend genommen, daß die Voraussetzungen von 1. oder wenigstens in ausreichender Näherung erfüllt sit Um einen Anhalt dafür zu bekommen, wie weit die Näherung reicht, werden im folgenden die in Tabelle 2 aufgeführten Einzelfälle durchgerechnet. 1 Angaben in den einzelnen Zeilen enthalten die weser lichen Voraussetzungen bezüglich der in den Spalte köpfen angegebenen Funktionen. Die Funktion, der Verhalten in Abhängigkeit dieser Voraussetzung untersucht werden soll, ist durch ein ? gekennzeichn Man erkennt, daß die eben unter 1. und 2. angegeben Fälle als Grenzfälle zu den in den Abschnitten VI w VIII behandelten Beispielen aufzufassen sind. Abschnitt V und VII wird die bislang noch nic gegebene Darstellung der Funktion $J(\Theta)$ aus de beiden Funktionen $S(\lambda)$ und K(d) besprochen.

Ш

Tabelle 2. Zusammenstellung der untersuchten Modelle

chnitt	S(\(\lambda\)	K(d)	$J(\Theta)$	$G(\varepsilon)$	$B(\Theta)$	$B(\Theta)_{\alpha 1} + B(\Theta)_{\alpha 2}$					
v	symmetrisch	$\delta(d-\overline{d})$?								
I	schwach asymmetrisch	$\delta(d-\overline{d})$	schwach asymmetrisch	symmetrisch	?						
n	schwach asymmetrisch	symmetrisch	?	symmetrisch	?	_					
ш	symmetrisch	$\delta(d-\overline{d})$	symmetrisch	schmal und asymmetrisch	?						
X	symmetrisch	, symmetrisch	symmetrisch	symmetrisch	symmetrisch	?					
7	Diskussion im Hinblick auf Präzisionsmessungen										
7	Chickenskin Dentation of the Chickens of the C										

Gleichzeitige Benützung verschiedener Eigenstrahlungen

Visuelle Filmvermessung

chnitt IX wird eine grobe Abschätzung vorgemen, in wie weit eine ungenügende Dubletteaufng der α_1 - α_2 -Komponenten einer Interferenz läschend auf das Meßresultat wirkt. Bei einer Dission der Ergebnisse in Abschnitt X wird dann bigt, daß eine Gitterkonstantenbestimmung im chluß an die Mitte der Halbwertshöhe, d.h. mit Wellenlänge λ_H und dem gemessenen Winkel $\Theta_{B,H}$ guten Präparaten und günstiger Apparategeomeunter Umständen Vorteile bietet, wenn höchste aufgkeiten angestrebt werden. In den letzten den Abschnitten ergeben sich einige Gesichtspunkte bei der gleichzeitigen Benützung mehrerer Eigenhungen und bei visueller Filmvermessung beachtet den müssen.

V. Darstellung der kristalleigenen Streuintensitätsfunktion

Der Zusammenhang zwischen der kristalleigenen wintensitätsfunktion und den Verteilungsfunktios $S(\lambda)$ und K(d) soll schrittweise abgeleitet werden, en vorläufig angenommen wird, daß K(d) durch Deltafunktion $\delta(d-\bar{d})$ nach Gl. (5) gegeben ist. Abschnitt VII wird diese einschränkende Vorausung dann fallengelassen.

Die Braggsche Gleichung $\lambda = 2\bar{d}\sin\Theta$ ordnet im Wert von λ einen Winkel Θ zu. Man kann Ansatz machen, daß das Wellenlängenintervall sich mit der Intensität proportional zu $S(\lambda) d\lambda$ das entsprechende Winkelintervall $d\Theta$ abbildet. so entstehenden Verteilungsfunktion überlagert noch der Lorentz-Polarisations-Faktor für Pulverschwen $LP(\Theta) = 1 + \cos^2 2\Theta$ Demit erhölt man

nahmen $LP(\Theta) = \frac{1 + \cos^2 2\Theta}{\sin 2\Theta \cdot \sin \Theta}$. Damit erhält man $1 = S(\lambda) \frac{d\lambda}{d\Theta} LP(\Theta)$. Da für eine gegebene Internz der konstante Faktor = 1 gesetzt werden kann, bt sich ([17])

$$S(\Theta) = S(\lambda) \frac{1 + \cos^2 2\Theta}{\sin^2 \Theta} \quad \text{mit} \quad \lambda = 2\bar{d} \sin \Theta. \quad (14)$$

muß geprüft werden, in wie weit die Winkel $M_{\rm ax}$ und $\Theta_{J,H}$ mit den Wellenlängen $\lambda_{\rm Max}$ bzw. λ_H der Braggschen Gleichung den richtigen Netzmenabstand \bar{d} ergeben.

Setzt man

$$S(\lambda) = \left[1 + \left(\frac{\lambda - \lambda_{\text{Max}}}{\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}}\right)^{2}\right]^{-1}$$
 (15)

und differenziert G. (14) nach Θ , so ergibt sich unter Verwendung von $\frac{d-\bar{d}}{\bar{d}} = -\frac{\lambda_{-} - \lambda_{\text{Max}}}{\lambda_{\text{Max}}}$ in erster Näherung

$$\lambda_{\text{Max}} = 2 \sin \Theta_{J, \text{Max}} \cdot \vec{d} \cdot \{1 - \varrho^2 \cdot \tau\};$$

$$\varrho = \frac{\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}}{\lambda_{\text{Max}}}; \quad \tau = \frac{2 \sin^4 \Theta - 1}{1 - 2 \sin^2 \Theta + 2 \sin^4 \Theta}.$$
(16)

Der winkelabhängige Faktor τ in der geschweiften Klammer ist im Rückstrahlbereich immer von der Größenordnung 1. Da $(\Delta \lambda_i/\lambda_{\rm Max})^2 \approx 4 \cdot 10^{-8}$, kann das Korrekturglied auch bei höchsten Genauigkeiten vernachlässigt werden.

Eine zu Gl. (16) analoge Beziehung folgt, wenn man Gl. (14) und (15) bis zu zweiten Potenzen in $\frac{\lambda - \lambda_{\text{Max}}}{\lambda_{\text{Max}}} \text{ und } (\Theta - \Theta_{J, \text{Max}}) \text{ entwickelt.}$

$$\lambda_{H} = 2 \cdot \sin \Theta_{J,H} \cdot \bar{d} \left\{ 1 - 2 \cdot \varrho^{2} \cdot \tau - \frac{1}{2} \varrho^{2} \operatorname{tg}^{2} \Theta \right\};$$

$$\varrho, \tau \text{ nach Gl. (16).}$$
(17)

Das erste Korrekturglied in der geschweiften Klammer ist wieder wie oben von der Größenordnung 10^{-7} bis 10^{-8} und läßt sich deswegen stets vernachlässigen. Das zweite Glied hat mit $(\Delta \lambda_b^i/\lambda_{\rm Max})^2 = 4 \cdot 10^{-8}$ erst bei $\theta = 86,4^\circ$ den Wert $5 \cdot 10^{-6}$ erreicht. Diese Korrektur, eine Folge der im Rückstrahlbereich stark winkelabhängigen Dispersion $\Delta \Theta/\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = {\rm tg}\,\Theta,$ ist demnach in den meisten Fällen ebenfalls ohne Bedeutung. In Gl. (16) und (17) ist die Asymmetrie von $S(\lambda)$ nicht berücksichtigt. Sie würde sich erst in höheren Näherungen bemerkbar machen und fällt somit nicht ins Gewicht.

Da also die Korrekturen bezüglich λ_{Max} und $\Theta_{J,\text{Max}}$ bzw. λ_H und $\Theta_{J,H}$ unerheblich sind, kann man folgern, daß die Funktion $J(\Theta)$, eventuell unter Ausschluß der Ausläufer, der "Schwänze", in erster Näherung folgender Gleichung genügt:

mit
$$J(\Theta) = S(\lambda)$$

$$\frac{\lambda - \lambda_{\text{Max}}}{\lambda_{\text{Max}}} = \cot g \, \Theta_{J, \, \text{Max}} \cdot (\Theta - \Theta_{J, \, \text{Max}}).$$
(18)

Der Vollständigkeit halber soll hier noch kurz auf Gitterkonstantenmessungen mit der Schwerpunktswellenlänge $\bar{\lambda}$ und dem Schwerpunkt $\bar{\Theta}_J$ von $J(\Theta)$ eingegangen werden. Lang [17] hat diesen Fall schon ausführlich behandelt. Entwickelt man Gl. (14) wieder

bis zu zweiten Potenzen in $\frac{\lambda - \lambda_{\text{Max}}}{\lambda_{\text{Max}}}$ und $(\Theta - \Theta_{J, \text{Max}})$

und bestimmt den Schwerpunkt $\overline{\Theta}_J$, so ergibt sich folgende korrigierte Braggsche Gleichung:

$$\vec{\lambda} = 2 \cdot \sin \overline{\Theta}_{J} \cdot \vec{d} \cdot \{1 - \overline{\alpha^{2}} \cdot \tau - \frac{3}{2} \overline{\alpha^{2}} \operatorname{tg}^{2} \Theta\};$$
mit
$$\tau \text{ nach Gl. (16)}$$

$$\alpha = \frac{\lambda - \lambda_{\text{Max}}}{\lambda_{\text{Max}}} \quad ; S_{\chi}(\alpha) = S(\lambda); \ \overline{\alpha^{2}} = \frac{\int S_{\chi}(\alpha) \alpha^{2} d\alpha}{\int S_{\chi}(\alpha) d\alpha}.$$
(19)

Für $S(\lambda)$ nach Gl. (15) ist $\overline{\alpha^2} = \infty$. Schneidet man aber die Enden dieser Verteilungsfunktion z.B. bei $|\lambda - \lambda_{\text{Max}}| = 5 \cdot \varDelta \, \lambda_{\underline{1}}$ ab, dann ist $\overline{\alpha^2} = 2,65 \, (\varDelta \, \lambda_{\underline{1}} / \lambda_{\text{Max}})^2$. Je nach dem, wie weit man bei Schwerpunktsmessungen die Schwänze noch erfaßt — in der darin liegenden Willkür liegt eine beträchtliche Meßunsicherheit — muß man mit kleineren oder größeren Werten für $\overline{\alpha^2}$ rechnen.

Man erkennt, daß trotzdem das erste Korrekturgleid i.a. wieder zu vernachlässigen ist. Setzt man etwa $\alpha^2=3\cdot(A\lambda_b/\lambda_{\rm Max})^2=12\cdot10^{-8}$, so hat das zweite Korrekturglied, das wie in Gl. (17) durch die winkelabhängige Dispersion bedingt ist, bei $\theta=82,3^\circ$ den Wert 10^{-5} erreicht und ist somit bei genauen Messungen im Rückstrahlbereich nicht zu vernachlässigen.

Nach [17] umgeht man aber die durch die winkelabhängige Dispersion verursachten Korrekturen in Gl. (17) und (19), indem man wie in Gl. (18) $J(\theta) = S(\lambda)$ setzt, wegen $\lambda = \mathrm{const} \cdot \sin \theta$ die Streuintensitäten nicht über θ sondern über $\sin \theta$ aufträgt und abweichend von den Definitionen in Gl. (2) und (4) den Schwerpunkt durch $\overline{\sin \theta}_J = \frac{\int J(\theta) \sin \theta \, d(\sin \theta)}{\int J(\theta) \, d(\sin \theta)}$ und die Mitte der Halbwertshöhe durch $(\sin \theta)_{J,H} = \frac{1}{2} [\sin \theta_J^* + \sin \theta_J^-]$ erklärt und mit diesen Werten in die Braggsche Gleichung geht.

VI. Asymmetrische Spektralfunktion und symmetrische Apparatefunktion

Auch in diesem Abschnitt sei noch daran festgehalten, daß die Kristallfunktion K(d) durch eine Deltafunktion $\delta(d-\bar{d})$ nach Gl. (5) gegeben ist und damit keinen verbreiternden Einfluß auf $J(\Theta)$ ausübt.

Für die Rechnungen wird die Spektralfunktion $S(\lambda)$ nach Gl. (7) zugrunde gelegt. Als Asymmetrieverhältnis soll $\nu=1,35$ gewählt werden, das nach Tabelle I ungefähr einem Mittelwert der beobachteten Asymmetrieverhältnisse von Cr-K bis Cu-K entspricht. Nach Gl. (18) kann dann die gleiche Funktion in erster Näherung für $J(\Theta)$ benützt werden.

$$S(\lambda) = J(\Theta) = j(x) = \left[1 + \left(\frac{x}{0.85}\right)^{2}\right]^{-1} \text{ für } x \leq 0$$

$$= \left[1 + \left(\frac{x}{1.15}\right)^{2}\right]^{-1} \text{ für } x \geq 0$$

$$\frac{\Theta - \Theta_{J,\text{Max}}}{\Delta \Theta_{J,\frac{1}{2}}} = x; \quad \Delta \Theta_{J,\frac{1}{2}} = \frac{\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}}{\lambda_{\text{Max}}} \cdot \text{tg } \Theta;$$

$$x_{j,\text{Max}} = 0, \quad x_{j,H} = 0.15, \quad \Delta x_{j,\frac{1}{2}} = 1$$

$$(20)$$

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit darf man annehmen, daß die (symmetrische) Apparatefunktion ihren Schwerpunkt in $\bar{\varepsilon}=0$ hat. Denn ist das nicht der Fall, so läßt sich mit $G(\varepsilon)=G(\bar{\varepsilon}+\eta)$ eine neue Variable η einführen. Die beobachtete Streuintensitätsverteilung

$$B(\Theta) = \int J(\Theta - \varepsilon) G(\varepsilon) d\varepsilon = \int J((\Theta - \overline{\varepsilon}) - \eta) G(\overline{\varepsilon} + \eta) d\eta$$

entsteht dann durch Faltung einer um $\overline{\epsilon}$ unverä er verschobenen Funktion $J(\Theta-\overline{\epsilon})$ mit einer zun $\mathbb C$ sprung der laufenden Koordinate η symmetri he Apparatefunktion. Bleibt bei der Faltung das $\mathbb C$ mum von $B(\Theta)$ an der gleichen Stelle wie das $\mathbb C$ mum von $J(\Theta-\overline{\epsilon})$, so ist Gl. (13) offenbar er $\mathbb C$ Verschiebt aber die zum Nullpunkt symmetrich Apparatefunktion das Maximum von $B(\Theta)$, seh deutet das eine Abweichung von Gl. (13), die gerade untersucht werden soll. Demnach genü von vorneherein, symmetrische Apparatefunkt zu betrachten, bei denen $\overline{\epsilon}=0$ ist.

Nachdem für $J(\Theta)$ in Gl. (20) eine auf dipweilige Halbweite bezogene, normierte Darsten gefunden ist, ist es zweckmäßig, auch $G(\varepsilon)$ und in entsprechend normierter Weise aufzustellen.

G(\varepsilon) = g(y) mit $y = arepsilon / \Delta \Theta_{J, \frac{1}{2}}$, und mit x und j(x) nach Gl. (20) wird $b(x) = \int j(x-y) g(y) dy.$

Als g(y) werden drei idealisierte Beispiele av nommen.

$$g_1(y) = 1$$
 für $|y| \le p$
= 0 für $|y| > p$
Rechteckfunktion, Halbweite = p

$$\begin{split} g_2(y) &= 1 - \frac{y^2}{q^2} \text{ für } |y| \leq q \\ &= 0 \qquad \text{ für } |y| > q \\ &= \text{Parabelfunktion, Halbweite} = \frac{1}{2} \sqrt{2} \, q \end{split}$$

$$\begin{split} g_3(y) &= 1 - \frac{y}{r} &\text{ für } \qquad 0 \leqq y \leqq r \\ &= 1 + \frac{y}{r} &\text{ für } - r \leqq y \leqq 0 \\ &= 0 &\text{ für } \quad |y| > r \\ &\text{ Dreiecksfunktion, Halbweite } = \frac{1}{2} \cdot r \end{split}$$

Die Parameter p, q, r sind ein Maß für die Ausenung der Apparatefunktionen, bezogen auf die weilige Halbweite $\varDelta \Theta_{J,\frac{1}{2}}$ von $J(\Theta)$. Mit diesen Futionen läßt sich das Faltungsintegral in Gl. elementar auswerten. Da die resultierenden Funktiob(x) unübersichtlich sind und die Bestimmung gesuchten Koordinaten $x_{b,\mathrm{Max}}, x_{b,H},$ und $\varDelta x_{b,\frac{1}{2}}$ durch "Punkt-für-Punkt-Ausrechnen" und Interption möglich ist, sei auf die zugehörigen Rechnunhier verzichtet.

Abb. 3a zeigt die Verschiebung des Maximu $x_{b,\,\mathrm{Max}}$ gegenüber dem Maximum $x_{j,\,\mathrm{Max}} = 0$ für die v schiedenen Formen von g(y) und für verschied! Parameter $p,\ q,\ r$. Nimmt man $\Delta \lambda_k/\lambda_{\mathrm{Max}} = 2\cdot 1$ was als Mittelwert für die hier interessierenden Eigstrahlungen gelten kann, dann läßt sich die Verschung mit $\Delta a/a = -2\cdot 10^{-4}\cdot x_{b,\,\mathrm{Max}}$ zugleich als Git konstantenfehlmessung angeben. Das ist an der On nate von Abb. 3a geschehen. Als Abszisse ist Halbweite $\Delta x_{b,\,\frac{1}{2}}$ von b(x) gewählt worden, da entsprechende Halbweite $\Delta \Theta_{B,\,\frac{1}{2}}$ von $B(\Theta)$ bei obj tiver Registrierung der Streuintensitäten (Zählro Photometer) der Messung leicht zugänglich ist. E Vergrößerung von $\Delta \Theta_{B,\,\frac{1}{2}}$ gegenüber einer aus Literat angaben berechneten, allein spektral bedingten Ha

weite $\frac{A\lambda_{i}}{\lambda_{\text{Max}}}$ tg Θ wird gelegentlich als Kriterium einen Einfluß der Apparatefunktionen auf das Interenzprofil von $B(\Theta)$ herangezogen. Abb. 3b zei

die als Beispiele gewählten Apparatefunktionen Abhängigkeit ihrer Halbweiten verbreiternd auf wirken.

Man erkennt in Abb. 3, daß schon relativ schmale paratefunktionen das Maximum $x_{b, \text{Max}}$ in merkher Weise verschieben, so daß Meßfehler $\Delta a/a$ der ößenordnung 10^{-5} entstehen können, wenn die lbweite $\Delta x_{b,\frac{1}{2}}$ (bzw. $\Delta \Theta_{B,\frac{1}{2}}$) erst wenige Prozent enüber der Halbweite $\Delta x_{j,\frac{1}{2}}$ (bzw. $\Delta \Theta_{J,\frac{1}{2}}$) ver-Bert ist. Abb. 3 kann selbstverständlich nur als halt dafür dienen, mit welchen Fehlmessungen man rechnen hat, da durch die Beschränkung der Rechng auf die drei idealisierten Apparatefunktionen in Wirklichkeit vorkommenden Verhältnisse sichernicht erschöpfend dargestellt werden und da die llytische Darstellung für j(x) in Gl. (20) für genauere ssagen nicht ausreicht. Deswegen wurde auch darverzichtet, die Kurven in Abb. 3 zu noch größeren lbweiten ∆ x_{b, ½} auszudehnen.

Da die Verschiebung des Maximums im Sinne einer metrisierung des Profiles von $B(\Theta)$ erfolgt, soll folgenden der einfachen Sprechweise halber von er "Verschmierung" der Asymmetrie gesprochen den.

Es ist nun bemerkenswert, daß bei den hier durchechneten Beispielen die Mitte der Halbwertshöhe a von b(x) nur sehr viel weniger von der Apparatektion g(y) beeinflußt wird als das Maximum $x_{b, \text{Max}}$. gefundenen Werte sind in Abb. 3 mit eingetragen. n erkennt, daß die Verschiebung von x_{hH} nur a 10% der Verschiebung von $x_{b, \text{Max}}$ beträgt, und ir weitgehend unabhängig von der Form für g(y). f die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für izisionsmessungen wird in Abschnitt X eingegangen. Nun ist allerdings leicht einzusehen, daß nicht ganze Fehler, der durch die verschmierende Wirng der Apparatefunktion erzeugt wird, sich im trapolationsergebnis wiederfindet. Die Halbweite $J_{J,\frac{1}{2}}$ von $J(\Theta)$ nimmt mit tg Θ zu, während die sdehnung von $G(\varepsilon)$ im Rückstrahlbereich vom nkel Θ nur schwach abhängt, u.U. näherungsweise stant ist. In der normierten Darstellung nach (21) bedeutet das, daß die Breite von g(y) mit gendem Winkel Θ abnimmt, d.h. nach Abb. 3 ist Meßfehler um so kleiner, je näher die Interferenz $\Theta = 90^{\circ}$ liegt, und bei der Extrapolation wird er enfalls teilweise eliminiert. Da aber Form und sdehnung der Apparatefunktionen bzw. deren Abgigkeit vom Winkel für die einzelnen Meßvortungen stark verschieden sein kann, ist eine Abätzung des verbleibenden Fehlers am Extrapolaisergebnis im allgemeinen nicht möglich.

Die Ergebnisse dieses Abschnittes beziehen sich ein Asymmetrieverhältnis $\nu=1,35$ und $\Delta \lambda_{3}/\lambda_{\rm Max}=$

 10^{-4} bzw. $\frac{\lambda_H - \lambda_{\text{Max}}}{\lambda_{\text{Max}}} = 3 \cdot 10^{-5}$. Diese Werte treffen

h Tabelle 1 ungefähr für Co-Kα-Strahlung zu. K-Strahlung hat eine geringere Asymmetrie, und Meßfehler Δa/a nach Abb. 3 werden entsprechend driger sein. Bei Fe-K-Strahlung hingegen, die das hste Asymmetrieverhältnis der für Gitterkonstanmessungen gebräuchlichen Eigenstrahlungen hat, 3 man mit Meßfehlern rechnen, die noch wesenthöher sein können, als Abb. 3 anzeigt.

Zum Schluß dieses Abschnittes sei ein Beispiel der Praxis angeführt. Beim fokussierenden Planfilm-Rückstrahl-Verfahren mit kreisförmiger Fokussierungsblende ist ein Abstand Film-Präparat von 60 mm und eine Fokussierungsblende mit 0,3 mm Durchmesser eine gebräuchliche Meßanordnung. Bei $\theta=80^\circ$ hat $J(\theta)$ eine Halbweite von $\approx 6\cdot 10^{-2}\,^\circ$, der etwa 0,12 mm auf dem Film entsprechen (Co-Ka-Strahlung). Einer runden Fokussierungsblende mit dem Radius 0,15 mm entspricht bei kleiner Primärstrahldivergenz näherungsweise eine halbkreisförmige Apparatefunktion mit gleichem Radius auf dem Film. Diese Halbkreisfunktion läßt sich etwa durch eine Parabelfunktion $g_{\bar{z}}(y)$ nach Gl. (23) mit $q\approx 1$ ersetzen. Dieser Ansatz gibt ein g(y), das jedenfalls nicht zu breit gewählt ist. Schließt man die Gitterkonstantenmessung an $\lambda_{\rm Max}$ und $\theta_{B,\,{\rm Max}}$ an, so zeigt Abb. 3 dafür

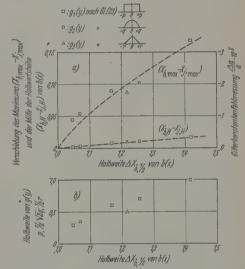


Abb. 3. Maximum, Mitte der Halbwertshöhe und Halbweite von b(x) nach Gl. (22) mit symmetrischen Funktionen g(y) und asymmetrischer Funktion j(x)

einen systematischen Fehler $\Delta a/a$ von etwa 2 · 10⁻⁵, der also wesentlich größer ist, als die in den neuesten Arbeiten angegebenen Fehlerbreiten.

VII. Einfluß der Kristallfunktion

Die Voraussetzung in Abschnitt V und VI — $K(d) = \delta (d - \bar{d})$ — wird bei Pulverpräparaten häufig nicht in ausreichendem Maße zutreffen. Man muß mit einer endlichen Breite von K(d) rechnen, und $J(\Theta)$ wird entsprechend der Braggschen Gleichung $\lambda/d = 2 \cdot \sin \Theta$ von der Häufigkeitsverteilung für das Verhältnis λ/d und damit vom Zusammenwirken von $S(\lambda)$ und K(d) bestimmt.

Aus rein formalen Gründen ist es zweckmäßig, die von Null verschiedene Breite von K(d) aus dem Rechengang zu eliminieren, indem man mit der Gleichung $\lambda/d=\lambda^*/\bar{d}$ eine neue Variable λ^* einführt. Die gesuchte Häufigkeitsverteilung für λ/d wird dann zu einer Häufigkeitsverteilung für λ^* , die mit $U(\lambda^*)$ bezeichnet werden soll. $U(\lambda^*)$ kann man als eine an die Unvollkommenheit des Kristallgitters "angepaßte Spektralverteilungsfunktion" auffassen, deren Benützung an Stelle von $S(\lambda)$ bewirkt, daß man bei der Darstellung von $J(\Theta)$ in Abschnitt V wieder mit $K(d)=\delta(d-\bar{d})$ rechnen kann.

Führt man für λ , λ^* und d reduzierte Koordinaten ein, die auf die jeweilige Halbweite $\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}$ von $S(\lambda)$ normiert sind,

$$\begin{split} &\lambda = \lambda_{\text{Max}}(1+w\cdot\varrho), \quad \lambda^* = \lambda_{\text{Max}}(1+x\cdot\varrho), \\ &d - \bar{d}(1+y\cdot\varrho); \quad \varrho = \frac{A\lambda_{\frac{1}{2}}}{\lambda_{\text{Max}}} \end{split}$$

und sind $S(\lambda) = s(w)$, $U(\lambda^*) = u(x)$, K(d) = k(y) die auf die neuen Variablen transformierten Verteilungsfunktionen, dann läßt sich in allen bei Präzisionsmessungen vorkommenden Fällen wegen des eng begrenzten Bereiches, in dem $k(y) \neq 0$ ist, in völlig ausreichender Näherung schreiben:

$$egin{aligned} rac{\lambda}{d} &= rac{\lambda_{ ext{Max}}(1+w\cdotarrho)}{\overline{d}(1+y\cdotarrho)} = rac{\lambda_{ ext{Max}}}{\overline{d}}\left(1+(w-y)\,arrho
ight) \ &= rac{\lambda^*}{\overline{d}} = rac{\lambda_{ ext{Max}}}{\overline{d}}\left(1+x\cdotarrho
ight); \qquad x=w-y \end{aligned}$$

und die gesuchte Häufigkeitsverteilung ergibt sich zu

$$U(\lambda^*) = u(x) = \int s(w) k(y) dy$$

$$= \int s(x+y) k(y) dy \text{ wegen } w = x+y.$$
(24)

Ist $K(d) = \delta(d - \bar{d})$ bzw. $k(y) = \delta(y)$, dann folgt aus der Gleichung:

$$U(\lambda^*) = u(x) = s(x) = S(\lambda),$$

und an den Ergebnissen in Abschnitt V und VI ändert sich nichts. Läßt man dagegen $K(d) + \delta (d - \bar{d})$ zu, dann muß in diesen Abschnitten statt $S(\lambda)$ die modifizierte Funktion $U(\lambda^*)$ eingesetzt werden. Die Auswirkungen sind leicht zu übersehen.

Gl. (22) und (24) sind formal identisch (das andere Vorzeichen der Integrationsvariablen im ersten Faktordes Integranden ist belanglos), und die in Abschnitt VI gewonnenen und in Abb. 3 zusammengefaßten Beziehungen zwischen $x_{b,\,\mathrm{Max}},\ x_{b,\,\mathrm{H}},\ \Delta\,x_{b,\,\frac{1}{2}}$ einerseits und $x_{j,\,\mathrm{Max}},\ x_{j,\,\mathrm{H}},\ \Delta\,x_{j,\,\frac{1}{2}}$ andererseits in Abhängigkeit von Form und Halbweite von $g\left(y\right)$ gelten nach Austausch der Variablen auch für die entsprechenden Beziehungen zwischen $x_{d,\,\mathrm{Max}}$ usw. und $x_{s,\,\mathrm{Max}}$ usw. in Abhängigkeit von Form und Halbweite von $k\left(y\right)$.

Für Abschnitt V ergeben sich daraus einige Veränderungen: Auf den rechten Seiten der Gl. (16), (17), (19) ist $(\Delta \lambda_b/\lambda_{\text{Max}})^2$ durch $(\Delta \lambda_b^*/\lambda_{\text{Max}}^*)^2$ zu ersetzen, und die Korrekturglieder in den geschweiften Klammern können wegen $\Delta x_{u, \frac{1}{2}} > \Delta x_{s, \frac{1}{2}}$ bzw. $\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}^* > \Delta \lambda_{\frac{1}{2}}$ entsprechend größer werden. Schaltet man aber den Einfluß der winkelabhängigen Dispersion, wie in Abschnitt V erwähnt, durch Auftragen der Streuintensitäten über $\sin \Theta$ aus, dann bleiben die Korrekturen in allen drei Gleichungen selbst dann noch zu vernachlässigen, wenn $\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}^* = 4 \Delta \lambda_{\frac{1}{2}}$ ist. (Bei Interferenzen, die noch stärker durch die Kristallfunktion verbreitert sind, werden kaum noch Präzisionsmessungen mit Genauigkeiten $\Delta a/a$ um 10^{-5} angestrebt werden.) Und man kann wie in Gl. (18) wieder in erster Näherung setzen

$$J(\Theta) = U(\lambda^*) \text{ mit } rac{\lambda^* - \lambda^*_{ ext{Max}}}{\lambda^*_{ ext{Max}}} = \operatorname{cotg} \Theta_{J, ext{Max}}(\Theta - \Theta_{J, ext{Max}}).$$

Auf den linken Seiten von Gl. (16) und (17) stehen jetzt die gegenüber λ_{Max} und λ_H verschobenen Werte λ_{Max}^* und λ_H^* . Nach Abschnitt VI kann man dabei wieder annehmen, daß $(x_{u,\,\text{Max}}-x_{s,\,\text{Max}})$ bzw. $(\lambda_{\text{Max}}^*-\lambda_{\text{Max}})$ wesentlich größer ist als $(x_{u,\,H}-x_{s,\,H})$ bzw. $(\lambda_H^*-\lambda_H)$

und man erhält systematische Gitterkonstanten messungen, die diesen Differenzen entsprechen. Gl. (19) ändert sich auf der linken Seite nichts wegen $\bar{y}_k = 0$ und Gl. (6) gilt: $\bar{x}_u = \bar{x}_s$, $\bar{\lambda}^* = \lambda$.)

Bezüglich der beobachteten Streuintensitätsfriton $B(\theta)$ hat man demnach mit zwei Verschrungseffekten zu rechnen: Die asymmetrische Funk $S(\lambda)$ wird durch K(d) zu einer verbreiterten und scheher asymmetrischen Funktion $U(\lambda^*)$ verschmaus $U(\lambda^*)$ geht durch Koordinatentransformation Funktion $J(\theta)$ hervor, und bei der Faltung von mit $J(\theta)$ entsteht eine nochmals verbreiterte noch schwächer asymmetrische Funktion $B(\theta)$, erst der Beobachtung zugänglich ist.

Da, wie in Abschnitt II erwähnt, K(d) im Ristahlbereich nur völlig untergeordnet vom Winksabhängt, da andererseits durch K(d) bereits die Fution $J(\theta)$ verschmiert wird — also die Streuinte tätsfunktion, auf die die unvollkommene Appar geometrie noch gar nicht eingewirkt hat — läßt die durch K(d) verursachte Fehlmessung $\Delta a | a$ wedurch Verbesserung der Meßanordnung noch du Extrapolation mildern, im Gegensatz zu den Fmessungen, die die endliche Ausdehnung von übewirkt. Bei Relativmessungen, bei denen die Apratebedingungen für die einzelnen Messungen konstgehalten werden, ist das zu beachten, wenn die vergleichenden Präparate merklich unterschiedligkristallfunktionen haben.

VIII, Symmetrische Spektralfunktion und asymmetris-Apparatefunktion

Bis jetzt wurde der verschmierende Einfluß Funktionen $G(\varepsilon)$ und K(d) auf die Asymmetrie beobachteten Streuintensitätsfunktion $B(\theta)$ dis tiert. Grundsätzlich tritt natürlich der gleiche Effauf, wenn $G(\varepsilon)$ oder K(d) ihrerseits asymmetrisind. Ist diese Asymmetrie stark und haben Funktionen obendrein eine genügende Breite, da wird eventuell gegen die in Abschnitt IV unter 2. ageführten Voraussetzungen verstoßen, und die Asymetrie von $G(\varepsilon)$ oder K(d) bewirkt eine nur schwübersehbare Verschiebung des Maximums von $B(\varepsilon)$

Um diese Verschiebung abschätzen zu könnt soll ein sehr vereinfachtes Modell durchgerecht werden. Die Funktion $J(\Theta)$ kann dabei als symmetrie angenommen werden, und ihre Halbweite soll alle durch die Spektralverteilung gegeben sein, K(d) $\delta(d-\bar{d})$. Mit der gleichen Bedeutung für x wie Gl. (20) ergibt sich der Ansatz

$$J(\Theta) = j(x) = [1 + x^2]^{-1}$$
.

Als Apparatefunktion soll die Funktion dienen, dei flachen Präparaten z.B. den Einfluß der Hozontaldivergenz des Strahlenbündels und unter istimmten experimentellen Bedingungen auch de Einfluß der Vertikaldivergenz beschreibt [13], [I: [18]].

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{y}} \quad \text{für} \quad 0 \le y \le 3\,\bar{y} \quad \text{mit} \quad \bar{y} = \text{Schwer-punkt von } g(y) \\ = 0 \quad \text{für} \quad y < 0; \quad y > 3\,\bar{y}.$$
 (2)

Die Koordinate y wird wieder nach Gl. (21) in Viefachen der Halbweite von $J(\Theta)$ gemessen.

Das Integral für $b(x) = \int j(x-y) g(y) dy$ ist g schlossen darstellbar, und die numerische Auswertur ot den in Abb. 4 gezeigten Zusammenhang zwin den Koordinaten \bar{y} , $x_{b,\,\mathrm{Max}}$, $x_{b,\,\bar{H}}$, $Ax_{b,\,\bar{q}}$. In Abb. 4 lie Differenz $\bar{y}-x_{b,\,\mathrm{Max}}$, die die hier interessierende eichung von Gl. (13) angibt, wieder unter der ahme von $A\lambda_b/\lambda_{\mathrm{Max}}=2\cdot 10^{-4}$ als Gitterkonstantenmessung Aa/a angegeben. Als Abszisse ist die artete Verschiebung \bar{y} des Maximums $x_{b,\,\mathrm{Max}}$ aufgeen. Man erkennt, daß für $\bar{y} \leq 0,3$ die Fehlmesgen Aa/a unter $5\cdot 10^{-6}$ bleiben, daß sie aber bei Beren \bar{y} dann steil ansteigen. Für $y \gtrsim 0,3$ ergibt mach auch eine symmetrische Funktion j(x) $(J(\Theta))$ der Faltung mit einer Funktion g(y) $(G(\varepsilon))$ nach (26) je nach Größe von \bar{y} eine mehr oder minder mmetrische Funktion b(x) $(B(\Theta))$, bei der Maxim und Schwerpunkt auseinanderfallen, denn wegen 0 und Gl. (6) ist $\bar{x}_b = \bar{y}$ jedenfalls erfüllt.

In Abb. 4a ist noch die Differenz $\bar{y}-x_{b,H}$ bzw. dazu äquivalente Gitterkonstantenfehlmessung getragen. Man sieht, daß ganz analog zu den gebnissen in Abschnitt VI, Abb. 3, die Verschieg der Mitte der Halbwertshöhe sehr viel genauer die des Maximums mit der erwarteten Verschieg \bar{y} übereinstimmt.

Wie in Abschnitt VI ist zu prüfen, ob eine Fehlssung als Folge einer asymmetrischen Apparatektion das Extrapolationsergebnis beeinflußt. Seien (ε) diejenigen Apparatefunktionen nach AbschnittII stark asymmetrisch sind (z.B. diejenigen für rizontal- und Vertikaldivergenz, Präparatabsorph), und seien $\bar{\varepsilon}_{\alpha i}$ die zugehörigen Schwerpunkte, in sind die Fehlmessungen $\Delta a | a$ als Folge der weichung von $\Theta_{B, \text{Max}} = \Theta_{J, \text{Max}} + \bar{\varepsilon}_{\alpha i}$ gesondert für einzelnen $\bar{\varepsilon}_{\alpha i}$ abzuschätzen und zu addieren. Die nme der einzelnen Fehlmessungen, die mit $\alpha \sum \Delta a | a$

eichnet sei, wird dann entsprechend Abschnitt VI ih gemildert durch den verschmierenden Einfluß übrigen, symmetrischen Apparatefunktionen wie liche Brennfleckausdehnung, Rundblende usw. In erkennt daraus, daß es sehr schwierig ist, auch grobe Abschätzungen über die schließlich für einzelne Interferenz resultierende Fehlmessung erhalten. Nun gehen aber die $\bar{\varepsilon}_{\alpha i}$ im Rückstrahl-

eich etwa mit $\left(\frac{\pi}{2} - \Theta\right)$ gegen Null. (Für die Veraldivergenz gilt das nicht immer, s. weiter unten.) andererseits die Halbweite $\varDelta\Theta_{J,\frac{1}{2}}$ von $J(\Theta)$ portional zu tg Θ ist — im Rückstrahlbereich $\left(\frac{\pi}{2} - \Theta\right)^{-1}$ — ergibt sich, daß die $\overline{y}_{\alpha i} = \frac{\overline{\varepsilon}_{\alpha i}}{\varDelta\Theta_{J,\frac{1}{2}}}$ mit

 $(-\theta)^2$ gegen Null gehen. Durch entsprechende nensionierung des Präparates und der Blendenmetrie kann man es deswegen stets erreichen, für die letzte Interferenz die oben erklärte Summe $\Delta a/a$ hinreichend klein ist. Der an der letzten

erferenz erhaltene Meßwert ist aber wesentlich timmend für das Extrapolationsergebnis. Für die igen Interferenzen mit Glanzwinkeln $\Theta \lesssim 70^\circ$ wird sich häufig nicht vermeiden lassen, daß die Asymtrie einzelner Apparatefunktionen zu schwer konlierbaren systematischen Fehlern führt. Dadurch daber allenfalls die Neigung der Extrapolationsaden verfälscht. Die Fehlmessungen kommen also in stark abgeschwächtem Maße im Extrapolationsebnis zur Wirkung.

Ein Sonderstellung nimmt die Vertikaldivergenz ein, deren Apparatefunktion in der auf $\Delta \Theta_{J,\frac{1}{2}}$ bezogenen, normierten Darstellung angenähert durch Gl. (26) gegeben ist [18]. Insbesondere bei Messungen mit dem Zählrohrgoniometer, aber auch bei photographischer Registrierung mit schlitzförmiger Eintrittsblende oder Photometerspalt als Empfangsblende wächst die zugehörige Schwerpunktskoordinate $\bar{\epsilon}_{\nu}$ etwa proportional mit cotg $2\,\Theta$ an, wenn Θ gegen 90° geht. Wegen $\cot 2\,\Theta \approx \frac{1}{2}\, tg\,\Theta$ im Rückstrahlbereich und $\Delta \Theta_{J,\frac{1}{2}}$ prop. $tg\,\Theta$ ist in diesen Fällen der normierte Schwerpunkt angenähert konstant. Mit $\Delta u/a = -\cot g\,\Theta \cdot \bar{\epsilon}_{\nu}$ gibt die Vertikaldivergenz eine Gitterkonstantenfehlmessung prop. $\cot g\,\Theta \cdot \cot g\,2\,\Theta = \frac{1}{2}\,(\cot g^2\,\Theta - 1)$ [19], [20]. Der kleinere, mit $\cot g^2\,\Theta$

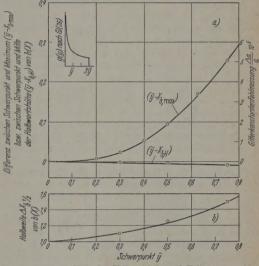


Abb. 4. Maximum, Mitte der Halbwertshöhe und Halbweite von b(x) nach Gl. (22) mit asymmetrischer Funktion j(x)

gehende Anteil der Fehlmessung wird bei der Extrapolation über eine der üblichen Funktionen — z.B. $\cos^2\Theta$ — hinreichend eliminiert, während der konstante Anteil aus der Apparategeometrie entnommen und extrakorrigiert werden muß. Diese Extrakorrektur ist natürlich um so unsicherer, je größer sie ist. Sie wird noch unsicherer, wenn \bar{y}_{ν} entsprechend Abb. 4 nicht ausreichend klein gegen 1 ist. Bei Präzisionsmessungen wird man allerdings ohne Schwierigkeiten durch hinreichend enge Sollerschlitze oder niedrige Eintrittsspaltblenden oder Photometerspalte diese zusätzliche Unsicherheit vermeiden können.

IX. Überlappung der α_1 - α_2 -Komponenten

Bei den bisherigen Überlegungen war außer acht gelassen, daß die Überlagerung der beiden eng benachbarten α_1 - α_2 -Komponenten einer Interferenz zu Verschiebungen des Maximums bzw. der Mitte der Halbwertshöhe der $B(\Theta)$ -Funktionen der einzelnen Komponenten führt. Grundsätzlich bleibt in diesen Fällen die Möglichkeit, durch Separierung des Dublettes die beiden Komponenten getrennt zu erhalten. Dafür sind in der Literatur mehrere Verfahren angegeben, die aber alle einengende Voraussetzungen bezüglich der $B(\Theta)$ -Funktionen der beiden Komponenten machen müssen, s. z. B. [21].

Um die Auswirkung mangelnder Dubletteauflösung auf die Lage des Maximums und der Mitte der Halbwertshöhe analytisch abschätzen zu können, soll die durch Überlagerung der $B(\Theta)$ -Funktionen entstehende

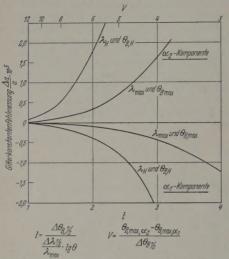


Abb. 5. Gitterkonstantenfehlmessung Aa/a als Folge der Überlappung der α_{1} - α_{2} -Komponenten für den Fall, daß in die Braggsche Gleichung die Wellenlapen $\lambda_{\rm Max}$ oder $\lambda_{\rm H}$ und die ohne Separierung der Komponenten gemessenen Winkel $\Theta_{B,\,\rm Max}$ oder $\Theta_{B,\,\rm H}$ eingesetzt werden

Streuintensitätsfunktion des Dublettes durch folgenden Ansatz dargestellt werden:

$$D_{1}(z) = b(z) + \frac{1}{2}b(z - v),$$

$$\text{wenn } b(z) \text{ die } \alpha_{1}\text{-Komponente ist.}$$

$$D_{2}(z) = b(z) + 2 \cdot b(z + v),$$

$$\text{wenn } b(z) \text{ die } \alpha_{2}\text{-Komponente ist.}$$

$$z = \frac{\Theta - \Theta_{B, \text{Max}}}{A\Theta_{B, \frac{1}{2}}}, \quad b(z) = [1 + z^{2}]^{-1},$$

$$v = \frac{\Theta_{B, \text{Max}, \alpha_{3}} - \Theta_{B, \text{Max}, \alpha_{4}}}{A\Theta_{B, \frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{\lambda_{\text{Max}, \alpha_{2}} - \lambda_{\text{Max}, \alpha_{4}}}{A\Lambda_{\frac{1}{2}}} \cdot t = \frac{A\Theta_{B, \frac{1}{2}}}{\frac{1}{\lambda_{\text{Max}}}} \cdot tg\Theta$$

Dabei ist vernachlässigt: die winkelabhängige Dispersion im Rückstrahlbereich, wodurch die Halbweite der α_2 -Komponente größer als die der α_1 -Komponente wird; Abweichung der b(z)-Funktion von obiger Darstellung, insbesondere eine mögliche Asymmetrie; Unterschiede zwischen den b(z)-Funktionen der beiden Komponenten.

v ist ein Maß für die Dubletteauflösung. Der Hilfsparameter t, ein Faktor ≥ 1 , gibt an, um wieviel die Halbweite von $B(\Theta)$ durch die verbreiternde Wirkung der Funktionen K(d) und $G(\varepsilon)$ gegenüber der allein spektral bedingten Halbweite vergrößert ist.

Von D(z) interessieren die Größen z_{Max} und z_H . Die Rechnung ergibt, daß in dem in Abb. 5 gezeichneten Bereich eine erste Näherung der zugehörigen Bestimmungsgleichungen ausreicht. Nach einigen elementaren Entwickelungen erhält man:

für
$$D_1(z)$$
: $z_{D\,1,\,\mathrm{Max}}=rac{v}{2(v^2+1)^2+1}\,, \ z_{D\,1,\,H}=rac{2\,v}{(v^2+1)^2-4\,v^2}$

$$\begin{array}{ll} \text{für } D_2(\!z\!)\!: & z_{D\,2,\,\text{Max}}\!=\!\frac{-\,2\,v}{(v^2+1)^2+2}\;,\\ \\ z_{D2,\,\!H}\!=\!\frac{-\,8\,v}{(v^2-2)^2-4\,v^2} \end{array}$$

Mit $v \cdot t = 12$ nach Gl. (27) und $\Delta \lambda_{\parallel} / \lambda_{\text{Max}} = 2 \cdot 1$ beides entspricht ungefähr einem Mittelwert für K- α -Strahlungen von Cr bis Cu, ergibt der Ausd $z \cdot t \cdot \frac{\Delta \lambda_{\parallel}}{2}$ eine den Verschiebungen entspreche

Gitterkonstantenfehlmessung $\Delta a/a$, wenn man fürentweder $z_{\rm Max}$ oder z_H einsetzt. Man erkennt in Abldaß Maximum und Mitte der Halbwertshöhe α_2 -Komponente etwa viermal störungsempfindlic sind als die entsprechenden Werte der α_1 -Kompone. Erhält man also bei mangelnder Dubletteauflös an den beiden Komponenten verschiedene Gitterk stanten, so muß ein im Verhältnis 4:1 gewichte Mittelwert gebildet werden. Dabei ist allerdings vachlässigt, daß nach Tabelle I die α_1 - und α_2 -Koponenten der Eigenstrahlungen zum Teil erhebi verschiedene Asymmetrieverhältnisse haben. I wiederum bewirkt nach Abschnitt VI und VII um schiedliche Verschiebungen des Maximums der beide Komponenten, die nur schwer auszumitteln sind.

Abb. 5 zeigt ferner, daß die Mitte der Halbweiniste etwa vier- bis fünfmal stärker verschoben wals das Maximum. Man beobachtet also schon kleinen Werten t (bzw. großen Werten v) selbst da scheinbar asymmetrische $B(\Theta)$ -Funktionen, wenn separierten Komponenten symmetrisch sind.

X. Gitterkonstantenmessungen im Anschluß an die M der Halbwertshöhe

In den vorangegangenen Abschnitten wurde imr neben dem Maximum das Verhalten der Mitte Halbwertshöhe verfolgt. Es ergab sich dabei, daß versehmierende Wirkung der Apparatefunktion und der Kristallfunktion K(d) auf die Asymme der beobachteten Streuintensitätsfunktion $B(\Theta)$ ein seits und die unerwünschte Profiländerung von B durch stark asymmetrische $G(\varepsilon)$ andererseits Maximum $\Theta_{B, \text{Max}}$ etwa zehnmal stärker verschie als die Mitte der Halbwertshöhe $\Theta_{B,H}$. Es ist deswe zu untersuchen, ob nicht die Schwierigkeiten Präzisionsmessungen, die von der Asymmetrie beteiligten Funktionen herrühren, dadurch weitgehe zu vermeiden sind, daß man die Gitterkonstant messungen nicht wie üblich an das Maximum A und $\Theta_{B, \text{Max}}$, sondern an die Mitte der Halbwertsh λ_H und $\Theta_{B,\,H}$ anschließt¹. Diese Meßmethode erford allerdings eine objektive Registrierung der In ferenzen, die aber bei höchsten Genauigkeitsanfor rungen einer visuellen Filmvermessung vorzuzie ist (s. auch Abschnitt XII).

Neben dem eben erwähnten Vorteil besteht a ein nicht unerheblicher Nachteil darin, daß n Abschnitt IX eine mangelnde Dubletteauflösung α_1 - α_2 -Komponenten die Mitte der Halbwertshöhe et vier- bis fünfmal stärker verschiebt als das Maximu Bei Interferenzen mit $\theta \lesssim 70^\circ$, die zur Bestimmt der Extrapolationsgeraden benötigt werden, w selbst bei guten Präparaten die Dubletteauflösung allgemeinen nicht soweit gelingen, daß bei Messun im Anschluß an die Mitte der Halbwertshöhe keiner verschaften der Schaft verschaft auch daß bei Messun im Anschluß an die Mitte der Halbwertshöhe keiner verschaft verschaft verschaft auch daß bei Messun im Anschluß an die Mitte der Halbwertshöhe keiner verschaft vers

¹ z. B. [23] hat dieses Verfahren schon angewandt.

lichen Fehler entstehen, deren Auswirkung auf xtrapolationsergebnis wieder wie in Abschnitt VI VIII schwer abzuschätzen ist. Bei Präparaten rheblichen inneren Spannungen oder Teilchennverbreiterungen, die auch bei den letzten Interzen schlechte Dubletteauflösungen ergeben, bringt essung mit λ_H und $\Theta_{B,H}$ jedenfalls keinen Vorteil. ei guten Präparaten hingegen besteht eine Mögeit, durch Messung der Mitte der Halbwertshöhe erschmierende Wirkung der Apparate- und der allfunktionen zu kontrollieren und damit das aß der dadurch verursachten Fehlmessung abätzen. Sind die a1-a2-Komponenten der letzten ferenzen soweit aufgelöst, daß nach Gl. (27) die etteauflösung $v \geq 6$ ist, dann verändert die Überng der beiden Komponenten nach Abb. 5 zuest das Profil der α₁-Komponente — abgesehen len Ausläufern — noch nicht merklich. Eine an · Komponente gemessene Asymmetrie, gekennnet durch $\frac{\sin \Theta_{B,H} - \sin \Theta_{B,Max}}{\cos \Theta_{B,Max}}$ sollte im günstig-

net durch $\frac{\partial_{B,H} - \partial_{B,\max}}{\sin \Theta_{B,\max}}$ sollte im günstig-Fall mit der Asymmetrie $\frac{\lambda_H - \lambda_{\max}}{\lambda_{\max}}$ der Eigen-

A_{Max}
lung nach Tabelle I übereinstimmen. Besteht
hen beiden Ausdrücken eine Differenz, die die
herheit der in Tabelle I aufgeführten Werte über1, so verweist das auf Verschmierungen durch die
rate- und die Kristallfunktion, die von der Extraionsmethode gar nicht oder nur mangelhaft erwerden. Nimmt man in erster Näherung an,
die Verschmierung nur das Maximum, nicht dadie Mitte der Halbwertshöhe verändert, wofür
dregebnisse in Abschnitt VI und VIII Anhaltste geben, dann gibt die Differenz

$$\frac{\varDelta a}{a} = \frac{\sin\Theta_{B,\,H} - \sin\Theta_{B,\,\mathrm{Max}}}{\sin\Theta_{B,\,\mathrm{Max}}} - \frac{\lambda_{H} - \lambda_{\mathrm{Max}}}{\lambda_{\mathrm{Max}}} \quad (28)$$

en α_1 -Komponenten der letzten, gut aufgelösten ferenzen ein ungefähres Maß für einen systematen Fehler im Extrapolationsergebnis, der nach le 1 und Abschnitt VI insbesondere bei Fe-K-Co-K mehrere 10^{-5} betragen kann.

a extremen Rückstrahlbereich $\theta \gtrsim 85^{\circ}$ besteht (28) eine Schwierigkeit in der Bestimmung von $B_{B,H}$. Dort muß auch bei guten Präparaten ($\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}^{*} \approx 1$ nach Abschnitt VII) die winkelabhängige Dism beachtet werden. Man muß dann entweder Gl. (17) und Abschnitt VII diesen Einfluß gieren, indem man in Gl. (28) sin $\theta_{B,H}$ durch $B_{B,H} \times (1 - \frac{1}{2}(\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}^{*}/\lambda_{\text{Max}}^{*})^2 \operatorname{tg}^2 \theta)$ ersetzt (wobei $\Delta \lambda_{\frac{1}{2}}^{*}$ chätzt werden muß), oder wie in Abschnitt III von Gl. (4) abweichende Definition

$$(\sin \Theta)_{B,H} = \frac{1}{2} \left[\sin \Theta_B^+ + \sin \Theta_H^- \right] \tag{29}$$

nden. Letztere Möglichkeit gilt streng nur für ristalleigene Streuintensitätsfunktion $J(\Theta)$. Es sich aber zeigen, — was hier aus Platzgründen bleiben soll — daß Gl. (29), die sich auf die achtete Streuintensitätsfunktion $B(\Theta)$ bezieht, lenklich benützt werden kann, solange die ratefunktion $G(\varepsilon)$ nur schwach verbreiternd auf wirkt.

Bei einer Abschätzung der Genauigkeiten dieser Werte ist chten, daß bei Untersuchungen am Doppelspektrometer dieser Arbeit behandelten Funktionen in einer zum Teil komplizierteren Weise miteinander verflochten sind, als Gitterkonstantenmessungen gilt, siehe z. B. [5].

XI. Gleichzeitige Verwendung mehrerer Eigenstrahlungen

Gitterkonstantenmessungen unter Verwendung nur einer Eigenstrahlung können bezüglich des Verhältnisses $\bar{a}/\lambda_{\rm Max}$ je nach Meßaufwand zu hohen Genauigkeiten führen. Insbesondere zu Vergleichszwecken ist aber diese Angabe oft ausreichend, so daß die begrenzte Genauigkeit, mit der die Wellenlänge \(\lambda_{\text{Max}} \) etwa im kX- oder Ångström-Maßstab bekannt ist, im Meßergebnis gar nicht erscheint. Wendet man die Extrapolationsmethode auf Interferenzen an, die von verschiedenen Eigenstrahlungen herrühren (Legierungsantikathoden, Mehrfachbelichtung des Filmes mit verschiedenen Antikathoden, Verwendung von α- und β-Strahlungen), so wird die Genauigkeit des Extrapolationsergebnisses grundsätzlich von der Relativgenauigkeit der benützten Wellenlängen unter sich begrenzt. Während z.B. die Messungen von verschiedenen Autoren an Cu-Kα nur um etwa 7 · 10⁻⁶ von einander abweichen, sind die Werte insbesondere für Cr-K wesentlich unsicherer (s. z. B. [22], [8]).

Abgesehen von diesem grundsätzlichen Nachteil führt die gleichzeitige Verwendung verschiedener Strahlungen zur dichteren Belegung der Extrapolationsgeraden sicherlich dann zu falschen Ergebnissen, wenn die Apparatefunktion, die den Einfluß der Präparatabsorption enthält für die einzelnen Strahlungen merklich verschiedene Schwerpunktsverschiebungen $\bar{\epsilon}_i$ bewirkt. Die Interferenzen der einzelnen Strahlungen erfordern dann jeweils eigene Extrapolationsgeraden. Das dürfte vor allem bei leichten Substanzen mit geringer Absorption der Fall sein.

Bei schweren, dicht gepackten Substanzen, bei denen der Absorptionseinfluß oft zu vernachlässigen ist, bei denen aber die Brechungskorrektur wesentlich größer als die angestrebte Meßgenauigkeit sein kann, müssen die an den einzelnen Interferenzen gemessenen Gitterkonstanten bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer Strahlungen jedenfalls vor der Extrapolation bezüglich der Brechung korrigiert werden. Da die Brechungskorrektur proportional mit λ^2 geht, können anderenfalls erhebliche Fehler entstehen. So beträgt z. B. (bei $\Theta = 90^{\circ}$) die Korrektur für Gold mit Cu-K α : $\Delta a/a = 5 \cdot 10^{-5}$, mit Cr-K α : $\Delta a/a = 11 \cdot 10^{-5}$. Bei Pulverpräparaten ist aber eine Brechungskorrektur für Interferenzen mit $\Theta < 90^{\circ}$ um so unsicherer, je weiter Θ von 90° entfernt ist [25], [26]. Deshalb ist die Lage der Extrapolationsgeraden bei einer Korrektur der gemessenen Gitterkonstanten vor der Extrapolation mit einem schwer abschätzbaren Fehler belastet. Bei Verwendung nur einer Strahlung hingegen korrigiert man nach [25] erst das Extrapolationsergebnis, da die Unsicherheit der Korrektur bei Winkeln $\Theta < 90^{\circ}$ mit der Extrapolation der gemessenen, unkorrigierten Gitterkonstanten über einer Funktion, die mit $\left(\frac{\pi}{2} - \Theta\right)^2$ gegen Null geht, weitgehend eliminiert wird.

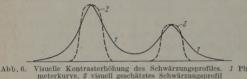
Es ergibt sich also, daß die Anwendung mehrerer Strahlungen zur dichteren Belegung der Extrapolationsgeraden bei höchsten Genauigkeitsanforderungen im allgemeinen keinen Vorteil bringt.

XII. Visuelle Filmvermessung

Bei photographischen Meßverfahren werden die Glanzwinkel der einzelnen Interferenzen meist mit einem Komparator oder Meßuhrmaßstab vermessen.

Dann stellt eine mögliche Asymmetrie der beobachteten Streuintensitätsfunktion $B(\Theta)$ eine grundsätzliche Genauigkeitsgrenze dar. Denn es ist im einzelnen nicht bekannt, ob das subjektiv empfindende Auge die Meßmarke auf das Maximum, auf die Mitte der Halbwertshöhe oder auf den Schwerpunkt des Schwärzungsprofils oder auf einen irgendwie gearteten Mittelwert einstellt. Da das Auge die Kontraste zwischen dem "Kopf" und den "Füßen" von $B(\Theta)$ stark überhöht, Abb. 6, ist es naheliegend, daß man mit dem Auge einen Punkt zwischen Maximum und Mitte der Halbwertshöhe anvisiert, wobei vermutlich die Einstellung um so näher bei der Mitte der Halbwertshöhe liegt, je stärker der Film überbelichtet ist. Deswegen ist bei visueller Filmvermessung ein systematischer Fehler da/a etwa der Größenordnung $\lambda_H - \lambda_{\text{Max}}$ nach Tabelle 1 selbst dann zu erwarten, wenn

 λ_{Max} $G(\varepsilon)$ und K(d) keinen verbreiternden und verschmierenden Einfluß auf $B(\Theta)$ ausüben. In Wirklichkeit ist das aber immer der Fall. Dann wird entsprechend den Ergebnissen in Abschnitt VI und VII die Differenz zwischen Maximum und Mitte der Halbwertshöhe



von $B(\Theta)$ zwar gemildert, aber in der Weise, daß das Maximum verschoben wird, d.h. die Fehlmessung wird nur noch wahrscheinlicher.

Wegen $\lambda_H > \lambda_{ ext{Max}}$ oder $\Theta_{B,H} > \Theta_{B, ext{Max}}$ erhält man also bei visueller Filmvermessung bevorzugt zu kleine Gitterkonstanten. Inwieweit sich diese subjektiv bedingten systematischen Fehler, die zusätzlich zu den in Abschnitt VI bis VIII besprochenen auftreten, bei der Extrapolation eliminieren, ist nicht abzuschätzen, zumal die Einstellung der Meßmarke bezüglich des Maximums bzw. der Mitte der Halbwertshöhe möglicherweise von Person zu Person verschieden ist. Diese Fehler werden sich bei Relativmessungen allerdings dann weitgehend herausheben, wenn die verschiedenen Messungen in der gleichen Meßvorrichtung, an etwa gleich guten Präparaten und von der gleichen Person vorgenommen werden. (Bezüglich der statistischen Fehler bei visueller Filmvermessung s. z.B. [24].)

Zusammenţassung

Schließt man die Gitterkonstantenmessung an das Maximum der Spektralverteilungsfunktion und an das Maximum der beobachteten Streuintensitätsfunktion an und versucht man, eine Genauigkeit $\Delta a/a$ von 1 bis $2\cdot 10^{-5}$ zu erreichen, so erfordert die Asymmetrie der Spektralverteilungsfunktion eine sorgfältige Berücksichtigung des verbreiternd und damit verschmierend wirkenden Einflusses der Apparatefunktion und der Kristallfunktion.

Die systematischen Fehlmessungen, die die endliche Ausdehnung der Apparatefunktion verursacht, wird bei Anwendung der Extrapolationsmethode im allgemeinen teilweise eliminiert.

Eine endliche Ausdehnung der Kristallfunktion dagegen bewirkt einen Fehler, der bei der Extrapolation nicht ausgeschaltet wird. Es werden Beziehungen abgeleitet, die angen für Co-Kz-Strahlung gelten. Insbesondere I Strahlung ist für Präzisionsmessungen nicht geei

Unter günstigen Experimentalbedingungen It flußt eine mögliche Asymmetrie der Apparatefundas Maximum der beobachteten Streuintens funktion bei den letzten Interferenzen mit θ nur wenig. Für Interferenzen mit $\theta \lesssim 70^\circ$ is merklicher Einfluß zu erwarten, der aber im Epolationsergebnis nur abgeschwächt zur Winkommt.

Bei guten Präparaten mit hinreichender lösung der α₁-α₂-Komponenten erlaubt ein Verg der an den letzten Interferenzen gemessenen Ametrie mit den bekannten Literaturwerten eine schätzung des systematischen Fehlers, der durch Asymmetrie der Spektralfunktion, der Appafunktion oder der Kristallfunktion erzeugt wird

Bei höchsten Genauigkeitsanforderungen ist gleichzeitige Benützung verschiedener Eigens lungen nicht zu empfehlen, da die Wellenlänger unterschiedlicher Genauigkeit bekannt sind, die parate für die verschiedenen Strahlungen verschie Absorptionskoeffizienten haben und eine Brech korrektur für Winkel $\Theta < 90^\circ$ unsicher ist.

Bei visueller Filmvermessung stellt das Aug Meßmarke wahrscheinlich auf einen vom Belicht grad und von der Meßperson abhängenden W zwischen Maximum und Mitte der Halbwertshöh Schwärzungsprofiles ein. Dadurch mißt man je der Asymmetrie des Profiles bevorzugt zu k Gitterkonstantenwerte, wenn man das Maximum visieren will.

Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. R. GLOCKER und Herr E. Macherauch habe ich für zahlreiche Anregung danken.

Literatur: [1] SMAKULA, A., and J. KALNAJS: Phys. 99, 1737 (1955). — [2] STRAUMANIS, M. E., u. C. C. V. Acta crystallogr. 8, 367 (1955). — [3] WEYERER, H.: Z. a Phys. 8, 202, 297, 553 (1956). — [3a] GIESECKS, G. H. PFISTER: Acta crystallogr. 11, 369 (1958). — [4] BAIN, M.: Spektroskopie der Röntgenstrahlen. Berlin 19 [5] Frügge, S.: Handbuch der Physik, Bd. XXX. 1957. — [6] Allison, S. K.: Phys. Rev. 44, 63 (1937). — [6] Allison, S. K.: Phys. Rev. 44, 63 (1937). — [6] Allison, S. K.: Phys. Rev. 44, 63 (1937). — [7] PARRATT, L. G.: Phys. Rev. 50, 1 (1936). — [8] BEAJ. A., and C. H. SHAW: Phys. Rev. 48, 18 (1935). — [10] P. SON, M. S.: J. Appl. Phys. 23, 499 (1952). — [11] WAB. E., u. E. P. WAREKOIS: Acta metallurg. 3, 473 (1957). — [12] ALEXANDER, L.: J. Appl. Phys. 25, 155 (1956). — [13] WILSON, A. J. C., J. Sci. Instrum. 27, 321 (1956). — [14] TROST, A.: Z. angew. Phys. 7, 469 (1955). — [15] Kli and L. Alexander: X-Ray Diffraction Procedures. York 1954. — [16] TAYLOR, A., and H. SINCLAIR: Phys. Soc. Lond. 57, 108, 126 (1945). — [16a] NE J. B., and D. P. RILEY: Proc. Phys. Soc. Lond. 57 (1945). — [17] Lang, A. R.: J. Appl. Phys. 27, 485 (1951). BRADLEY, A. J., and A. H. JAY: Proc. Phys. Soc. 44, 563 (1932). — [20] Lipson, H., and A. J. C. Wi J. Sci. Instrum. 26, 423 (1955). — [22] BEARDEN, J. A.: Rev. 43, 92 (1933). — [23] NEFF, H.: Z. angew. Ph 505 (1956). — [24] ERSTEIN, H., u. S. SIEGEL: Acta cryste 2, 99 (1949). — [25] WILSON, A. J. C.: Proc. Cambridge Soc. 36, 485 (1940). — [26] Frohnmeyer, G., u. R. Glocal Carlos (1958).

Dr. Manfred Wilkens Röntgeninstitut der Technischen Hochsch und Institut für Metallphysik am Max-Planck-Institut für Metallforschu Stuttgart, Seestraße 71